DÜZLEMSEL İLETİM HATLARININ ELEKTRİKSEL PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİLTRE TASARIMI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Tezi <u>Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı</u>

Mehmet URHAN

Danışman : Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ

Temmuz, 2009 DENİZLİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU

Mehmet URHAN tarafından Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ yönetiminde hazırlanan **"Düzlemsel İletim Hatlarının Elektriksel Parametrelerinin Hesaplanması ve Bilgisayar Destekli Filtre Tasarımı"** başlıklı tez tarafımızdan okunmuş, kapsamı ve niteliği açısından bir yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Doç. Jüri Başkanı (Danışman)

Yrd. Doç. Dr. Sezai TOKAT Jüri Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet

Jüri Üyesi

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun 12/08/2009 tarih ve .18./.11... sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Prof. Dr. Halil KARAHAN Müdür

TEŞEKKÜR

Tez çalışmam süresince sağlamış olduğu özgür çalışma ortamı ile değerli bilgilerini ve desteğini hiçbir zaman benden esirgemeyen, tez danışmanım ve değerli hocam sayın Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca yüksek lisans ve lisans öğrenimimde derslerini almış olduğum çok değerli hocalarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum.

Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; bu çalışmanın doğrudan birincil ürünü olmayan bulguların, verilerin ve materyallerin bilimsel etiğe uygun olarak kaynak gösterildiğini ve alıntı yapılan çalışmalara atfedildiğini beyan ederim.

İmza

: Mttetwary

Öğrenci Adı Soyadı : Mehmet URHAN

ÖZET

DÜZLEMSEL İLETİM HATLARININ ELEKTRİKSEL PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİLTRE TASARIMI

Urhan, Mehmet

Yüksek Lisans Tezi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği A. B. D.

Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ

Temmuz 2009, 135 Sayfa

Bu çalışmada düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin hesaplanması ve mikrodalga filtre tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla "Quasi-Statik Analiz Metodu" ve "Araya Girme Kaybı Metodu" kullanılarak Visual C#.Net ve Borland Delphi tabanlı yeni bir görsel paket program hazırlanmıştır.

Bölüm 1'de ilk olarak konu ile ilgili kısa bir tarihçe verilmiştir ve düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin hesaplanması ve filtre tasarımı için mikrodalga literatüründeki mevcut metotlar ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Daha sonra bu metotlar içerisinden; yeni paket programın esaslarını oluşturmak için bir metot belirlenmiştir.

Bölüm 2'de düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin analizinde bir *Quasi-statik analiz* metodu olan *"Konform Dönüşüm Metodu"* kullanılarak yeni paket program için formülasyonlar toparlanmıştır.

Bölüm 3'de ilk olarak *Araya girme kaybı* metoduyla *Butterworth, Chebyshev* ve *Eliptik* karakteristikli frekans cevapları için prototip alçak geçiren filtre eleman değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra prototip alçak geçiren filtre eleman değerleri gerçek filtre eleman değerlerine dönüştürülmüştür.

Bölüm 4'de yeni paket program ayrıntılı bir biçimde tanıtılmıştır. Bölüm 5'de ise bu paket programın yazılım aşamasında kullanılan programlardan bahsedilmiştir. Son olarak Bölüm 6'da bu çalışmanın sonuçlarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düzlemsel İletim Hatları, Elektriksel Parametreler, Mikrodalga Filtre Tasarımı, Quasi-Statik Analiz Metodu, Araya Girme Kaybı Metodu.

Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ Yrd. Doç. Dr. Sezai TOKAT Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZEK

ABSTRACT

COMPUTING ELECTRICAL PARAMETERS OF PLANAR TRANSMISSION LINES AND COMPUTER-AIDED FILTER DESIGN

Urhan, Mehmet

M. Sc. Thesis in Electrical & Electronics Engineering

Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Ceyhun KARPUZ

July 2009, 135 Pages

In this study, microwave filter design and computing electrical parameters of planar transmission lines have been implemented. For this purpose, a new visual packet programme based on *Visual C#.Net* and *Borland Delphi* has been developed by using "*Quasi-Static Analysis Method*" and "*Insertion Loss Method*".

In Section 1, a short history of the subject has been presented, and, current methods in microwave literature for computing electrical parameters of planar transmission lines and filter design have been examined in detail, first. Then, a method is determined out of these methods in order to produce the principles of the new packet programme.

In Section 2, formulas have been formed for the new packet programme by using "Conformal Mapping Method", a Quasi-static analysis method to analyze the electrical parameters of planar transmission lines.

In Section 3, element values of lowpass prototype filter for frequency responces having *Butterworth, Chebyshev* and *Eliptic* characteristics have been computed by using *Insertion loss* method, first. Then element values of lowpass prototype filter have been transformed into element values of real filter.

In Section 4, the new packet programme is introduced in detail. In Section 5 programmes used in the process of software of this packet programme have been mentioned. Finally in Section 6, the results of this study have been discussed.

Keywords: Planar Transmission Lines, Electrical Parameters, Microwave Filter Design, Quasi-Static Analysis Method, Insertion Loss Method.

Assoc. Prof. Dr. Ceyhun KARPUZ Asst. Prof. Dr. Sezai TOKAT Asst. Prof. Dr. Ahmet ÖZEK

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
Yüksek Lisans Tezi Onay Formu	ii
Teşekkür	iii
Bilimsel Etik Sayfası	iv
Özet	V
Abstract	vi
İçindekiler	vii
Şekiller Dizini	ix
Tablolar Dizini	xii
Simge ve Kısaltmalar Dizini	xiii
	1
I. GIRIŞ	1
1.1 Mikrodalga Entegre Devreleri	
1.1.1 Tarihçe	l
1.2 Düzlemsel Iletim Hatları ve Mikrodalga Entegre Devreleri	4
1.3 Mikrodalga Filtreler	6
1.4 Düzlemsel İletim Hatlarının Quasi-Statik Analizine ve Filtre Tasarımına	
Yönelik Mevcut Bazı Programların İncelenmesi	7
1.4.1 Txline	7
1.4.2 Filter Design	8
1.4.3 Filter Free	9
1.5 Tezin Amacı ve Önemi	9
1.6 Materyal ve Metot	10
2. DÜZLEMSEL İLETİM HATLARI	11
2.1 Giriş	11
2.2 İletim Hattı Parametreleri	12
2.2.1 Statik Analiz	13
2.2.2 Dinamik Analiz	14
2.3 Mikroserit Hat	17
2.4 Es Düzlemsel Dalga Kılavuzu (CPW)	
2.5 Es Düzlemsel Seritler (CPS).	
2.6 Serit Hat	
2.7 Yarık (Slot) Hat	31
3 FILTRE TASARIMI	33
3 1 Giris	33
3.2 Transfer Fonksivonları	33
3.2.1 Genel Tanımlar	33
3 2 2 Kompleks Düzlemde Kutun ve Sıfırlar	35
3 2 2 1 Butterworth Cevah	
3 2 2 2 Chebyshey Cevah	
3 2 2 3 Flintik Fonksivon Cevabi	
2.2.2.5 Eliptik Folksiyoli Cevall	<i>ر</i> د 11
J.J Alaya Olille Kayul Meluuu le Fille Tasalilli	

3.3.1 Butterworth Filtre	41
3.3.2 Chebyshev Filtre	47
3.3.3 Eliptik Filtre	
3.4 Frekans ve Eleman Dönüşümleri	
3.4.1 Alçak Geçiren Filtre Dönüşümü	
3.4.2 Yüksek Geçiren Filtre Dönüşümü	
3.4.3 Band Geçiren Filtre Dönüşümü	60
3.4.4 Band Tutan Filtre Dönüşümü	63
3.5 Filtre Sentezi	
4. YAPILAN PAKET PROGRAMIN TANITIMI	69
4.1 Giriş	69
4.2 Filtre Analizi	71
4.3 Filtre Sentezi	
4.4 Quasi-Statik Analiz	
4.5 Grafik Analiz	
4.6 Yardım	109
5. KULLANILAN YAZILIMLAR	
5.1 Giriş	110
5.2 Visual C#.Net	110
5.3 Borland Delphi	111
6. SONUÇ VE TARTIŞMA	112
6.1 Sonuç	112
KAYNAKLAR	
Ekler	
Özgeçmiş	135

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayt	fa
Şekil 1.1 Düzlemsel iletim hatlarına ait kesitler	.3
Şekil 1.2 Çok katmanlı bir iletim hattı	.5
Şekil 1.3 "Txline" program görüntüsü	.7
Sekil 1.4 "Filter Design" program görüntüsü	.8
Şekil 1.5 "Filter Free" program görüntüsü	.9
sekil 2.1 Dielektrikli mikroşerit hat kesiti1	3
ekil 2.2 Mikroşerit hat kesiti1	8
ekil 2.3 Eş düzlemsel dalga kılavuzu kesitleri, (a) Klasik eş düzlemsel dalga kılavuzu	
(b) İletken destekli eş düzlemsel dalga kılavuzu2	22
ekil 2.4 Eş düzlemsel şerit kesiti	26
ekil 2.5 Şerit hat kesiti2	28
ekil 2.6 Yarık hat kesiti	31
ekil 3.1 İki portlu devre3	33
ekil 3.2 Butterworth alçak geçiren cevabı	36
ekil 3.3 Butterworth cevabı için kutup dağılımı3	37
ekil 3.4 Chebyshev alçak geçiren cevabı3	37
ekil 3.5 Chebyshev cevabı için kutup dağılımı3	39
ekil 3.6 Eliptik fonksiyon alçak geçiren cevabı4	10
ekil 3.7 Eliptik rasyonel fonksiyon grafiği4	1
ekil 3.8 Butterworth filtre cevabı4	12
ekil 3.9 Butterworth filtre alçak geçiren cevabı4	12
ekil 3.10 Butterworth filtrenin zayıflama karakteristiği4	14
ekil 3.11 Örnek 3.1'deki Butterworth filtrenin iletim ve yansıma karakteristiğinin	
Mathcad program görüntüsü4	15
ekil 3.12 İlk elemanı kapasitans olan prototip devre4	16
ekil 3.13 İlk elemanı indüktans olan prototip devre4	16
ekil 3.14 İlk elemanı kapasitans olan 6. dereceden Butterworth alçak geçiren filtre	
prototip devresi4	16
Sekil 3.15 3. dereceden filtre için Chebyshev ve Butterworth cevaplarının	
karşılaştırılması4	18
Sekil 3.16 İlk elemanı kapasitans olan 7. dereceden Chebyshev alçak geçiren filtre	
prototip devresi	51
Sekil 3.17 Eliptik filtre alçak geçiren prototipleri (a) seri paralel rezonans devreleri ile	
(b) paralel seri rezonans devreleri ile	;3
Sekil 3.18 Alçak geçiren filtrenin iletim karakteristiği5	56
Sekil 3.19 Alçak geçiren filtre için ilk elemanın kapasitans olması durumundaki	
eleman dönüşümü5	56
sekil 3.20 Alçak geçiren filtre için ilk elemanın indüktans olması durumundaki	
eleman dönüşümü5	57
sekil 3.21 Yüksek geçiren filtrenin iletim karakteristiği5	58

Şekil 3.22 Yüksek geçiren filtre için ilk elemanın kapasitans olması durumundaki	
eleman dönüşümü	58
Şekil 3.23 Yüksek geçiren filtre için ilk elemanın indüktans olması durumundaki	
eleman dönüşümü	59
Şekil 3.24 Alçak geçiren filtreden band geçiren filtreye dönüşüm	60
Şekil 3.25 Band geçiren filtre karakteristiği.	61
Şekil 3.26 Band geçiren filtre için ilk elemanın kapasitans olması durumundaki	
eleman dönüşümü	62
Şekil 3.27 Band geçiren filtre için ilk elemanın indüktans olması durumundaki	
eleman dönüşümü	63
Şekil 3.28 Band tutan filtre karakteristiği	63
Sekil 3.29 Band tutan filtre için ilk elemanın kapasitans olması durumundaki	
eleman dönüşümü	64
Sekil 3.30 Band tutan filtre icin ilk elemanın indüktans olması durumundaki	
eleman dönüsümü	65
Sekil 3.31 İlk elemanı seri indüktans olan devre	68
Sekil 3.32 İlk elemanı seri kapasitans olan devre	68
Sekil 4.1 Program bölümlerinin cember döngüsü	70
Sekil 4.2 "Baslangic" form görüntüsü	71
Sekil 4.3 "Filtre Türleri" form görüntüsü	72
Sekil 4.4 "Analiz Türleri" form görüntüsü	72
Sekil 4.5 "Filtre Derecesine Göre" analiz sayfası görüntüsü	73
Sekil 4.6 "Arava Girme Kayhina Göre" analiz sayfası görüntüsü	73
Sekil 4.7 Uvgulama 4.1 join analiz görüntüsü	<i>15</i> 74
Sekil 4.8 Uvgulama 4.1 için analiz sonucları görüntüsü	, - 75
Sekil 4.9.6 dereceden Butterworth alcak gegiren filtrenin iletim ve vansıma	
karakteristiği görüntüsü	75
Sakil 4 10 Grafik üzerinde vanilabilen islemler menüsü	<i>15</i> 76
Sokil 4 11 S21(w) grafiği üzerinde $w= 2$ değerine karşılık 36 dB sevivesinin	70
okuması	77
Solil 1 12 "Grofil" monü görüntügü	.// 70
Sokil 4.12 'Drattin Grafik Avarları'' form görüntüsü	70 78
Sekil 4.14 Voni avarlarda alda adilan grafik görüntüsü	.70
Sekil 4.14 Telli ayallalua elue eulieli gialik golullusu	77 ۵۵
Sekil 4.15 Çoklu glalık çalışına görüllüsü.	00 00
Sekil 4.10 Granklehn Gorunum menusunden duzene koyunnası	00
Sekii 4.17 Kayıt işlemleri Torm gorunlusu	16 co
Sekii 4.18 Dosya Kaydet pencere goruntusu	82
Sekii 4.19 Filter.pinr dosyasinin ekran goruntusu	83
Sekil 4.20 "FilterSpesifik.pinr" dosyasinin ekran goruntusu	83
Sekil 4.21 "Grafik->Dosyadan Aç" menu goruntusu	84
Şekil 4.22 "Aç" pencere görüntüsü	84
Şekil 4.23 "Filter.plnr" dosyasından okuma sonucu oluşan grafik görüntüsü	85
Şekil 4.24 "Butterworth Filtre Türleri" form görüntüsü	86
Şekil 4.25 Butterworth "Alçak Geçiren Filtre" sayfa görüntüsü	.86
Şekil 4.26 Ilk elemanı kapasite olan 6. dereceden alçak geçiren filtre prototip eşdeğer	ſ
devre görüntüsü	87
Şekil 4.27 Butterworth "Band Geçiren Filtre" sayfa görüntüsü	87
Şekil 4.28 Ilk elemanı indüktans olan band geçiren prototip eşdeğer devre görüntüsü	88
Şekil 4.29 "Sonuçları Kaydet" pencere görüntüsü	89
Şekil 4.30 "Sonuçlar başarıyla kaydedildi" mesaj görüntüsü	89

Şekil	4.31	"Sonuçlar.txt" dosyasının ekran görüntüsü	.90
Şekil	4.32	Alçak geçiren filtrenin S21(w) grafiği üzerinde f(w)=4 GHz değerine	
ka	rşılık	gelen -36 dB seviyesinin okunması	.91
Şekil	4.33	Butterworth band geçiren filtrenin iletim ve yansıma karakteristiği	.91
Şekil	4.34	Uygulama 4.2 için analiz sonuçları görüntüsü	.92
Şekil	4.35	7. dereceden Chebyshev alçak geçiren filtrenin iletim ve yansıma	
ka	rakte	ristiği görüntüsü	.93
Şekil	4.36	Chebyshev "Alçak Geçiren Filtre" sayfa görüntüsü	.93
Şekil	4.37	İlk elemanı kapasite olan 7. dereceden alçak geçiren filtre prototip eşdeğer	
de	vre g	jörüntüsü	.94
Şekil	4.38	"Eliptik Filtre Analiz Türleri" form görüntüsü	.95
Şekil	4.39	Uygulama 4.3 için analiz görüntüsü	.95
Şekil	4.40	Uygulama 4.3 için analiz sonuçları görüntüsü	.96
Şekil	4.41	Eliptik filtrenin kutup ve sıfırlarının bulunması	.96
Şekil	4.42	5. dereceden Eliptik filtrenin iletim ve yansıma karakteristiği görüntüsü	.97
Şekil	4.43	"Chebyshev Sentez Prototip" formu analiz görüntüsü	.98
Şekil	4.44	"Chebyshev Sentez Prototip" formu analiz sonuçları görüntüsü	.98
Şekil	4.45	"Chebyshev Filtre Sentez Türleri" form görüntüsü	.99
Şekil	4.46	"Chebyshev Sentez Bölüm" form görüntüsü	.99
Şekil	4.47	Chebyshev filtre için kutup ve sıfırların bulunması	100
Şekil	4.48	Chebyshev filtre için empedans fonksiyonunun bulunması	101
Şekil	4.49	Chebyshev filtre için prototip eleman değerlerinin sentez yoluyla	
bu	lunm	ası	101
Şekil	4.50	"Chebyshev Filtre Türleri" form görüntüsü	102
Şekil	4.51	"Planar Analiz" form görüntüsü	103
Şekil	4.52	"Şerit Hat" analiz görüntüsü	104
Şekil	4.53	"Şerit Hat" sentez görüntüsü	104
Şekil	4.54	Dielektrik seçimi	105
Şekil	4.55	İletken seçimi	105
Şekil	4.56	"Şerit Hat" analiz sonuçları görüntüsü	106
Şekil	4.57	"Şerit Hat" sentez sonuçları görüntüsü	106
Şekil	4.58	"Mikroşerit Hat" form görüntüsü	107
Şekil	4.59	"Klasik Eş Düzlemsel Dalga Kılavuzu" form görüntüsü	107
Şekil	4.60	"İletken Destekli Eş Düzlemsel Dalga Kılavuzu" form görüntüsü	108
Şekil	4.61	"Eş Düzlemsel Şerit" form görüntüsü	108
Şekil	4.62	"Slot Hat" form görüntüsü	109

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1.1 Şekil 1.1'de gösterilen düzlemsel iletim hatlarının özellikleri	4
Tablo 3.1 1-9 arası derecelerdeki Butterworth alçak-geçiren filtrenin prototip eleman	
değerleri (g ₀ =1.0, w _c =1, L _{Ar} =3.01 dB)	.47
Tablo 3.2 Farklı dereceler için Chebyshev polinomları	.49
Tablo 3.3 1-9 arası derecelerdeki Chebyshev alçak geçiren filtrenin prototip eleman	
değerleri (g ₀ =1.0, w _c =1, L _{Ar} =0.01 dB)	.52
Tablo 3.4 1-9 arası derecelerdeki Chebyshev alçak geçiren filtrenin prototip eleman	
değerleri (g ₀ =1.0, w _c =1, L _{Ar} =0.04321 dB)	.52
Tablo 3.5 1-9 arası derecelerdeki Chebyshev alçak geçiren filtrenin prototip eleman	
değerleri (g ₀ =1.0, w _c =1, L _{Ar} =0.1 dB)	.52
Tablo 3.6 1-7 arası derecelerdeki Eliptik alçak geçiren filtrenin prototip eleman	
değerleri ($g_0=g_{N+1}=1$, $w_c=1$, $L_{Ar}=0.1$ dB)	54
Tablo 3.7 Eleman elde edilmesi ve kontrolü için sistematik	.66

SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ

RF	Radyo frekansı
IC	Entegre devre
MIC	Mikrodalga entegre devre
MMIC	Monolitik mikrodalga entegre devre
CPS	Eş düzlemsel şerit
CPW	Eş düzlemsel dalga kılavuzu
Z_0	Karakteristik empedans
С	Işık hızı
λ	Dalga boyu
λ_0	Serbest boşluk dalga boyu
${\cal E}_r$	Dielektrik sabiti
${\cal E}_{e\!f\!f}$	Efektif dielektrik sabiti
α	Zayıflama sabiti
lpha eta	Zayıflama sabiti Faz sabiti
lpha eta f_c	Zayıflama sabiti Faz sabiti Kesim frekansı
lpha eta f_c f_s	Zayıflama sabiti Faz sabiti Kesim frekansı Araya girme kaybının gerçekleştiği frekans
lpha eta f_c f_s ω_c	Zayıflama sabiti Faz sabiti Kesim frekansı Araya girme kaybının gerçekleştiği frekans Normalize kesim frekansı
α β f_c f_s ω_c ω_n	Zayıflama sabiti Faz sabiti Kesim frekansı Araya girme kaybının gerçekleştiği frekans Normalize kesim frekansı Seçicilik faktörü
lpha eta f_c f_s ω_c ω_n N	Zayıflama sabiti Faz sabiti Kesim frekansı Araya girme kaybının gerçekleştiği frekans Normalize kesim frekansı Seçicilik faktörü Filtre derecesi
lpha eta f_c f_s ω_c ω_n N L_{Ar}	Zayıflama sabiti Faz sabiti Kesim frekansı Araya girme kaybının gerçekleştiği frekans Normalize kesim frekansı Seçicilik faktörü Filtre derecesi Geçme bandı dönme kaybı
$egin{array}{c} lpha & & \ eta & & \ eta & & \ f_c & & \ f_s & & \ eta_c & & \ eta_n & & \ eta & \ eta & \ eta & \ eta & & \ eta & $	Zayıflama sabiti Faz sabiti Kesim frekansı Araya girme kaybının gerçekleştiği frekans Normalize kesim frekansı Seçicilik faktörü Filtre derecesi Geçme bandı dönme kaybı Araya girme kaybı
$egin{array}{c} lpha & & \ eta & & \ eta & & \ f_c & & \ f_s & & \ eta_c & & \ eta_n & & \ eta & \ eta & \ eta & \ eta & \ eta & \ $	Zayıflama sabitiFaz sabitiFaz sabitiKesim frekansıAraya girme kaybının gerçekleştiği frekansıNormalize kesim frekansıSeçicilik faktörüFiltre derecesiGeçme bandı dönme kaybıAraya girme kaybıRipple faktörü

1. GİRİŞ

1.1 Mikrodalga Entegre Devreleri

1.1.1 Tarihçe

Mikrodalga entegre devreleri (MICs) 1950'lerde ortaya çıkmıştır. O zamandan beri mikrodalga entegre devreler radyo frekansının (RF) ve mikrodalga teknolojilerinin ilerlemesinde önemli rol oynamıştır. Mikrodalga teknolojisinde en önemli kilometre taşı monolitik (tek parça) mikrodalga entegre devrelerin (MMICs) ortaya çıkması olmuştur. Mikrodalga entegre devrelerindeki bu ilerlemeler katı hal teknolojisi ve düzlemsel (planar) iletim hatlarının gelişmesiyle mümkün olmuştur. Düzlemsel iletim hatları iletken şeritlerin bir dielektrik taban malzemesinin yüzeylerine yerleştirilmesiyle oluşur. Bu yapılar mikrodalga entegre devrelerin temelini oluşturur ve birçok mikrodalga mühendisleri için önemli ve ilginç bir araştırma konusu olmuştur. Mikrodalga entegre devrelerindeki ilerlemelerle birlikte mikrodalga ve milimetrik dalga pasif devreler için özellikle mikrodalga entegre devrelerin doğru analizleri ve tasarımı için duyulan ihtiyaca karşılık olarak bir çok analiz metodu geliştirildi. Bu analiz metotları yeni düzlemsel iletim hatlarının araştırılması ve geliştirilmesinde daha çok yardımcı olmuştur.

Mikrodalgaların varlığı çok uzun yıllardan beri bilinmesine rağmen, mikrodalga devrelerindeki hızlı gelişmeler ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında, özellikle karşılaşılan radar problemlerinin giderilmesi ile başlamıştır. Bu yıllarda "*Mikrodalga Devreler*" terimi ile "*Dalgakılavuzu Devreleri*" terimi çoğu zaman eşanlamlı olarak kullanılmıştır. Mikrodalga frekansları için kullanışlı bir transmisyon yapısı olarak değerlendirilmiş olan dalgakılavuzları ile ilgili olarak yapılan ilk çalışmalar Bell Telefon Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir.

Bu konuda özellikle radar problemlerine çözüm bulmak için yapılan çalışmalar sayesinde mikrodalga devreleri konusunda hızlı gelismeler sağlandı. Bu yıllarda, TEM modu koaksiyel hatlar ve dalga kılavuzları olmak üzere, iki temel yapı incelendi. 1950'li yılların başında, Barret ve Barnes tarafından serit hatlar tasarlandı (Howe 1974). Yine aynı yıllarda farklı bir transmisyon yapısı olarak sunulan mikroşerit hatlar, radvasvonun neden olduğu birim uzunluktaki yüksek kayıplarından dolayı ilk zamanlar pek kabul görmedi. Bununla birlikte, sivil ve askeri mikrodalga uygulamaları için sürekli artan minyatür mikrodalga devre ihtiyacı 1960'lı yıllarda, mikroşerit devrelere olan ilgiyi artırdı. Wheeler, mikroşerit yapıların, Konform dönüşüm metoduna dayalı çok basit bir analizini geliştirdi (Wheeler 1964). Yüksek dielektrik sabitine sahip düşük kayıplı dielektrik malzemelerin imal edilmesi ve metalik filmlerin yoğunlaştırılmasıyla ilgili teknolojik gelişmeler, mikroşerit devrelerin kullanımında hızlı ilerlemeler sağladı ve bu yapıların mükemmel hale gelmesinde etkin bir rol aldı. Bu gelişmelerle birlikte, fotolitografi ve ince film yoğunlaştırma tekniklerinin ve avrıca, mikrodalga süper iletken elemanlar teknolojisinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ile, "Mikrodalga Entegre Devre" teknolojisi doğdu (Gupta vd 1978).

Günümüzün mikrodalga teknolojisi olarak ifade edebileceğimiz MMIC teknolojisi, yüksek dirençli silikon (Si) ve galyum-arsenik (GaAs) ve silisyum dioksit (SiO₂) tabakalı düşük dirençli yarı-iletken tabanlarının MIC'lerde kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır (Goyal 1989). MMIC teknolojisindeki önemli gelişmeler, 1970'li yılların sonunda başlamış ve pratik devreler 1980'lerin ortasında ortaya çıkmıştır. MMIC'lerin araştırılması ve geliştirilmesi birkaç yıl içerisinde oldukça mesafe kaydetti (Esfandiari vd 1983, Hobdell 1979, Wheeler 1997, Liu vd 1986, Ohira 1987). MMIC'lerin çoğu mikroşerit hat konfigürasyonuna sahiptir. Bu konfigürasyonlar, toprak iletkenlerle bağlantı sağlamak için geçiş delikleri ve sınırlı kalınlıklara sahip ince taban ihtiyaçlarının yanında ilave işlemler gerektirdiğinden MMIC çip boyutunu azaltmak amacıyla bir çok araştırmacı tarafından tek yüzlü MMIC (Uniplanar MMIC's) konfigürasyonları önerildi (Hirota vd 1987, Ogawa vd 1987, Muraguchi vd 1998). Geliştirilen tek yüzlü MMIC'ler özellikle devre boyutlarının ve imalat masraflarının az olmasından dolayı, radyo sistemlerinde, mobil ve uydu haberleşme sistemlerinde önemli rol üstlenmiştir.

Günümüzde mikrodalga entegre devreleri, çoğunlukla seramik veya dielektrik taban üzerinde yoğunlaştırılmış iletkenlerin modellenmesiyle elde edilen devreleri, pasif elemanları ve ayrıca çip formunda özel olarak tasarlanmış olan devrelere monte edilmiş aktif elemanları ihtiva etmektedir. Mikrodalga entegre devrelerinde mikroşerit hatlara ilave olarak, yarık hat (Slot hat) ve koplanar hat (CPW ve CPS) olarak adlandırılan diğer düzlemsel hatlar da kullanılmaktadır (Cohn ve Wen 1969). Yarık hatlar, sadece bir yüzeyi iletken kaplı olan ve bu yüzeyi dar bir yarık içeren bir dielektrik tabandan meydana gelir. Koplanar hatlar ise, bütün iletkenleri aynı düzlem üzerinde olan yani dielektrik tabanın sadece üst yüzeyinde olan iletim hatlarıdır. Şekil 1.1'de uygulamalarda kullanılan düzlemsel iletim hatlarına ait kesitler görülmektedir.



Şekil 1.1 Düzlemsel iletim hatlarına ait kesitler

1.2 Düzlemsel İletim Hatları ve Mikrodalga Entegre Devreleri

Düzlemsel iletim hatları; mikrodalga entegre devrelerin temel elemanlarıdır. Bunlar hem baluns, filtreler, hibridler ve kuplörler gibi pek çok devre fonksiyonlarının gerçekleştirilmesinde hem de sinyallerin mümkün olabildiğince kayıpsız bir şekilde taşınmasında kullanılır. Düzlemsel iletim hatlarının özellikleri tablo halinde Tablo1.1'de özetlenmiştir. Herbir düzlemsel iletim hattı kendisine ait benzersiz avantajlara ve dezavantajlara sahiptir ve bağlı olduğu devre tipleri, tek iletim hattı veya bunların birleşiminin her ikisine de hem istenilen devre fonksiyonlarını hem de en uygun performansları elde etmede ihtiyaç duyulur. En uygulanabilir düzlemsel iletim hatları belki de basit mikroşerit hattı ve diğer düzlemsel iletim hatlarından yavaş gelişen koplanar dalga kılavuzudur (CPW). Bu iletim hatları ihtiyaca göre tekli ya da ardışık bağlı olarak kullanılabilmektedir.

İletim Hattı	Sistem Frekansı (GHz)	Karakteristik Empedans (Ohm)	Boyut	Кауір	Güç Eldesi	Katı Hal Alet Montajı	Düşük Maliyetli Üretim
Mikroşerit Hat	<=110	10-100	Küçük	Yüksek	Alçak	Fena değil	İyi
Şerit Hat	<=60	20-150	Orta	Alçak	Alçak	Orta	İyi
Ekranlanmış Şerit Hat	<=220	20-150	Orta	Alçak	Alçak	Orta	Fena değil
Yüzgeç Hat	<=220	20-400	Orta	Orta	Alçak	Kolay	Fena değil
Yarık Hat	<=110	60-200	Küçük	Yüksek	Alçak	Kolay	İyi
Terslendirilmiş Mikroşerit Hat	<=220	25-130	Küçük	Orta	Alçak	Orta	Fena değil
Eş Düzlemsel Dalga Kılavuzu	<=110	40-150	Küçük	Yüksek	Alçak	Çok kolay	İyi
Eş Düzlemsel Şeritler	<=110	30-250	Küçük	Yüksek	Alçak	Kolay	İyi

Tablo 1.1 Şekil 1.1'de gösterilen düzlemsel iletim hatlarının özellikleri

Şekil 1.2'de görülmekte olan çok katlı düzlemsel iletim hatları; esnek olmaları ve karmaşık devreleri gerçekleştirmedeki kabiliyetiyle birlikte, yüksek oranda devre

bütünleşmesine izin vermesinden dolayı özellikle mikrodalga entegre devreleri için çekici olmaktadır.



Şekil 1.2 Çok katmanlı bir iletim hattı

Mikrodalga pasif devre elemanları, iletim hatları ve dalgakılavuzları boyunca dağılmış olarak bulunmaktadır. 1960'lı yılların sonunda yapılan çalışmalar, mikrodalga devrelerinin analizi için, toplu eleman devre analizi yöntemlerinin kullanılması üzerinde yoğunlaşmıştır (Daly vd 1967, Katoh 1967, Caulton vd 1968, 1971, Alley 1970, Aitchison vd 1967). Toplu elemanların, dielektrik tabanlar üzerine monte edilmiş çip formundaki yarı iletken elemanlarla birlikte kullanımı mikrodalga entegre devreleri için cazip bir seçenek olmuş ve maliyet % 50 oranında düşürülmüştür. Boyut indirgeme özelliklerinin yanında, toplu elemanların diğer bir avantajı ise alçak frekanslarda geliştirilmiş olan devre tasarımı ve optimizasyon tekniklerinin doğrudan doğruya mikrodalga frekans bölgesinde de kullanılabilme imkanı sağlamasıdır. Bu avantajların yanı sıra, yüksek güvenilirlikde karşılaşılan problemi ortadan kaldırmak için çok hassas düzenlere olan ihtiyaç ve doğruluk derecesinin yüksek tutulması problemi gibi dezavantajlar ortaya çıkmıştır. Bu problemlerin giderilmesi için simülasyon ve optimizasyon tekniklerinin ve CAD paketlerinin kullanılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Gupta 1981).

MMIC teknolojisinde bir GaAs alt tabakası üzerinde üretim, sıvı fazlı ve buhar fazlı epitaksi, iyon aşılama, saçılma, buharlaşma, yayılma veya tüm bu metodların bileşimini içeren farklı depolama, paketleme metotlarından herhangi birisi ile yapılabilir. GaAs'in 4 GHz'in daha üstündeki mikrodalga frekanslarında kuvvetlendirme ve osilasyon yapma yeteneğine sahip olan monolitik entegre devrelerin ve ayrık transistörlerin

üretimi için uygun olan şu anda mevcut tek taban malzemesi olduğu gerçeği ile GaAs MMIC'ler gelişimini sürdürmektedir. Hibrid ve Monolitik MIC'ler, alçak frekans entegre devreleriyle hemen hemen aynı avantajları sunar. Bu avantajları sırasıyla şu şekilde ifade edebiliriz:

-Geliştirilmiş sistem güvenirliği,

-İndirgenmiş hacim ve ağırlık,

-Büyük oranda standartlaştırma ihtiyacında düşük maliyet,

-Yüksek performans.

Bu avantajlarının yanı sıra, MIC'lerin kullanımına ilişkin bazı problemler vardır (Gupta 1978). MIC'ler, yaygın olarak kullanılmadan önce, mikrodalga devre tasarımcıları ve kullanıcıları, devre performansını üretimden sonraki aşamalarda düzenli bir şekilde optimize etmek için kullanılan ayar vidaları ve adaptörlerin birleştirilmesi esnekliğine sahiptiler. MIC'ler özellikle, yüksek güvenirlik ihtiyaçlarını karşılama durumunda bu harici düzenleme ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu nedenle MIC'lerde hassas olarak karakterize edilmiş düzenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak, kullanılan düzenler daha hassas karakterize işlemi gerektirir ve devreler daha düzenli bir şekilde tasarlanmak zorundadır. Bu sebeple, problemleri gidermek için simülasyon ve optimizasyon teknikleri ve CAD paketlerinin kullanımı zorunlu bir hale gelmiştir.

1.3 Mikrodalga Filtreler

Mikrodalga filtreler, hücresel haberleşme, mikrodalga devreleri, radarlar, test ve ölçüm sistemleri gibi çeşitli birçok uygulama alanlarında yer bulmaktadır. Avantajları olan; küçük boyutlu, düşük maliyetli ve üretimlerinin kolay olmaları, mikrodalga yapıların günümüzde filtre uygulamalarında yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır.

Mason, Sykes, Darlington, Fano, Lawson ve Richards'ın öncülüğünü yaptığı mikrodalga filtre teorisinin temelleri II. Dünya savaşı yıllarında atılmıştır. Mikrodalga filtre tasarlamak üzere çeşitli metotlar geliştirilmiştir. İletim parametreleri metodu ile filtre tasarımı 1930'ların sonlarında önerildi. Günümüzde ise, birçok filtre araya girme kaybı metodu ile tasarlanmaktadır. Bu metot devre analizi tekniğine dayanmaktadır.

1948 yılında P.I. Richards mikrodalga filtre tasarımına yeni bir teori kazandırdı. Richards'ın teoremi; toplu elemanlar ile tasarlanan filtrenin ayrık iletim hatlarına dönüşümüne dayanmaktadır (Richards 1948). Richards'ın dönüşümleri K. Kuroda'nın dört tanımlaması ile birleşmektedir (Ozaki ve Ishii 1958). Bu tanımlamalar ile toplu elemanlar filtre prototipi, açık ve kısa devre iletim hattı dalları ile fiziksel olarak gerçeklenir.

1.4 Düzlemsel İletim Hatlarının Quasi-Statik Analizine ve Filtre Tasarımına Yönelik Mevcut Bazı Programların İncelenmesi

Düzlemsel iletim hatlarının quasi-statik analizi, filtre analizi ve tasarımı konusu ile alakalı birçok programlar yapılmış olup bu tez çalışmasında birkaç tanesi üzerinde inceleme yapılmıştır. Programların ulaşılabildiği ilgili linkler **KAYNAKLAR** başlığı altında verilmiştir (Bkz. KAYNAKLAR).

1.4.1 Txline

TXLINE 2003 - Mice	rostrip	100		200	100	-		x
Microstrip Stripline C	PW CPW Ground	Round Coaxial	Slotline	Coupled MSLine (Coupled	Stripline		
Material Parameters								
Dielectric GaAs	•	Conductor	Silver		•	• •	⊷w→ ↓	
Dielectric Constant	6.15	Conductivity	5.88E+07	S/m	•	Ĥ	 	
Loss Tangent	0.0019			AWR				777.
Electrical Characteristic	08		1	-Physical Characte	ristic			
Impedance	50	Ohms 💌		Physical Length (L) 294	.771	mil	•
Frequency	10	GHz 💌		Width (V	V) 1.6	5	mm	-
Electrical Length	90	deg 💌		Height (I	H) 0.64	4	mm	•
Phase Constant	180	deg/m 💌		Thickness (T) 35		um	•
Effective Diel. Const.	10							
Loss	10	dB/m ▼						

Şekil 1.3 "Txline" program görüntüsü

"Txline" düzlemsel iletim hatlarının quasi-statik analizine yönelik tek bir arayüzden oluşmuş bir paket programdır (Bkz Şekil 1.3). Programın çalışması şu şekildedir: Kullanıcı, bir taraftan girdiği hat parametrelerine karşılık ileri-geri "Ok" butonları ile diğer taraftaki istenilen parametre değerlerine ulaşabilmektedir.

1.4.2 Filter Design

Filtre tasarımına yönelik olarak yapılmış "Filter Design" paket program görüntüsü Şekil 1.4'de görülmektedir. Programın çalışması şu şekildedir : Kullanıcı tasarıma; "DESIGN" menüsünden filtre tipini seçerek başlar. Açılan "Filtre Fonksiyonu" formundan filtre fonksiyonunu seçerek parametrelerin girildiği forma ulaşır. Bu formda parametreleri girdikten sonra "Enter" butonu ile kullanılacak bobinin kayıplarının girileceği bir metin kutusu karşısına gelir. Kullanıcı, buraya bobinin kaybını girerek tekrar "Enter" butonu ile oluşturulacak filtre devresinin başlığının ne olacağını soran bir mesaj kutusuna ulaşır. Buraya devrenin adını yazdıktan sonra girilen parametre değerlerine göre oluşturulan devreyi elde etmiş olur.



Şekil 1.4 "Filter Design" program görüntüsü

1.4.3 Filter Free

Filtre tasarımına yönelik olarak yapılmış başka bir paket program olan "Filter Free" görüntüsü de Şekil 1.5'de görülmektedir. Programın çalışması şu şekildedir : Bu programda filtre tipinin seçimi, filtre fonksiyonunun seçimi ve parametre değerlerinin girilmesi tek bir arayüz formu üzerinden sağlanıyor olması, programın pratik kullanımını sağlamaktadır. Kullanıcı, programı ilk çalıştırdığında ekrana gelen form üzerinde parametre değerlerini girip istenen seçimleri yaptıktan sonra "Circuit" butonu ile devreyi görebilmektedir. Bu programda analizlere ek olarak, oluşturulan grafiğin transfer fonksiyonunu ve sıfır kutup grafiğini de görebilmek mümkündür.

If Filter Free 2008 Nuhertz Technologies, LLC File Data Upgrade Options Window Help							
Filter Type Gaussian Bessel Clebeyshev I Chebyshev I Chebyshev I Hourglass Elliptic Raised Cos Matched Delay	Filter Attributes Set Order 3 Order 1 Pass Band Freq Add Tx Zeros Implen ⊙ Pa	ndard Pass Band Atten nentation ssive© Tx Line © Active	e ◯ Sw Cap◯ Diqital	Passive Design Ideal Filter Response ☐Transfer Function Pole Zero Plots Reflection Coefficient ☐Circuit Paramaters ☐Current Source ☑ Voltage Source ☑ 1st Ele Shunt ☑ 1st Ele Series Min Inductors	Time Response Frequency Response Incl Source Bias Source Res Load Res		
Filter Class C Low Pass High Pass	Band Pass ● Rad/Sec ● Hertz Band Stop	Graph Limits 0.1 10 Min Freq Max Freq	0 10 Min Time Max Time	Synthesize Filter			
WUNCETEZ www.nuhertz.com							

Şekil 1.5 "Filter Free" program görüntüsü

1.5 Tezin Amacı ve Önemi

Bu tez çalışmasında, *Txline, Filter Design, ve Filter Free* gibi programların tüm işlevlerini tek başına yerine getirebilecek ve bunun yanında daha esnek bir grafik gösterim, daha hızlı ve basit hesaplama gibi farklı işlevleri sunabilme yeteneğine sahip geniş kapsamlı bir paket program tasarlanması amaçlanmıştır. Tek bir paket altında veya kendi başına kullanılma özelliğine sahip bir çok formlar kullanılarak hazırlanan yeni paket program ile düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin analizi yapılabilmekte ve aynı zamanda filtre tasarımı gerçekleştirilmektedir.

1.6 Materyal ve Metot

Mikrodalga literatüründe filtre tasarımına yönelik çeşitli metodlar bulunmaktadır. Bu metotlar incelendiğinde "Araya Girme Kaybı Metodu (Insertion Loss Method)" 'nun diğer metotlara kıyasla daha yaygın bir kullanıma sahip olduğu sonucuna varılarak bu metot üzerinde yoğunlaşılmıştır. Düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin hesaplanmasında ise bir Quasi-statik analiz metodu olan "Konform Dönüşüm Metodu (Conformal Mapping Method)" kullanılmıştır.

Bir filtre tasarımının ilk adımı arzu edilen filtre karakteristiğini elde edebilmek için gerekli eleman değerlerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede hazırlanan programda öncelikli olarak *Araya girme kaybı* metoduyla *Butterworth, Chebyshev* ve *Eliptik* karakteristikli frekans cevapları için prototip alçak geçiren filtre eleman değerleri hesaplanmakta ve daha sonra prototip eleman değerlerinden gerçek filtrelerin eleman değerlerine geçiş yapılmaktadır. Ayrıca, hazırlanan yeni paket program kendine özgü grafik paketi ve kayıt formatları gibi birçok fonksiyonel özelliğiyle kullanıcıya değişik platformlarda çalışma imkanı sunmaktadır.

Yazılım aşamasında *Visual C#.Net* ve *Borland Delphi* yazılım dillerinden yararlanılmıştır. Bu dillerin seçilme nedeni; görsel programlamaya elverişli olmalarının yanı sıra tezde ortaya konan temel hedeflere ulaşabilmede yeterli imkanlara sahip olmalarıdır.

2. DÜZLEMSEL İLETİM HATLARI

2.1 Giriş

Düşük frekanslı dijitalden yüksek frekanslı RF ve mikrodalga devrelerine kadar neredeyse tüm elektronik devrelerde iletim hatları kullanılır. İletim hatları arasında, düzlemsel iletim hatları olarak da bilinen baskı devre yapıları modern elektronikte en yararlı hatlardır. Düzlemsel iletim hatları, elektronik entegre devrelerindeki ilerlemeler ile gelişirken, entegre devrelerinin daha sağlam ve dayanıklı olmasına ve daha iyi ara bağlantılar ve performans sağlayarak IC (entegre devre) teknolojilerinin ilerlemesine yardımcı olmuştur.Düzlemsel iletim hatları sadece sinyal verme şeklindeki en temel amaçlarını sağlamakla kalmamış aynı zamanda uygun şekilde kombinasyonlarının sağlanması ile geniş bant hibrit jonksiyonları gibi muhtelif RF ve mikrodalga elemanlarının yaratılması için de kullanılabilmektedir. En çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan düzlemsel iletim hattı, 1952'de ileri sürülen mikroşerit hatdır. Bu, şerit hattı ile birlikte, koaksiyel iletim hattının ilk düzlemsel versiyonunu oluşturmaktadır. O tarihten bu yana, RF ve mikrodalga IC'lerde kullanılmak üzere muhtelif düzlemsel iletim hatları geliştirilmiştir. Bölüm 1'de yaygın olarak kullanılan düzlemsel iletim hatları açıklanmaktadır (Bkz Şekil 1.1 ve Tablo 1.1). Şu anda, RF ve mikrodalga IC'ler için en yaygın kullanılan yapılar, mikroşerit hat, eş düzlemsel dalga kılavuzu, eş düzlemsel şerit, şerit hat ve yarık hattır. Bu bölümde, Konform dönüşüm metodu kullanılarak yeni paket programın "Quasi-Statik Analiz" bölümüne ait yazılım kısmında kullanılan formülasyonların toparlanması gerçekleştirilecektir.

İlk olarak iletim hattının statik ve dinamik parametreleri incelenecektir. Daha sonra, mikroşerit hat, ortak düzlemsel dalga kılavuzu, eş düzlemsel şerit, şerit hat ve yarık hat dahil en yaygın kullanılan düzlemsel iletim hatlarının kısa bir incelemesi yapılarak, karakteristik empedanslarını, efektif dielektrik sabitlerini ve kayıplarını hesaplamada kullanılan kapalı form ifadeleri incelenecektir. Bu parametreler başka yöntemler kullanılarak doğru şekilde bulunabilir, ancak kapalı form ifadeleri, RF ve mikrodalga devrelerine yönelik hızlı bilgisayar destekli tasarım ve analizine olanak tanımaktadır.

2.2 İletim Hattı Parametreleri

Şerit hat gibi, homojen ortama takılan mükemmel iletkenli iletim hatları, saf bir enlemesine elektromagnetik (TEM) modu veya dalgasını destekler. Bununla birlikte, mikroşerit hatları gibi ikiden fazla dielektrikli iletim hatlarının sadece TEM modunu andıran quasi bir TEM modunu destekleyebileceği de bilinmektedir. TEM veya quasi TEM modu*, kesim frekansı olmayan iletim hattında dominant bir moddur. Devre tasarım amaçlı iletim hatlarının en önemli parametreleri belki de TEM modu için karakteristik empedansı ve efektif dielektrik sabitidir. İşletme frekansı arttıkça, iletim hattında TEM ve hibrit modları dahil sonsuz mod sayısı görülebilir. Hibrit modları, dc (0Hz)'den farklı kesim frekansı daha yüksek sıralı modlardır ve istenmez. Bu modlar, enlemesine elektrik (TE) ve enlemesine magnetik (TM) modlarının bir kombinasyonudur ve dolayısıyla hem elektrik hem de magnetik alanın boylamasına unsurlarına sahiptirler.

Bir iletim hattının analizinde iki yaklaşım vardır: Statik veya quasi-statik ve dinamik veya tam-dalga yaklaşımı. Statik veya quasi-statik yaklaşımı sadece, de'de geçerli olan TEM modu için iletim hattı parametrelerini oluşturur. Öte yandan, dinamik yaklaşım, sadece TEM modu için değil aynı zamanda parametreleri frekansın fonksiyonları olan hibrit modlarının da iletim hattı parametrelerini verebilir. Statik yaklaşım ile elde edilen TEM modu iletim hattı parametrelerini verebilir. Statik yaklaşım ile elde edilen TEM modu iletim hattı parametrelerini verebilir. Statik yaklaşım ile elde edilen TEM modu iletim hattı parametreleri sadece de'de teorik olarak geçerlidir. Pratikte, bu sonuçlar daha yüksek frekanslarda da kullanılabilir. Çoğu mühendis, statik sonuçları hangi frekansa kadar kullanabileceğini bilmek ister. Buna tam, açık bir cevap yoktur. Bazıları frekans sıfırdan farklı olduğu sürece, statik sonuçların kullanılamayacağına inanır. Öte yandan, çoğu mühendis, **18 GHz** frekansa kadar statik sonuçları kullanımaktadır. Aslında, W-bandı (**75-110 GHz**)'e kadar çalışan milimetre-dalga devrelerinin bir kısını, sadece statik sonuçlar kullanılarak başarı ile tasarlanmıştır. Yine de yüksek frekanslarda özellikle milimetre dalga bölgesindeki frekanslarda iletim hattı parametrelerinin daha doğru tespiti için dinamik yaklaşım kullanılmalıdır. Statik ile dinamik sonuçlar arasındaki ana özellik, statik sonuçların, hesaplaması daha kolay ancak doğruluk derecesinin daha düşük olmasıdır.

Statik analizle, frekanstan bağımsız olan iletim hattı parametreleri bulunur. Şimdi, iletim hattı statik karakteristik empedansı ve efektif dielektrik sabiti için basit eşitlikler çıkarılacaktır. Genel olarak, hem TEM hem de quasi TEM'i göstermek için TEM ve hem statik hem de quasi statik için statik ifadesi kullanılacaktır.

Genelliği kaybetmeksizin, Şekil 2.1'de gösterildiği gibi, iletim hattı temsilcisi olarak, dielektrikli kayıpsız mikroşerit hat kullanacağız.



Şekil 2.1 Dielektrikli mikroşerit hat kesiti

Bu iletim hattının karakteristik empedansı eşitlik (2.1) ile bulunur:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$
(2.1)

Buradaki L ve C, sırası ile iletim hattının birim uzunluğu başına indüktans ve kapasitanstır. L_a ve C_a , dielektrik hava ile değiştirildiğinde iletim hattı birim uzunluğu başına indüktans ve kapasitans olsun. Birim uzunluk başına indüktansın çevredeki dielektrik tabana bağlı olmadığı olgusundan hareketle eşitlik (2.1) yeniden yazılabilir.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_a C_a}{C_a C}} = \frac{1}{c\sqrt{CC_a}}$$
(2.2)

Buradaki $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ serbest boşluktaki ışık hızıdır.

İletim hattı boyunca yayılan quasi TEM dalgasının faz velositesi,

$$\upsilon_p = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \tag{2.3}$$

olarak verilir.

Buradaki ε_{eff} ; efektif dielektrik sabitidir. Eşitliğin her iki tarafının karesi alındığında ve $L = L_a$ kullanıldığında,

$$\varepsilon_{eff} = \frac{C}{C_a}$$
(2.4)

eşitliğini elde ederiz. Dalga boyu,

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mathcal{E}_{eff}}} \tag{2.5}$$

olarak verilir. Buradaki $\lambda_{\theta} = c/f$, serbest boşluk dalga boyudur.

Tüm bu eşitlikler, herhangi bir iletim hattında quasi TEM'e uygulanır. Bir iletim hattının statik karakteristik empedansı ve efektif dielektrik sabitini bulmak için, dielektrik tabanlı ve dielektrik tabansız iletim hattının birim uzunluk başına kapasitansını bulmaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Bunu yapmak için, Laplace denklemini çözmemiz gerekmektedir.

2.2.2 Dinamik Analiz

Dinamik analiz, frekansa bağımlı karakteristik empedans ve yayılım sabitini verir ve dolayısıyla TEM iletim hattı ile hibrit modları zayıflama ve efektif dielektrik sabitlerini verir. Bu yaklaşım, skaler elektrik ve uygun sınır şartlarına tabi magnetik potansiyelleri için dalga eşitliklerinin çözümü ile başlatılır ve bunlar kullanılarak elektrik ve magnetik alan sonuçları elde edilir. Bu işlem ayrıca Eigen değer denklemini de verir. Eigen değeri yayılım sabiti $\gamma = \alpha + j\beta$ dır. Buradaki α ve β sırası ile zayıflama ve faz sabitleridir. β faz sabiti, efektif dielektrik sabitinin hesaplanması için kullanılabilir.

$$\varepsilon_{eff} = \left(\frac{\beta}{k_0}\right)^2 \tag{2.6}$$

Buradaki $k_0 = \omega \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$, serbest boşluk dalga sayısıdır. Faz sabitinin şarta uyması gerektiği kaydedilmelidir.

$$\omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \le \beta \le \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0\varepsilon_r} \tag{2.7}$$

Burada ε_r , iletim hattı için kullanılan nispi dielektrik sabitlerinin en yüksek değerine sahiptir. Elektrik ve manyetik alanları kullanarak, (**dinamik**) karakteristik empedansı frekans fonksiyonu olarak hesaplayabiliriz. TEM modu karakteristik empedansının tek olduğu bilinmektedir zira mod voltaj ve akımı kendine özgü olarak tanımlanır. Bununla birlikte hibrit mod karakteristik empedansı tek değildir. Karakteristik empedansın değişik tanımları mevcuttur ve genel tanımlar, sırasıyla aşağıda gösterildiği gibi voltaj ve akım, güç ve akım, ve güç ve voltaja dayanmaktadır.

$$Z_0^{VI} = \frac{V_0}{I_0}$$
(2.8)

$$Z_0^{PI} = \frac{2P_{avg}}{|I_0|^2}$$
(2.9)

$$Z_0^{PV} = \frac{|V_0|^2}{2P_{avg}}$$
(2.10)

Buradaki V_{θ} ; iletkenler üzerindeki voltaj, I_{θ} ; boylamasına akım ve P_{avg} ; iletim hattı kesitinde iletilen zaman-ortalama güç değeridir. Bu üç karakteristik empedans,

$$Z_0^{VI} = \sqrt{Z_0^{PI} Z_0^{PV}}$$
(2.11)

ile bağlantılıdır.

Karakteristik empedansa ait farklı tanımların, dc'de olanlar hariç farklı sayısal sonuçlar verir. TEM modu için, üç tanım da aynı sonuçları verir. Bu tanımlar, P_{avg} = $1/2(VI^*)$ olduğunda da aynıdır. Genel olarak, bu durum iletim hattında hibrit modları için geçerli değildir. Güç ve akıma ve güç ve voltaja dayalı tanımlar iki iletken iletim hattından çıkarılır. Belli bir tanım tercihi tam açık değildir. Olası bir tercih, bir devredeki iletim hattının spesifik kullanımına göre bir tanımın kullanılmasıdır. Yarık hat ve eş düzlemsel dalga kılavuzu gibi yarıklar içeren iletim hattı genel tanımı, güç ve voltaja dayanmaktadır. Örneğin, Şekil 2.3 (a)'da gösterilen eş düzlemsel dalga kılavuzu güç ve güç ile eşitlik (2.10)'dan elde edilebilir.

$$V_{0} = \int_{a}^{b} E_{x}(x,h) dx$$
 (2.12)

$$P_{avg} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (E_x H_y^* - E_y H_x^*) dx dy$$
(2.13)

Şekil 2.6'da gösterildiği gibi yarık hat karakteristik empedansı, eşitlik (2.10) ile tanımlanabilir. Burada güç yine eşitlik (2.13) ile verilir ve voltaj;

$$V_0 = \int_{-W/2}^{W/2} E_x(x,h) dx$$
(2.14)

olarak elde edilir. Yarıksız diğer iletim hatları için akım ve güce ve voltaj ve akıma dayalı tanımlar kullanılmaktadır. Şekil 2.2'de gösterilen mikroşerit hat durumu için, akım, voltaj ve güç;

$$I_0 = \int_{-W/2}^{W/2} J_z(x,h) dx$$
(2.15)

$$V_0 = -\int_0^h E_y dy$$
 (2.16)

$$P_{avg} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (E_{x} H_{y}^{*} - E_{y} H_{x}^{*}) dx dy$$
(2.17)

olarak verilir. Buradaki J_z , z yönü boyunca şerit üzerindeki akım yoğunluğudur.

2.3 Mikroşerit Hat

Mikroşerit hat ilk olarak 1952'de önerildi ve o tarihten bu yana, belki de en iyi bilinen ve RF ve mikrodalga IC'ler için en yaygın kullanılan düzlemsel iletim hattıdır. Bu popülerlik ve yaygın kullanımı, düzlemsel niteliği, fotolitografik işlemler kullanılan yapım kolaylığı, katı-durumlu cihazlarla kolay entegrasyonu, iyi ısı azalması, iyi mekanik destek ve geniş tasarım bilgilerinden dolayıdır. Şekil 2.2'de gösterildiği gibi sıfır şerit kalınlığı (*t*=0) verildiği varsayımı ile, bir mikroşerit hattın efektif dielektrik sabiti, ε_{eff} ve karakteristik empedansı, Z_{θ} için kapalı form ifadeleri;

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_{r+1}}{2} + \frac{\varepsilon_{r-1}}{2} \left(1 + 10 \frac{h}{W} \right)^{-B}$$
(2.18)

$$Z_{0} = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \ln \left[\frac{h}{W} A + \sqrt{1 + \left(\frac{2h}{W}\right)^{2}} \right]$$
(2.19)

olarak verilir. Buradaki A ve B sabitleri eşitlik (2.20) ve (2.21)'den hesaplanır.

$$A = 6 + (2\pi - 6) \exp\left[-\left(\frac{30.666h}{W}\right)^{0.7528}\right]$$
(2.20)

$$B = 0.564x \begin{cases} 1 + \frac{1}{49} \ln \left(\frac{\left((W/h)^4 + (W/52h)^2 \right)}{\left((W/h)^4 + 0.432 \right)} \right) \\ + \frac{1}{18.7} \ln \left[1 + \left(\frac{W}{18.1h} \right)^3 \right] \end{cases} \begin{cases} x \left(\frac{\varepsilon_r - 0.9}{\varepsilon_r + 3} \right)^{0.053} \end{cases}$$
(2.21)

Eşitlik (2.18)'den elde edilen efektif dielektrik sabitlerinin doğruluğu $\varepsilon_r \le 128$ ve $0.01 \le W/h \le 100$ için %0.2'den daha iyidir. Karakteristik empedans için maksimum hatalar, sırasıyla $W/h \le 1$ ve 1000 için %0.01 ve %0.03'tür.



Şekil 2.2 Mikroşerit hat kesiti

Normalize şerit eni *W/h*, karakteristik empedans ve rölatif dielektrik sabitinden de bulunabilir.

$$\frac{W}{h} = \begin{cases} \frac{8 \exp(C)}{\exp(2C) - 2}, \Leftrightarrow \frac{W}{h} \le 2\\ \frac{2}{\pi} \left[D - 1 - \ln(2D - 1) + \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{2\varepsilon_r}\right) x \left(\ln(D - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\varepsilon_r}\right) \right], \Leftrightarrow \frac{W}{h} \ge 2 \end{cases}$$
(2.22)

Buradaki C ve D sabitleri eşitlik (2.23) ve (2.24)'den hesaplanır.

$$C = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\varepsilon_r + 1}{2}} + \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{\varepsilon_r} \right)$$
(2.23)

$$D = \frac{60\pi^2}{Z_0 \sqrt{\varepsilon_r}}$$
(2.24)

Pratik mikroşerit hattı, sonlu şerit kalınlığı t'ye sahiptir ve etkisi, şerit enini arttırmaktır. Eşitlik (2.18) ve (2.19), daha doğru sonuçlar için t'yi dikkate almak için değiştirilebilir.

$$\varepsilon_{eff}(t) = \left[\frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left(1 + \frac{10h}{W_e}\right)^{-B_r}\right] \frac{Z_0(t', \varepsilon_r = 1)}{Z_0(t, \varepsilon_r = 1)}$$
(2.25)

$$Z_0(t) = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{eff}(t)}} \ln \left[\frac{h}{W_e} A_t + \sqrt{1 + \left(\frac{2h}{W_e}\right)^2} \right]$$
(2.26)

Buradaki,

$$A_{t} = 6 + (2\pi - 6) \exp\left[-\left(\frac{30.666h}{W_{e}}\right)^{0.7528}\right]$$
(2.27)

$$B_{t} = 0.564x \begin{cases} 1 + \frac{1}{49} \ln \left(\frac{(W_{e}/h)^{4} + (W_{e}/52h)^{2}}{(W_{e}/h)^{4} + 0.432} \right) \\ + \frac{1}{18.7} \ln \left[1 + \left(\frac{W_{e}}{18.1h} \right)^{3} \right] \end{cases} x \left(\frac{\varepsilon_{r} - 0.9}{\varepsilon_{r} + 3} \right)^{0.053}$$
(2.28)

$$W_e = W + \Delta W \tag{2.29}$$

$$\Delta W = \frac{\Delta W'}{2} \left(1 + \frac{1}{\cosh(\sqrt{\varepsilon_r - 1})} \right)$$
(2.30)

$$\Delta W' = \frac{t}{\pi} \ln \left(1 + \frac{4 \exp(1)}{\left(t/h\right) \coth^2\left(\sqrt{6.517\frac{W}{h}}\right)} \right)$$
(2.31)

$$W' = W + \Delta W' \tag{2.32}$$

olarak verilir.

 $Z_{\theta}(t, \varepsilon_{r=1})$ ve $Z_{\theta}(t', \varepsilon_{r=1})$, eşitlik (2.26)'dan $\varepsilon_{eff}(t) = 1$ ve W_e 'den elde edilen karakteristik empedanslar olup sırasıyla eşitlik (2.29) ve (2.32) ile elde edilir.

Tipik mikrodalga dielektrik tabanları, **0.5**, **1** ve **2** oz **(28.3 gram)**'da olarak bakıra sahiptir. Bu da, **0.0007**, **0.00014** ve **0.0028** inç kalınlıklara karşılık gelmektedir.

Frekansa bağlı efektif dielektrik sabiti ve karakteristik empedanslar aşağıdaki gibi bulunabilir.

$$\varepsilon_{eff}(f) = \varepsilon_r - \frac{\varepsilon_r - \varepsilon_{eff}(0)}{1 + G(f/f_p)^2}$$
(2.33)

$$Z_0(f) = Z_0(0) \frac{\varepsilon_{eff}(f) - 1}{\varepsilon_{eff}(0) - 1} \sqrt{\frac{\varepsilon_{eff}(0)}{\varepsilon_{eff}(f)}}$$
(2.34)

Burada,

$$f_p = \frac{Z_0(0)}{2\mu_0 h}$$
(2.35)

$$G = \frac{\pi^2}{12} \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_{eff}(0)} \sqrt{\frac{Z_0(0)}{60}}$$
(2.36)

olarak verilir.

 $\varepsilon_{eff}(\theta)$ ve $Z_{\theta}(\theta)$, sırasıyla quasi-statik efektif dielektrik sabiti ve karakteristik empedansıdır ve $\mu_{\theta} = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, serbest boşluk manyetik geçirgenliğidir.

İletim hattı için, mikroşerit hattaki kayıp, mükemmel olmayan iletkenler ve dielektrikten dolayıdır ve zayıflama sabiti $\alpha = \alpha_{c+}\alpha_{d}$ ile karakterizedir. Burada α_{c} ve α_{d} sırasıyla iletken ve dielektrik zayıflama sabitleridir ve α_{c} (**dB/cm cinsinden**) aşağıdaki gibi bulunabilir.

 $0 < W/h \le 1/2\pi$ için,

$$\alpha_{c} = \frac{8.68Rs}{2\pi Z_{0}h} x \left[1 - \left(\frac{W_{e}}{4h}\right)^{2} \right] x \left\{ 1 + \frac{h}{W_{e}} + \frac{h}{\pi W_{e}} \left[\ln\left(\frac{4\pi W}{t}\right) + \frac{t}{W} \right] \right\}$$
(2.37)

 $1/2\pi < W/h \le 2$ için,

$$\alpha_c = \frac{8.68Rs}{2\pi Z_0 h} x \left[1 - \left(\frac{W_e}{4h}\right)^2 \right] x \left\{ 1 + \frac{h}{W_e} + \frac{h}{\pi W_e} \left[\ln\left(\frac{2h}{t}\right) + \frac{t}{h} \right] \right\}$$
(2.38)

 $2 \leq W/h$ için,

$$\alpha_{c} = \frac{8.68Rs}{Z_{0}h} x \left\{ 1 + \frac{h}{W_{e}} + \frac{h}{\pi W_{e}} \left[\ln\left(\frac{2h}{t}\right) - \frac{t}{h} \right] \right\}$$

$$x \left(\frac{W_{e}}{h} + \frac{W_{e}/\pi h}{W_{e}/2h + 0.94} \right) x \left[\frac{W_{e}}{h} + \frac{2}{\pi} \ln\left(\frac{W_{e}}{2h} + 0.94\right) \right]^{-2}$$
(2.39)

Burada $\mathbf{R}_s = \sqrt{\omega \mu_0 / 2\alpha}$, σ iletkenlikli iletkenin yüzey direncidir. W_e , şerit sonlu metalizasyon kalınlığı dikkate alınarak eşitlik (2.29), efektif şerit genişliğidir ve α_d aşağıdaki eşitlikten bulunabilir.

$$\alpha_{d} = \frac{27.3\varepsilon_{r}(\varepsilon_{eff} - 1)\tan\delta}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}(\varepsilon_{r} - 1)\lambda_{0}} \quad (\mathbf{dB/m})$$
(2.40)

Burada *tan* δ , dielektrik kayıp tanjantı ve λ_0 serbest boşluk dalga boyudur. Düzlemsel iletim hatları için dielektrik kayıp, dielektriklerin silikon gibi düşük dirençli yarı iletken olması durumu hariç, normal olarak iletken kaybından düşüktür.

2.4 Eş Düzlemsel Dalga Kılavuzu (CPW)

Eş düzlemsel dalga kılavuzu ilk olarak 1969 yılında ileri sürüldü. O tarihten bu yana, RF ve mikrodalga IC'ler, bir çok çekici özelliği nedeniyle (devre elemanlarının toprağa bağlantısında deliklerin eliminasyonu, katı durumlu aygıtlarla kolay entegrasyon, kompak balanslı devrelerin kolay sağlanması ve hatlar arasında çapraz konulmanın azalması gibi) hızla yaygın kullanım özelliği kazanmıştır. Şekil 2.3, klasik ve iletken destekli eş düzlemsel dalga kılavuzu kesitlerini göstermektedir. Sıfır kalınlıklı iletim hatları efektif dielektrik sabiti ve karakteristik empedans için kapalı form ifadeleri, *Konform dönüşüm metodu* esasları kullanılarak çıkarılmıştır.





Klasik eş düzlemsel dalga kılavuzu için efektif dielektrik sabiti ve karakteristik empedans için kapalı form ifadeleri aşağıda verilmiştir.

$$\varepsilon_{eff} = 1 + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \frac{K(k')}{K(k)} \frac{K(k_1)}{K(k_1')}$$
(2.41)

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \frac{K(k')}{K(k)}$$
(2.42)

Burada,

$$k = \frac{a}{b} \tag{2.43}$$

$$k' = \sqrt{1 - k^2} \tag{2.44}$$

$$k_1 = \frac{\sinh(\pi a/2h)}{\sinh(\pi b/2h)}$$
(2.45)

$$k_1' = \sqrt{1 - k_1^2} \tag{2.46}$$

olarak verilir.

K değerleri integral veya cetvele geçirilmiş tablolardan bulunabilen birinci tür komple integralidir. K(k)/(K(k')) oranı eşitlik (2.47) ile yaklaşık olarak bulunabilir.

$$\frac{K(k)}{K(k')} = \begin{cases} \frac{\pi}{\ln\left(2\frac{1+\sqrt{k'}}{1-\sqrt{k'}}\right)}, \Leftrightarrow 0 \le k \le 0.707\\ \frac{1}{\pi}\ln\left(2\frac{1+\sqrt{k}}{1-\sqrt{k}}\right), \Leftrightarrow 0.707 \le k \le 1 \end{cases}$$
(2.47)

İletken destekli eş düzlemsel dalga kılavuzu için efektif dielektrik sabiti ve karakteristik empedans, aşağıdaki eşitliklerden bulunabilir.

$$\varepsilon_{eff} = \frac{1 + \varepsilon_r \frac{K(k')}{K(k)} \frac{K(k_1)}{K(k_1')}}{1 + \frac{K(k')}{K(k)} \frac{K(k_1)}{K(k_1')}}$$
(2.48)

$$Z_{0} = \frac{60\pi}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \frac{1}{\frac{K(k)}{K(k')} + \frac{K(k_{1})}{K(k_{1}')}}$$
(2.49)

Burada,

$$k = \frac{a}{b} \tag{2.50}$$
$$k' = \sqrt{1 - k^2} \tag{2.51}$$

$$k_1 = \frac{\tanh(\pi a/2h)}{\tanh(\pi b/2h)}$$
(2.52)

$$k_1' = \sqrt{1 - k_1^2} \tag{2.53}$$

olarak verilir.

Merkez şerit ve toprak düzlemleri t kalınlığı değerlendirildiğinde, şerit genişlikleri ve açıklıklar etkin olarak sırası ile artar ve azalır. Efektif dielektrik sabiti ve karakteristik empedans, bu etki dikkate alınarak, eşitlik (2.54) ve (2.55)'den bulunabilir.

$$\varepsilon_{eff}(t) = \varepsilon_{eff} - \frac{0.7(\varepsilon_{eff} - 1)\frac{t}{b-a}}{\frac{K(k)}{K(k')} + 0.7\frac{t}{b-a}}$$
(2.54)

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_{eff}(t)}} \frac{K(k_e')}{K(k_e)}$$
(2.55)

Yukarıdaki sabit değerler aşağıdaki eşitliklerden bulunmaktadır.

$$k_e = \frac{S_e}{S_e + 2W_e} \tag{2.56}$$

$$k_e' = \sqrt{1 - k_e^2}$$
(2.57)

$$S_e = 2a + \Delta \tag{2.58}$$

$$W_e = b - a - \Delta \tag{2.59}$$

$$\Delta = \frac{1.25t}{\pi} \left[1 + \ln\left(\frac{8\pi a}{t}\right) \right]$$
(2.60)

Klasik eş düzlemsel dalga kılavuzu için iletken zayıflama sabiti aşağıdaki gibidir.

$$\alpha_{c} = \frac{4.88 \times 10^{4}}{\pi} R_{s} \varepsilon_{eff} Z_{0} P \frac{b+a}{(b-a)^{2}}$$

$$x \left\{ \frac{\frac{1.25t}{\pi} \ln\left(\frac{8\pi a}{t}\right) + 1 + \frac{1.25t}{2\pi a}}{\left[2 + \frac{2a}{b-a} - \frac{1.25t}{\pi(b-a)} \left(1 + \ln\frac{8\pi a}{t}\right)\right]^{2}} \right\}$$
(dB/m) (2.61)

Burada,

$$P = \begin{cases} \frac{k}{(1-k')(k')^{3/2}} \left[\frac{K(k)}{K(k')}\right]^2, \Leftrightarrow 0 \le k \le 0.707\\ \frac{1}{(1-k)\sqrt{k}}, \Leftrightarrow 0.707 \le k \le 1 \end{cases}$$
(2.62)

olarak verilir.

Dielektrik zayıflama sabiti ifadesi, eşitlik 2.40'da verilen mikroşerit hat sabiti ile aynıdır.

2.5 Eş Düzlemsel Şeritler (CPS)

Şekil 2.4'de gösterildiği gibi eş düzlemsel şeritlerde, dielektrik tabanın aynı tarafındaki iki paralel şerit kullanılır. Bu yapı, balanslı niteliği nedeniyle, RF ve mikrodalga IC'ler, özellikle balanslı devreler için de yararlıdır. Eş düzlemsel şerit yapısı, seri ve şönt katı durumlu aygıtlar için kolay bağlantıya olanak tanımaktadır.

Efektif dielektrik sabiti ve karakteristik empedans (sıfır şerit kalınlığı için) eşitlik (2.63) ve (2.64)'deki kapalı form eşitliklerinden bulunabilir:

$$\varepsilon_{eff} = 1 + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \frac{K(k')}{K(k)} \frac{K(k_1)}{K(k_1')}$$
(2.63)

$$Z_0 = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \frac{K(k)}{K(k')}$$
(2.64)

Burada,

$$k = \frac{a}{b} \tag{2.65}$$

$$k' = \sqrt{1 - k^2} \tag{2.66}$$

$$k_1 = \frac{\sinh(\pi a/2h)}{\sinh(\pi b/2h)} \tag{2.67}$$

$$k_1' = \sqrt{1 - k_1^2} \tag{2.68}$$

olarak verilir.





Şerit kalınlığı düşünüldüğünde efektif dielektrik sabiti ve karakteristik empedans aşağıdaki eşitlikler kullanılarak bulunabilir.

$$\varepsilon_{eff}(t) = \varepsilon_{eff} - \frac{0.7(\varepsilon_{eff} - 1)\frac{t}{a}}{\frac{K(k')}{K(k)} + 0.7\frac{t}{a}}$$
(2.69)

$$Z_0(t) = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{eff}(t)}} \frac{K(k_e)}{K(k_e')}$$
(2.70)

Burada,

$$S = b - a$$

$$k_e = \frac{S_e}{S_e + 2W_e} \tag{2.71}$$

$$k_{e}' = \sqrt{1 - k_{e}^{2}} \tag{2.72}$$

$$S_e = S - \Delta \tag{2.73}$$

$$W_e = W + \Delta \tag{2.74}$$

$$\Delta = \frac{1.25t}{\pi} \left[1 + \ln\left(4\pi \frac{b-a}{t}\right) \right]$$
(2.75)

olarak verilir.

İletken kaybından kaynaklanan zayıflama aşağıdaki gibi bulunabilir.

$$\alpha_{c} = \frac{4.34}{\pi} \frac{R_{s}}{Z_{0}} P \frac{a+b}{a^{2}} \left(\frac{\frac{1.25}{\pi} \ln\left(4\pi \frac{b-a}{t}\right) + 1 + \frac{1.25}{\pi} \frac{t}{b-a}}{\left\{1 + \frac{b-a}{a} + \frac{1.25}{2\pi} \frac{t}{a} \left[1 + \ln\left(4\pi \frac{b-a}{t}\right)\right]\right\}^{2}} \right)$$
(2.76)

Burada P, eşitlik (2.62)'de verilmiştir. Dielektrik zayıflama sabiti. eşitlik (2.40)'dan bulunabilir.

Şekil 2.5'de gösterildiği gibi şerit hat, bir koaksiyel iletim hattı baskılı devre versiyonudur. Yayılma dominant modu, mükemmel iletkenler varsayılarak saf TEM'dir. İki paralel toprak düzlemi nedeniyle yüksek frekanslarda istenmeyen paralel-plaka modlarını uyarma olasılığı nedeniyle, şerit hattı, düşük mikrodalga frekanslarda kullanıma daha fazla uygundur. Sıfır kalınlıkta şerit karakteristik empedansı aşağıdaki conformal-mapping formülleri kullanılarak bulunabilir.



Şekil 2.5 Şerit hat kesiti

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}} \frac{K(k')}{K(k)}$$
(2.77)

Burada,

$$k = \tanh\left(\frac{\pi W}{4a}\right) \tag{2.78}$$

$$k' = \sqrt{1 - k^2} \tag{2.79}$$

olarak verilir.

Sonlu şerit kalınlığı için, karakteristik empedans eşitlik (2.80) ile bulunabilir.

$$Z_{0} = \frac{30}{\sqrt{\varepsilon_{r}}} \ln \left\{ 1 + \frac{4}{\pi} \frac{2a - t}{W_{e}} \left[\frac{8}{\pi} \frac{2a - t}{W_{e}} + \sqrt{\left(\frac{8}{\pi} \frac{2a - t}{W_{e}}\right)^{2} + 6.27} \right] \right\}$$
(2.80)

Burada,

$$\frac{W_e}{2a-t} = \frac{W}{2a-t} + \frac{\Delta W}{2a-t}$$
(2.81)

$$\frac{\Delta W}{2a-t} = \frac{x}{\pi(1-x)} \left\{ 1 - \frac{1}{2} \ln \left[\left(\frac{x}{2-x} \right)^2 + \left(\frac{0.0796x}{W/2a+1.1x} \right)^m \right] \right\}$$
(2.82)

$$m = \frac{2}{1 + 2x/3(1 - x)} \tag{2.83}$$

$$x = \frac{t}{2a} \tag{2.84}$$

olarak verilir.

Şerit eni, karakteristik empedans ve rölatif dielektrik sabitinden de bulunabilir. Sıfır kalınlıklı şerit için şerit eni ifadesi eşitlik (2.77) - (2.79)'dan çıkarılabilir.

$$\frac{W}{a} = \frac{4}{\pi} \tanh^{-1}(\sqrt{p}) \tag{2.85}$$

Burada,

$$p = \begin{cases} \sqrt{1 - (e^{\pi q - 2} / e^{\pi q + 2})^4}, \Leftrightarrow q \ge 1\\ [(e^{\pi/q} - 2) / (e^{\pi/q} + 2)]^2, \Leftrightarrow 0 \le q \le 1 \end{cases}$$
(2.86)

$$q = \frac{Z_0 \sqrt{\varepsilon_r}}{30\pi} \tag{2.87}$$

olarak verilir.

Eşitlik (2.80) - (2.84) kullanılarak ve şerit kalınlığı dikkate alınarak şerit eni için aşağıdaki eşitlikler bulunabilir.

$$\frac{W}{2a-t} = \frac{W_e}{2a-t} - \frac{\Delta W}{2a-t}$$
(2.88)

$$\frac{W_e}{2a-t} = \frac{8}{\pi A} \tag{2.89}$$

$$\frac{\Delta W}{2a-t} = \frac{x}{\pi(1-x)} \left\{ 1 - \frac{1}{2} \ln \left[\left(\frac{x}{2-x} \right)^2 + \left(\frac{0.0796x}{W_e/2a+1.1x} \right)^m \right] \right\}$$
(2.90)

$$A = \frac{2B}{C} \tag{2.91}$$

$$B = \exp\left(\frac{Z_0\sqrt{\varepsilon_r}}{30}\right) - 1 \tag{2.92}$$

 $C = \sqrt{4B + 6.27} \tag{2.93}$

$$m = \frac{2}{1 + 2x/3(1 - x)} \tag{2.94}$$

$$x = \frac{t}{2a} \tag{2.95}$$

İletken zayıflama sabiti eşitlik (2.96) ile bulunabilir.

$$\alpha_{c} = \begin{cases} \frac{23.4x10^{-3}R_{s}\varepsilon_{r}Z_{0}A}{30\pi(2a-t)}, \Leftrightarrow Z_{0} < \frac{120}{\sqrt{\varepsilon_{r}}} \\ \frac{1.4R_{s}B}{2Z_{0}a}, \Leftrightarrow Z_{0} > \frac{120}{\sqrt{\varepsilon_{r}}} \end{cases}$$
(dB/m) (2.96)

Burada,

$$A = 1 + \frac{2W}{2a-t} + \frac{1}{\pi} \frac{2a+t}{2a-t} \ln\left(\frac{4a-t}{t}\right)$$
(2.97)

$$B = 1 + \frac{2a}{0.5W + 0.7t} \left(0.5 + \frac{0.414t}{W} + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{4\pi W}{t} \right)$$
(2.98)

olarak verilir. Dielektrik zayıflama sabiti eşitlik (2.99) ile verilir.

$$\alpha_d = \frac{27.3\sqrt{\varepsilon_r}\tan\delta}{\lambda_0} \quad (\mathbf{dB/m}) \tag{2.99}$$

2.7 Yarık (Slot) Hat

Şekil 2.6'da gösterildiği gibi yarık hat, RF ve mikrodalga IC'ler için de faydalıdır. Dengeli niteliği, özellikle, dengeli topoloji gerektiren devreler için çekici bir özelliktir. konvansiyonel iletim hatlarının tersine, yarık hat TEM yayılım modunu desteklemez. Yarık hat yayan modlar quasi TE₁₀ modları olup TE₁₀ tipini andırır. Dominant mod, quasi TE₁₀'dur, dikdörtgen dalga kılavuzu TE₁₀'a benzer. Yarık hat quasi TE₁₀ modun'da kesim frekansı yoktur. İyi bir iletim hattı olarak kullanılabilmesi için, yarık hat, radyasyonu minimize etmek için yüksek dielektrik sabitli bir madde kullanılarak imal edilmelidir. Öte yandan, yarık hat kullanılan bir anten, düşük dielektrik sabitli madde kullanılarak takılmalıdır.



Şekil 2.6 Yarık hat kesiti

Voltaj ve güce dayalı, karakteristik empedans kapalı form ifadeleri, Z_{θ} , ve yüksek dielektrik sabit tabanlarındaki yarık hat için dalga uzunluğu, λ_g , (9.7 $\leq \varepsilon_{eff} \leq$ 20) Cohn'un sayısal sonuçlarına uygun eğri ile elde edilmiştir. Aşağıdaki gibidir. $0.02 \le W/h \le 0.2$ için,

$$\frac{\lambda_g}{\lambda_0} = 0.923 - 0.195 \ln \varepsilon_r + 0.2 W / h - (0.126 W / h + 0.02) \ln(h/\lambda_0 x 10^2)$$
(2.100)

$$Z_{0} = 72.62 - 15.283 \ln \varepsilon_{r} + 50 \frac{(W/h - 0.02)(W/h - 0.1)}{W/h} + \ln(W/h x 10^{2})(19.23 - 3.693 \ln \varepsilon_{r})$$

$$- [0.139 \ln \varepsilon_{r} - 0.11 + W/h (0.465 \ln \varepsilon_{r} + 1.44)]$$

$$x(11.4 - 2.636 \ln \varepsilon_{r} - h/\lambda_{0} x 10^{2})^{2}$$

$$(2.101)$$

$$0.2 ≤ W/h ≤ 1.0 için,$$

$$\frac{\lambda_g}{\lambda_0} = 0.987 - 0.21 \ln \varepsilon_r + W/h(0.111 - 0.0022\varepsilon_r)$$

$$-(0.053 + 0.041W/h - 0.0014\varepsilon_r) \ln(h/\lambda_0 x 10^2)$$
(2.102)

$$Z_{0} = 113.19 - 23.257 \ln \varepsilon_{r} + 1.25W/h(114.59 - 22.531 \ln \varepsilon_{r}) + 20(W/h - 0.2)(1 - W/h) - [0.15 + 0.1 \ln \varepsilon_{r} + W/h(-0.79 + 0.899 \ln \varepsilon_{r})] x [10.25 - 2.171 \ln \varepsilon_{r} + W/h(2.1 - 0.617 \ln \varepsilon_{r}) - h/\lambda_{0} x 10^{2})]^{2}$$
(2.103)

Bu eşitlikler, sonsuz ince iletkenler varsayılarak bulunmuş ve aşağıdaki aralıklar için %2 içinde doğrudur.

$$9.7 \le \varepsilon_r \le 20 \tag{2.104}$$

$$0.01 \le \frac{h}{\lambda_0} \le \left(\frac{h}{\lambda_0}\right)_c \tag{2.105}$$

Burada (h / λ_0), TE₁₀ yüzey-dalga modu için kesim değeridir ve aşağıdaki gibidir.

$$\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)_c = 0.25\sqrt{\varepsilon_r - 1} \tag{2.106}$$

Düşük dielektrikli sabit tabanlar için karakteristik empedans ve dalga uzunluğu kapalı form ifadeleri, spektral etki alanı yöntemi sonuçları eğrisi ile çıkarılmıştır.

3. FİLTRE TASARIMI

3.1 Giriş

Filtre devreleri RF/mikrodalga mühendisliğinin birçok alanında gerekli yapım elemanlarıdır. Bu tür devreler bir sürü RF/mikrodalga sistemleri ve donanımları içerisindeki farklı frekanslardaki sinyalleri seçme/reddetme veya ayırma/birleştirmede kullanılır. RF/mikrodalga frekanslarında filtrelerin fiziksel gerçekleştirilmesi çeşitlilik gösterse de devre topolojisi hepsi için ortaktır.

Bu bölümde ilk olarak mikroşerit filtreleri içeren genel RF/mikrodalga filtrelerin tasarımı için kurma biçiminin temel kavramları ve teorileri tanımlanacaktır. Daha sonra mikrodalga filtre tasarımı metotlarından olan *Araya girme kaybı metodu* üzerinde durularak. değişik karakteristikteki filtre cevapları incelenecektir.

3.2 Transfer Fonksiyonları

3.2.1 Genel Tanımlar

Kayıpsız iki kapılı bir pasif filtre devresi Şekil 3.1'de görülmektedir.



Şekil 3.1 İki portlu devre

Bu kayıpsız pasif filtre devresinin transfer fonksiyonu; iletim katsayısı S_{21} 'in genliğinin karesi ile eşitlik (3.1)'deki gibi karakterize edilir.

$$|S_{21}(j\omega)|^{2} = \frac{1}{1 + \varepsilon^{2} F_{n}^{2}(j\omega)}$$
(3.1)

 S_{21} : İletim katsayısı

 ε : Ripple faktörü

$F_n(\omega)$: Filtrenin karakteristiğini tanımlayan fonksiyon

Doğrusal, zamanla değişmez devreler için transfer fonksiyonu; rasyonel fonksiyon olarak eşitlik (3.2)'deki gibi tanımlanabilir.

$$S_{21}(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$
(3.2)

Burada N(p) ve D(p); $p = \sigma + j\omega$ kompleks frekans değişkenine bağlı polinomlardır.

$$\left|S_{21}(j\omega)\right|^{2} + \left|S_{11}(j\omega)\right|^{2} = 1$$
(3.3)

Yansıma katsayısının genliğinin karesi eşitlik (3.3) yardımıyla eşitlik (3.4)'deki gibi bulunur.

$$\left|S_{11}(j\omega)\right|^{2} = \frac{\varepsilon^{2} F_{n}^{2}(j\omega)}{1 + \varepsilon^{2} F_{n}^{2}(j\omega)}$$
(3.4)

 S_{11} : Yansıma katsayısı

Araya girme kaybı eşitlik (3.5) ile tanımlanır.

$$L_A = 10 \log \left(\left| S_{21}(j\omega) \right|^2 \right)$$
 (dB) (3.5)

Dönme kaybı eşitlik (3.6) ile tanımlanır.

$$L_{R} = 10 \log \left(\left| S_{11}(j\omega) \right|^{2} \right) \quad (\mathbf{dB})$$
(3.6)

Eğer rasyonel bir transfer fonksiyonu elde edilebilirse filtrenin faz cevabı eşitlik (3.7) ile bulunabilir.

$$\phi_{21} = ArgS_{21}(j\omega) \tag{3.7}$$

O zaman bu devrenin grup gecikmesi eşitlik (3.8)'den hesaplanabilir.

$$\tau_d(\omega) = -\frac{d\phi_{21}(\omega)}{d\omega} \quad (\mathbf{sn}) \tag{3.8}$$

3.2.2 Kompleks Düzlemde Kutup ve Sıfırlar

Eşitlik (3.2) ile bir rasyonel transfer fonksiyonunun tanımlandığı (σ, ω) düzlemi kompleks düzlem veya p-düzlemi olarak adlandırılır. Bu düzlemin yatay ekseni reel veya σ - ekseni ve düşey ekseni sanal veya $j\omega$ ekseni olarak adlandırılır. $S_{21}(p)$ ' nin sıfırları paydaki N(p)' nin kökleri ve $S_{21}(p)$ ' nin kutupları paydadaki D(p)' nin kökleri olur.

3.2.2.1 Butterworth Cevabı

Kesim frekansı $\omega_c = 1$ de araya girme kaybı $L_{Ar} = 3.01$ dB olan Butterworh filtreler için transfer fonksiyonunun genliğinin karesi eşitlik (3.9)'da verilmektedir.

$$\left|S_{21}(j\omega)\right|^{2} = \frac{1}{1+\omega^{2N}}$$
(3.9)

N : Filtre derecesi

Butterworth filtre cevabında geçirme bandı dalgalanması düzdür yani dalgalanma olmaz. Aynı zamanda eşitlik (3.9)'daki transfer fonksiyonunun genliğinin karesi $\omega = 0$ 'da maksimum (2N-1) sayıda sıfır içermesinden dolayı bu filtreden yüksek düz olarak da bahsedilir. Bu durum ω ; kesim frekansı ω_c 'ye yaklaştıkça kötüleşir.

Şekil 3.2'de Butterworth alçak geçiren cevabı görülmektedir.



Şekil 3.2 Butterworth alçak geçiren cevabı

Rasyonel transfer fonksiyonu eşitlik (3.9)'dan elde edilebilir.

$$S_{21}(p) = \frac{1}{\prod_{i=1}^{N} (p - p_i)}$$
(3.10)

$$p_i = j \exp\left[\frac{(2i-1)\pi}{2N}\right]$$
(3.11)

 $S_{21}(p)$ 'nin sonlu frekanslı iletim sıfırları bulunmaz. Tüm sıfırlar sonsuzdadır. Kutuplar ise $|p_i| = 1$ ve $Arg(p_i = (2i-1)\pi/2N)$ olmasından dolayı Şekil 3.3'de görüldüğü gibi yarım çember üzerinde sol yarı düzlemde eşit açılarla yerlerini alırlar.



Şekil 3.3 Butterworth cevabı için kutup dağılımı

3.2.2.2 Chebyshev Cevabı

Chebyshev filtre cevabında geçme bandı dalgalanmasına izin verilir (Şekil 3.4).



Şekil 3.4 Chebyshev alçak geçiren cevabı

Chebyshev cevabı için transfer fonksiyonunun genliğinin karesi eşitlik (3.12)'de verilmektedir.

$$|S_{21}(j\omega)|^{2} = \frac{1}{1 + \varepsilon^{2} T_{N}^{2}(\omega)}$$
(3.12)

Ripple faktörü eşitlik (3.13) ile bulunur.

$$\varepsilon = \sqrt{10^{-0.1L_{Ar}} - 1} \tag{3.13}$$

L_{Ar} : Geçme bandı dalgalanması

 $T_N(\omega)$ filtrenin N derecesine göre bir Chebyshev fonksiyonudur ve eşitlik (3.14) ile tanımlanır.

$$T_{N}(\omega) = \begin{cases} \cos(N\cos^{-1}\omega) \Leftrightarrow |\omega| \le 1\\ \cosh(N\cosh^{-1}\omega) \Leftrightarrow |\omega| \ge 1 \end{cases}$$
(3.14)

Bu nedenle eşitlik (3.12)'den gerçekleştirilen filtreler genellikle Chebyshev filtreler olarak bilinir.

Rhodes eşitlik (3.12)'den hareketle Chebyshev filtre için rasyonel transfer fonksiyonunun genel bir formülünü eşitlik (3.15) olarak elde etmiştir.

$$S_{21}(p) = \frac{\prod_{i=1}^{N} [\eta^2 + \sin^2(i\pi/N)]^{1/2}}{\prod_{i=1}^{N} (p+p_i)}$$
(3.15)

Buradaki p_i ve η sırası ile eşitlik (3.16) ve eşitlik (3.17) ile tanımlanır.

$$p_{i} = j \cos \left[\sin^{-1}(j\eta) + \frac{(2i-1)\pi}{2N} \right]$$
(3.16)

$$\eta = \sinh\left(\frac{1}{N}\sinh^{-1}\frac{1}{\varepsilon}\right) \tag{3.17}$$

Butterworth filtre ile benzer olarak Chebyshev filtrede de $S_{21}(p)$ ' nin iletim sıfırlarının hepsi sonsuzda yer alır. Bunun yanında Butterworth filtreden farklı olarak Chebyhev cevabı için kutup yerleri bir elips üzerinde sol yarı düzlemdedir. Elipsin ana ekseni $j\omega$ - ekseni üzerindedir ve $\sqrt{1+\eta^2}$ ile genişletilmiştir. Diğer eksen σ -*ekseni* üzerinde ve η ile genişletilmiştir (Şekil 3.5).



Şekil 3.5 Chebyshev cevabı için kutup dağılımı

3.2.2.3 Eliptik Fonksiyon Cevabı

Eliptik fonksiyon cevabında hem geçme bandında hem de tutma bandında eşit dalgalanma olur. Bu cevap Şekil 3.6'da görülmektedir.



Şekil 3.6 Eliptik fonksiyon alçak geçiren cevabı

Bu tip cevap için transfer fonksiyonu eşitlik (3.18) ile tanımlanır.

$$|S_{21}(j\omega)|^{2} = \frac{1}{1 + \varepsilon^{2} F_{N}^{2}(\omega)}$$
(3.18)

Buradaki $F_N(\omega)$ fonksiyonu eşitlik (3.19)'da verilmektedir.

$$F_{N}(\omega) = \begin{cases} M \frac{\prod_{i=1}^{N/2} (\omega_{i}^{2} - \omega^{2})}{\prod_{i=1}^{N/2} (\omega_{s}^{2} / \omega_{i}^{2} - \omega^{2})} \Leftrightarrow N_{cift} \\ \frac{\omega \prod_{i=1}^{(N-1)/2} (\omega_{i}^{2} - \omega^{2})}{N \frac{\omega \prod_{i=1}^{(N-1)/2} (\omega_{i}^{2} - \omega^{2})}{\prod_{i=1}^{(N-1)/2} (\omega_{s}^{2} / \omega_{i}^{2} - \omega^{2})} \Leftrightarrow N_{tek} \ge 3 \end{cases}$$
(3.19)

Burada $\omega_i (0 < \omega_i < 1)$ ve $\omega_s > 1$ bazı kritik frekansları gösterir; M ve NLancaster Chapter 3 **[4-5]**'de tanımlanan sabitlerdir. $F_N(\omega)$ fonksiyonu $|\omega| \le 1$ için ± 1 arasında salınım yapar ve $|F_N(\omega = \pm 1)| = 1$ dir (Şekil 3.7).



Şekil 3.7 Eliptik rasyonel fonksiyon grafiği

3.3 Araya Girme Kaybı Metodu ile Filtre Tasarımı

Günümüzde filtre tasarımcıları devre analizi tekniğine dayanan bu metot ile birçok filtre tasarlamaktadırlar.

3.3.1. Butterworth Filtre

Genlik cevabının mümkün olabildiğince düz olmasını sağlayan orta-Q filtresi Butterworth Filtre olarak bilinir. Geçme bandının en düz olduğu ve dalgalanmanın hiç olmadığı frekans cevabı Butterworth Filtre ile elde edilebilir (C. Bowick, 1982). Butterworth filtrenin karakteristik özelliği Şekil 3.8'de görülmektedir.



Şekil 3.8 Butterworth filtre cevabı

Filtre parametrelerinin kendi içinde birbirlerine dönüşümlerinin sağlanması neticesinde farklı analiz yolları yeni paket programa uyarlanmıştır.



Şekil 3.9 Butterworth filtre alçak geçiren cevabı

 f_c ; kesim frekansı ve f_s ; istenilen araya girme kaybının meydana geldiği frekans olmak üzere normalize frekanslar;

$$\omega_c = 2\pi f_c \tag{3.20}$$

$$\omega_s = 2\pi f_s \tag{3.21}$$

olarak verilir.

Butterworth filtre için araya girme kaybı;

$$L_{As} = 10 \log \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^{2N} \right]$$
(3.22)

olarak tanımlanır.

 L_{Ar} ; geçme bandı dalgalanması olmak üzere Butterworth filtre için bu değer sabit -3 dB değerine karşılık gelir.

Ripple faktörü eşitlik (3.23)'deki gibi bulunur.

$$\varepsilon = \sqrt{10^{-0.1L_{Ar}} - 1} \tag{3.23}$$

Filtrenin yaklaşık derecesi eşitlik (3.24)'den bulunur.

$$N = ceil\left(\frac{\log(\sqrt{10^{-0.1L_{As}} - 1}) - \log(\varepsilon)}{\log\left(\frac{W_s}{W_c}\right)}\right)$$
(3.24)

Eşitlik (3.22)'ye göre farklı filtre derecelerine göre belli frekans oranlarındaki zayıflama karakteristikleri Şekil 3.10'da görülmektedir. Aynı zamanda filtrenin derecesi; oluşturulacak devrenin elaman sayısını verir.



Şekil 3.10 Butterworth filtrenin zayıflama karakteristiği

Seçicilik faktörü eşitlik (3.25)'deki gibi verilir.

$$\omega_n = \frac{f}{f_c} \tag{3.25}$$

 $\frac{J}{f_c}$; gözlenmek istenen frekansın kesim frekansına oranı

<u>Örnek 3.1</u>: Kesim frekansı 2 GHz'de olan ve 4 Ghz'de 36 dB'lik zayıflama yapması düşünülen filtrenin derecesini yani eleman sayısını bulalım. Son olarak da alçak geçiren filtrenin prototip eleman değerlerini bularak devresini gerçekleyelim.

<u>Çözüm :</u>

İlk başta seçicilik faktörü ω_n oranının bulunması gerekir. Bunu da $\frac{\omega}{\omega_c}$ oranından veya f/f_c oranı yardımıyla bulabiliriz.

$$w_n = \frac{f}{f_c} = \frac{4GHz}{2GHz} = 2$$

Yani 36 dB'lik zayıflamaya kesim frekansının 2 katında ulaşılır. Bir önceki grafiğe bakılarak 6. dereceden bir filtre devresinin istenilen zayıflamayı sağlayacağı görülür (Bkz. Şekil 3.10). Burada frekans ekseni ω/ω_c ile normalize edilerek grafiğin kesim frekansının -3dB den başlamış olduğu görülecektir. Mathcad analizi sonucundaki grafik Şekil 3.11'de görülmektedir.



Şekil 3.11 Örnek 3.1'deki Butterworth filtrenin iletim ve yansıma karakteristiğinin Mathcad program görüntüsü

1 Ohm'luk giriş ve çıkış yükleri arasında olan Butterworth filtre devresinin prototip değerlerini bulalım.

g_k ; k'nıncı prototip eleman ve

N; filtrenin derecesi olmak üzere prototip değerler eşitlik (3.26)'dan bulunur.

$$g_k = 2\sin\left(\frac{2k-1}{2N}\pi\right), \quad k = 1, 2, ..., N$$
 (3.26)

Prototip devre Şekil 3.12 ve Şekil 3.13'de görüleceği üzere iki farklı şekilde olur.



Şekil 3.12 İlk elemanı kapasitans olan prototip devre



Şekil 3.13 İlk elemanı indüktans olan prototip devre

Örnek 3.1'de bulunan prototip eleman değerleri ilk eleman kapasitans olacak şekilde Şekil 3.14'de gösterilmiştir.



Şekil 3.14 İlk elemanı kapasitans olan 6. dereceden Butterworth alçak geçiren filtre prototip devresi

Örnek 3.1'de gerçekleştirilen istenilen özelliklerdeki filtre tasarımı; yapılan paket programla da gerçeklenerek alçak geçiren prototip eleman değerleri bulunmuştur (Bkz. Bölüm 4).

1-9 arası derecedeki Butterworth alçak geçiren filtre için prototip eleman değerleri Tablo 3.1'de görülmektedir.

Tablo 3.1 1-9 arası derecelerdeki Butterworth alçak-geçiren filtrenin prototip eleman değerleri (g₀=1.0, w_c=1, LAr=3.01 dB)

Ν	g 1	g ₂	g ₃	g ₄	g 5	g 6	\mathbf{g}_7	g ₈	g 9	g ₁₀
1	2.0000	1.0								
2	1.4142	1.4142	1.0							
3	1.0000	2.0000	1.0000	1.0						
4	0.7654	1.8478	1.8478	0.7654	1.0					
5	0.6180	1.6180	2.0000	1.6180	0.6180	1.0				
6	0.5176	1.4142	1.9318	1.9318	1.4142	0.5176	1.0			
7	0.4450	1.2470	1.8019	2.0000	1.8019	1.2470	0.4450	1.0		
8	0.3902	1.1111	1.6629	1.9616	1.9616	1.6629	1.1111	0.3902	1.0	
9	0.3473	1.0000	1.5321	1.8794	2.0000	1.8794	1.5321	1.0000	0.3473	1.0

3.3.2 Chebyshev Filtre

Bir çeşit yüksek-Q filtreleri olan Chebyshev filtreleri;

-söndürme bandında dik iniş istenildiğinde,

-geçme bandının düz olmasının gerekli olmadığı durumlarda kullanılır.

Bu filtre cevabında geçme bandı dalgalanmasına izin verilir. Butterworth cevabına oranla söndürme bandındaki başlangıç inişleri daha keskindir. İki filtre cevabı arasındaki karşılaştırma Şekil 3.15'de gösterilmiştir. Şekil 3.15'deki grafik görüntüsü 3. dereceden filtreler içindir. Chebyshev filtresi geçme bandında 3 dB'lik dalgalanma yapmaktadır. Chebyshev filtresi söndürme bandında Butterworth filtresinden 10 dB kadar daha fazla zayıflama yapar (C. Bowick, 1982).



Şekil 3.15 3.dereceden filtre için Chebyshev ve Butterworth cevaplarının karşılaştırılması

Chebyshev filtresi için araya girme kaybı;

$$L_{As} = 10\log[1 + \varepsilon^2 T_N^{-2}(x)]$$
(3.27)

olarak tanımlanır.

Ripple faktörü eşitlik (3.28)'de tanımlanmıştır.

$$\varepsilon = \sqrt{10^{-0.1L_{Ar}} - 1} \tag{3.28}$$

 L_{Ar} : Geçme bandı dalgalanması

Eşitlik (3.27)' deki $T_N(x)$ Chebyshev polinomudur ve eşitlik (3.29) ile tanımlanır.

$$T_N(x) = \cos(N\cos^{-1}x)$$
 (3.29)

Eşitlik (3.29)'dan hareket edilerek genel bir formüle ulaşılabilir.

$$T_0(x) = 1$$
 (3.30)

$$T_1(x) = x \tag{3.31}$$

$$T_N(x) = 2xT_{N-1}(x) - T_{N-2}(x)$$
(3.32)

Filtre derecesinin 1-14 arası değerlerde olması durumundaki Chebyshev polinomları; eşitlik (3.32) yardımıyla çıkarılarak Tablo 3.2'de gösterilmiştir.

Ν	Chebyshev Polinomları
1	x
2	$2x^2 - 1$
3	$4x^3 - 3x$
4	$8x^4 - 8x^2 + 1$
5	$16x^5 - 20x^3 + 5x$
6	$32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1$
7	$64x^7 - 112x^5 + 56x^3 - 7x$
8	$128x^8 - 256x^6 + 160x^4 - 32x^2 + 1$
9	$256x^9 - 576x^7 + 432x^5 - 120x^3 + 9x$
10	$512x^{10} - 1280x^8 + 1120x^6 - 400x^4 + 50x^2 - 1$
11	$1024x^{11} - 2816x^9 + 2816x^7 - 1232x^5 + 220x^3 - 11x$
12	$2048x^{12} - 6144x^{10} + 6912x^8 - 3584x^6 + 840x^4 - 72x^2 + 1$
13	$4096x^{13} - 13312x^{11} + 16640x^{9} - 9984x^{7} + 2912x^{5} - 364x^{3} + 13x$
14	$8192x^{14} - 28672x^{12} + 39424x^{10} - 26880x^8 + 9408x^6 - 1568x^4 + 98x^2 - 1$

Tablo 3.2 Farklı dereceler için Chebyshev polinomları

<u>Örnek 3.2</u>: Geçme bandında 0.1 dB'lik dalgalanma yapan; kesim frekansı 3.16 GHz olan ve 5 Ghz'de 40 dB'lik zayıflama yapması düşünülen 7. dereceden Chebyshev filtrenin prototip değerlerini bularak devresini gerçekleyelim.

Önce eşitlik (3.27) kullanılarak ε ripple faktörü hasaplanır. Eşitlik (3.26)'da T_N yalnız bırakılarak eşitlik (3.33) elde edilir.

$$T_{N} = \sqrt{\frac{10^{-0.1L_{As}} - 1}{\varepsilon}}$$
(3.33)

$$\omega n = \frac{f}{f_c} = \frac{5}{3.16} = 1.582$$

C(N, wn): Filtre derecesine göre ωn 'e bağlı Chebyshev polinom değeri

Filtrenin derecesini bulabilmek için aşağıdaki döngü kurulur.

$$N := \text{ for } i \in 1...n$$

break if $C(i, wn) > T_N$
i+1 (3.34)

Buradan filtrenin derecesi bulunarak aşağıdaki eşitliklerle birlikte prototip değerlere geçiş yapılır.

$$\beta = \ln\left(\left|\operatorname{coth}\left(\frac{L_{Ar}}{17.37}\right)\right|\right) \tag{3.35}$$

$$\gamma = \sinh\!\left(\frac{\beta}{2N}\right) \tag{3.36}$$

$$a_k = \sin\left(\frac{2k-1}{2N}\pi\right) \tag{3.37}$$

$$b_k = \gamma^2 + \sin\left(\frac{k\pi}{N}\right)^2 \tag{3.38}$$

$$g_0 = 1$$
 (3.39)

$$g_{k} = \frac{4a_{k-1}a_{k}}{b_{k-1}g_{k-1}}$$
(3.40)

g_k ; k'nıncı prototip eleman

$$g_{N+1} = \begin{cases} 1 \Leftrightarrow N_{tek} \\ \operatorname{coth} \left(\frac{\beta}{4}\right)^2 \Leftrightarrow N_{cift} \end{cases}$$
(3.41)

Örnek 3.2 için çözüme devam edilirse; eşitlik (3.34) kullanılarak filtrenin derecesi 7 olarak belirlenir. Daha sonra eşitlik (3.35) - (3.41) arasındaki denklemler kullanılarak prototip devre eleman değerleri bulunur. Bulunan eleman değerleri Şekil 3.16'da gösterilmiştir.

Örnek 3.2'de gerçekleştirilen istenilen özelliklerdeki filtre tasarımı; yapılan paket programla da gerçeklenerek alçak geçiren prototip eleman değerleri bulunmuştur (Bkz. Bölüm 4).



Şekil 3.16 İlk elemanı kapasitans olan 7. dereceden Chebyshev alçak geçiren filtre prototip devresi

Geçme bandındaki değişik dalgalanma seviyeleri için 1-9 arası filtre derecelerindeki Chebyshev alçak geçiren filtrenin prototip eleman değerleri Tablo 3.3, Tablo 3.4, ve Tablo 3.5'de verilmektedir. Yapılan paket programda sonuçlar doğrulanmıştır.

Ν	g 1	\mathbf{g}_2	g ₃	\mathbf{g}_4	g 5	\mathbf{g}_6	\mathbf{g}_7	\mathbf{g}_8	g 9	g ₁₀
1	0.0960	1.0								
2	0.4489	0.4078	1.1008							
3	0.6292	0.9703	0.6292	1.0						
4	0.7129	1.2004	1.3213	0.6476	1.1008					
5	0.7563	1.3049	1.5773	1.3049	0.7563	1.0				
6	0.7814	1.3600	1.6897	1.5350	1.4970	0.7098	1.1008			
7	0.7970	1.3924	1.7481	1.6331	1.7481	1.3924	0.7970	1.0		
8	0.8073	1.4131	1.7825	1.6833	1.8529	1.6193	1.5555	0.7334	1.1008	
9	0.8145	1.4271	1.8044	1.7125	1.9058	1.7125	1.8044	1.4271	0.8145	1.0

Tablo 3.3 1-9 arası derecelerdeki Chebyshev alçak geçiren filtrenin prototip eleman değerleri (g₀=1.0, w_c=1, L_{Ar}=0.01 dB)

Tablo 3.4 1-9 arası derecelerdeki Chebyshev alçak geçiren filtrenin prototip eleman değerleri (g₀=1.0, w_c=1, L_{Ar}=0.04321 dB)

Ν	g 1	g ₂	g ₃	g ₄	g 5	\mathbf{g}_6	\mathbf{g}_7	g ₈	g 9	g ₁₀
1	0.2000	1.0								
2	0.6648	0.5445	1.2210							
3	0.8516	1.1032	0.8516	1.0						
4	0.9314	1.2920	1.5775	0.7628	1.2210					
5	0.9714	1.3721	1.8014	1.3721	0.9714	1.0				
6	0.9940	1.4131	1.8933	1.5506	1.7253	0.8141	1.2210			
7	1.0080	1.4368	1.9398	1.6220	1.9398	1.4368	1.0080	1.0		
8	1.0171	1.4518	1.9967	1.6574	2.0237	1.6107	1.7726	0.8330	1.2210	
9	1.0235	1.4619	1.9837	1.6778	2.0649	1.6778	1.9837	1.4619	1.0235	1.0

Tablo 3.5 1-9 arası derecelerdeki Chebyshev alçak geçiren filtrenin prototip eleman değerleri (g₀=1.0, w_c=1, L_{Ar}=0.1 dB)

Ν	g 1	g ₂	g ₃	\mathbf{g}_4	g 5	\mathbf{g}_{6}	\mathbf{g}_7	g 8	g 9	g ₁₀
1	0.3052	1.0								
2	0.8431	0.6220	1.3554							
3	1.0316	1.1474	1.0316	1.0						
4	1.1088	1.3062	1.7704	0.8181	1.3554					
5	1.1468	1.3712	1.9750	1.3712	1.1468	1.0				
6	1.1681	1.4040	2.0562	1.5171	1.9029	0.8618	1.3554			
7	1.1812	1.4228	2.0967	1.5734	2.0967	1.4228	1.1812	1.0		

8	1.1898	1.4346	2.1199	1.6010	2.1700	1.5641	1.9945	0.8778	1.3554	
9	1.1957	1.4426	2.1346	1.6167	2.2054	1.6167	2.1346	1.4426	1.1957	1.0

3.3.3 Eliptik Filtre

Eliptik fonksiyon alçak geçiren filtre prototipi için sıklıkla kullanılan iki devre yapısı Şekil 3.17'de görülmektedir.



Şekil 3.17 Eliptik filtre alçak geçiren prototipleri (a) seri paralel rezonans devreleri ile(b) paralel seri rezonans devreleri ile

Butterworth ve Chebyshev prototip alçak geçiren filtrelerin aksine Eliptik prototip alçak geçiren filtrelerin eleman değerlerini belirlemede basit elde edilebilir bir formül yoktur.

N	ws	$L_{As}(dB)$	\mathbf{g}_1	\mathbf{g}_2	\mathbf{g}_2 '	\mathbf{g}_3	\mathbf{g}_4	g ₄ '	g 5	\mathbf{g}_6	g ₆ '	\mathbf{g}_7
3	1.4493	13.5698	0.7427	0.7096	0.5412	0.7427						
	1.6949	18.8571	0.8333	0.8439	0.3252	0.8333						
	2.0000	24.0012	0.8949	0.9375	0.2070	0.8949						
	2.5000	30.5161	0.9471	1.0173	0.1205	0.9471						
4	1.2000	12.0856	0.3714	0.5664	1.0929	1.1194	0.9244					
	1.2425	14.1259	0.4282	0.6437	0.8902	1.1445	0.9289					
	1.2977	16.5343	0.4877	0.7284	0.7155	1.1728	0.9322					
	1.3962	20.3012	0.5675	0.8467	0.5261	1.2138	0.9345					
	1.5000	23.7378	0.6282	0.9401	0.4073	1.2471	0.9352					
	1.7090	29.5343	0.7094	1.0688	0.2730	1.2943	0.9348					
	2.0000	36.0438	0.7755	1.1765	0.1796	1.3347	0.9352					
5	1.0500	13.8785	0.7081	0.7663	0.7357	1.1276	0.2014	4.3812	0.0499			
	1.1000	20.0291	0.8130	0.9242	0.4934	1.2245	0.3719	2.1350	0.2913			
	1.1494	24.5451	0.8726	1.0084	0.3845	1.3097	0.4991	1.4450	0.4302			
	1.2000	28.3031	0.9144	1.0652	0.3163	1.3820	0.6013	1.0933	0.5297			
	1.2500	31.4911	0.9448	1.1060	0.2694	1.4415	0.6829	0.8827	0.6040			
	1.2987	34.2484	0.9681	1.1366	0.2352	1.4904	0.7489	0.7426	0.6615			
	1.4085	39.5947	1.0058	1.1862	0.1816	1.5771	0.8638	0.5436	0.7578			
	1.6129	47.5698	1.0481	1.2416	0.1244	1.6843	1.0031	0.3540	0.8692			
	1.812	54.0215	1.0730	1.2741	0.0919	1.7522	1.0903	0.2550	0.9367			
	2.000	58.9117	1.0876	1.2932	0.0732	1.7939	1.1433	0.2004	0.9772			
6	1.0500	18.6757	0.4418	0.7165	0.9091	0.8314	0.3627	2.4468	0.8046	0.9986		
	1.1000	26.2370	0.5763	0.8880	0.6128	0.9730	0.5906	1.3567	0.9431	1.0138		
	1.1580	32.4132	0.6549	1.0036	0.4597	1.0923	0.7731	0.9284	1.0406	1.0214		
	1.2503	39.9773	0.7422	1.1189	0.3313	1.2276	0.9746	0.6260	1.1413	1.0273		
	1.3024	43.4113	0.7751	1.1631	0.2870	1.2832	1.0565	0.5315	1.1809	1.0293		
	1.3955	48.9251	0.8289	1.2243	0.2294	1.3634	1.1739	0.4148	1.2366	1.0316		
	1.5962	58.4199	0.8821	1.3085	0.1565	1.4792	1.3421	0.2757	1.3148	1.0342		
	1.7032	62.7525	0.9115	1.3383	0.1321	1.5216	1.4036	0.2310	1.3429	1.0350		
	1.8915	69.3063	0.9316	1.3765	0.1019	1.5771	1.4837	0.1767	1.3794	1.0358		
7	1.0500	30.5062	0.9194	1.0766	0.3422	1.0962	0.4052	2.2085	0.8434	0.5034	2.2085	0.4110
	1.1000	39.3517	0.9882	1.1673	0.2437	1.2274	0.5972	1.3568	1.0403	0.6788	1.3568	0.5828
	1.1494	45.6916	1.0252	1.2157	0.1940	1.5811	0.9939	0.5816	1.2382	0.5243	0.5816	0.4369
	1.2500	55.4327	1.0683	1.2724	0.1382	1.7059	1.1340	0.4093	1.4104	0.7127	0.4093	0.6164
	1.2987	59.2932	1.0818	1.2902	0.1211	1.7478	1.1805	0.3578	1.4738	0.7804	0.3578	0.6759
	1.4085	66.7795	1.1034	1.3189	0.0940	1.8177	1.2583	0.2770	1.5856	0.8983	0.2770	0.7755
	1.5000	72.1183	1.1159	1.3355	0.0786	1.7569	1.1517	0.3716	1.6383	1.1250	0.3716	0.9559
	1.6129	77.9449	1.1272	1.3506	0.0647	1.8985	1.3485	0.1903	1.7235	1.0417	0.1903	0.8913
	1.6949	81.7567	1.1336	1.3590	0.0570	1.9206	1.3734	0.1675	1.7628	1.0823	0.1675	0.9231
	1.8182	86.9778	1.1411	1.3690	0.0479	1.9472	1.4033	0.1408	1.8107	1.1316	0.1408	0.9616

Tablo 3.6 1-7 arası derecelerdeki Eliptik alçak geçiren filtrenin prototip elemandeğerleri ($g_0=g_{N+1}=1$, $w_c=1$, $L_{Ar}=0.1$ dB)

3.4 Frekans ve Eleman Dönüşümleri

Bölüm 3.3'de istenilen karakteristik özelliklerdeki filtrenin prototip devre eleman değerlerinin belirlenmesi üzerinde durularak buradaki formülasyonlarla prototip filtre eleman değerleri bulunmaktadır. Bulunan değerler prototip alçak-geçiren filtre eleman değerleri olup bu değerler istenilen karakteristik özelliklerdeki filtrenin gerçek eleman değerlerine henüz dönüştürülmemiştir. Bu bölümde ise bulunan prototip eleman değerleri gerçek eleman değerlerine dönüştürülcektir.

Genel olarak filtre tasarımında izlenecek adımlar özetlenirse;

- İstenilen karakteristik özelliklerdeki filtrenin parametreleri tanımlanır. Yani; hangi frekansta ne kadar zayıflama yapılacağı, geçme bandında ne kadar dalgalanmaya izin verileceği vb.
- Bölüm 3.3'de her bir filtre için verilen formülasyonlarla prototip alçak geçiren filtre eleman değerlerine ulaşılır. Prototip alçak geçiren filtre eleman değerleri; filtrenin gerçek eleman değerlerine dönüşümde tüm filtre modelleri için temel oluşturur.
- Bulunan prototip alçak geçiren filtre eleman değerleri dönüşüm formüllerinde kullanılarak istenilen karakteristeki filtrenin gerçek eleman değerlerine dönüştürülür.

Yalnız burada belirtilmesi gereken nokta şudur: Yukarıdaki belirtilen adımların son ikisinde anlatılan direk formüllerle eleman değerlerini belirleme olayı Butterworth ve Chebyshev filtreler için mümkün olabilirken Eliptik filtreler için bu mümkün değildir. Bu durumda Eliptik filtrenin eleman değerleri giriş empedansının rasyonel fonksiyonu yardımıyla yaklaşık olarak bulunmaya çalışılır.

Gerçek devre elemanlarına geçişte ilk elemanın ne olması gerektiğine karar verilerek dönüşüm formüllerine başlanır.

Eleman alt indisleri için i=1, 3, ..., N ve j=2, 4, ..., N kullanılmıştır.

3.4.1 Alçak Geçiren Filtre Dönüşümü

Alçak geçiren filtrenin tipik iletim karakteristiği Şekil 3.18'de görülmektedir.



Şekil 3.18 Alçak geçiren filtrenin iletim karakteristiği

İlk elemanın kapasitans olması durumunda eşitlik (3.42) ve (3.43)'deki dönüşüm formülleri uygulanarak gerçek elemanlara geçilir. Şekil 3.19'da bu dönüşüm modeli görülmektedir.



Şekil 3.19 Alçak geçiren filtre için ilk elemanın kapasitans olması durumundaki eleman dönüşümü

İlk elemanın indüktans olması durumunda ise eşitlik (3.44) ve (3.45)'deki dönüşüm formülleri uygulanarak gerçek elemanlara geçilir. Şekil 3.20'de bu dönüşüm modeli görülmektedir.



Şekil 3.20 Alçak geçiren filtre için ilk elemanın indüktans olması durumundaki eleman dönüşümü

$$L_i = \frac{g_i Z_0}{w_c} \tag{3.44}$$

$$C_j = \frac{g_j}{w_c Z_0} \tag{3.45}$$

Alçak geçiren filtrede gerçek frekans dönüşümü eşitlik (3.25)'den elde edilen eşitlik (3.46) ile yapılır.

$$f = f_c \omega_n \tag{3.46}$$

3.4.2 Yüksek Geçiren Filtre Dönüşümü

Yüksek geçiren filtrenin tipik iletim karakteristiği Şekil 3.21'de görülmektedir.



Şekil 3.21 Yüksek geçiren filtrenin iletim karakteristiği

İlk elemanın kapasitans olması durumunda eşitlik (3.47) ve (3.48)'deki dönüşüm formülleri uygulanarak gerçek elemanlara geçilir. Şekil 3.22'de bu dönüşüm modeli görülmektedir.

$$L_i = \frac{Z_0}{g_i \omega_c} \tag{3.47}$$

$$C_j = \frac{1}{g_j \omega_c Z_0} \tag{3.48}$$



Şekil 3.22 Yüksek geçiren filtre için ilk elemanın kapasitans olması durumundaki eleman dönüşümü

İlk elemanın indüktans olması durumunda ise eşitlik (3.49) ve (3.50)'deki dönüşüm formülleri uygulanarak gerçek elemanlara geçilir. Şekil 3.23'de bu dönüşüm modeli görülmektedir.

$$C_i = \frac{1}{g_i \omega_c Z_0} \tag{3.49}$$

$$L_j = \frac{Z_0}{g_j \omega_c} \tag{3.50}$$



Şekil 3.23 Yüksek geçiren filtre için ilk elemanın indüktans olması durumundaki eleman dönüşümü

Yüksek geçiren filtrede gerçek frekans dönüşümü eşitlik (3.51) ile yapılır.

$$f = \frac{f_c}{\omega_n} \tag{3.51}$$
3.4.3 Band Geçiren Filtre Dönüşümü



Alçak geçiren filtreden band geçiren filtreye dönüşüm Şekil 3.24'de görülmektedir.

Şekil 3.24 Alçak geçiren filtreden band geçiren filtreye dönüşüm

Band geçiren ve band tutan filtre dönüşümü için *FBW* band genişliği parametresinin tanımlanması gerekir.



Şekil 3.25 Band geçiren filtre karakteristiği

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \tag{3.52}$$

Band genişliği FBW eşitlik (3.53) ile tanımlanır.

$$FBW = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0} \tag{3.53}$$

İlk elemanın kapasitans olması durumunda eşitlik (3.54), (3.55), (3.56) ve (3.57)'deki dönüşüm formülleri uygulanarak gerçek eleman değerlerine geçiş yapılır. Şekil 3.26' da bu dönüşüm modeli görülmektedir.

$$Cp_i = \frac{g_i}{FBW\omega_0 Z_0} \tag{3.54}$$

$$Lp_i = \frac{Z_0 FBW}{\omega_0 g_i} \tag{3.55}$$

$$Cs_{j} = \frac{FBW}{\omega_{0}g_{j}Z_{0}}$$
(3.56)

$$Ls_j = \frac{g_j Z_0}{\omega_0 FBW}$$
(3.57)



Şekil 3.26 Band geçiren filtre için ilk elemanın kapasitans olması durumundaki eleman dönüşümü

İlk elemanın indüktans olması durumunda ise eşitlik (3.58), (3.59), (3.60) ve (3.61)'deki dönüşüm formülleri uygulanarak gerçek elemanlara geçiş yapılır. Şekil 3.27'de bu dönüşüm modeli görülmektedir.

$$Cs_i = \frac{FBW}{\omega_0 g_i Z_0} \tag{3.58}$$

$$Ls_i = \frac{g_i Z_0}{\omega_0 FBW}$$
(3.59)

$$Cp_{j} = \frac{g_{j}}{\omega_{0}Z_{0}FBW}$$
(3.60)

$$Lp_{j} = \frac{Z_{0}FBW}{\omega_{0}g_{j}}$$
(3.61)



Şekil 3.27 Band geçiren filtre için ilk elemanın indüktans olması durumundaki eleman dönüşümü

Band geçiren filtrede gerçek frekans dönüşümü eşitlik (3.62) ile yapılır.

$$f = 0.5f_0 \left(\omega_n FBW + \sqrt{(\omega_n FBW)^2 + 4} \right)$$
(3.62)

3.4.3 Band Tutan Filtre Dönüşümü

Band tutan filtre karakteristiği Şekil 3.28'de görülmektedir.



Şekil 3.28 Band tutan filtre karakteristiği

İlk elemanın kapasitans olması durumunda eşitlik (3.63), (3.64), (3.65) ve (3.66)'daki dönüşüm formülleri uygulanarak gerçek elemanlara geçiş yapılır. Şekil 3.29'da bu dönüşüm modeli görülmektedir.

$$Cs_i = \frac{g_i FBW}{\omega_0 Z_0} \tag{3.63}$$

$$Ls_i = \frac{Z_0}{\omega_0 g_i FBW}$$
(3.64)

$$Cp_{j} = \frac{1}{\omega_{0}g_{j}Z_{0}FBW}$$
(3.65)

$$Lp_{j} = \frac{g_{j}Z_{0}FBW}{\omega_{0}}$$
(3.66)



Şekil 3.29 Band tutan filtre için ilk elemanın kapasitans olması durumundaki eleman dönüşümü

İlk elemanın indüktans olması durumunda ise eşitlik (3.67), (3.68), (3.69) ve (3.70)'deki dönüşüm formülleri uygulanarak gerçek elemanlara geçiş yapılır. Şekil 3.30'da bu dönüşüm modeli görülmektedir.

$$Cp_i = \frac{1}{\omega_0 g_i Z_0 FBW}$$
(3.67)

$$Lp_i = \frac{g_i Z_0 FBW}{\omega_0} \tag{3.68}$$

$$Cs_j = \frac{g_j FBW}{\omega_0 Z_0} \tag{3.69}$$

$$Ls_{j} = \frac{Z_{0}}{\omega_{0}g_{j}FBW}$$
(3.70)



Şekil 3.30 Band tutan filtre için ilk elemanın indüktans olması durumundaki eleman dönüşümü

Band tutan filtrede gerçek frekans dönüşümü eşitlik (3.71) ile yapılır.

$$f = 0.5f_0 \left(\frac{1}{\omega_n} FBW + \sqrt{\left(\frac{1}{\omega_n} FBW\right)^2 + 4} \right)$$
(3.71)

Devre sentezi, elektriksel performansı önceden belirlenmiş bir devreyi tanımlama yöntemi olarak nitelendirilebilir. Belki de devre sentezinin en çok kullanıldığı uygulama filtre tasarımıdır. Mühendislerin birçoğu öyle yada böyle açık denklemleri kullanarak veya eleman değerleri tablosunu kullanarak bir elektriksel filtre tasarlamıştır.

Bir devrenin giriş empedansı veya admitansını s-düzleminde yazabiliriz. Eleman değerlerinin elde edilmesi ve kontrolü ile ilgili sistematik bilgiler Tablo 3.7'de verilmiştir.

Eleman	Z(s) veya Y(s)	Kutup	Kontrol Z(s)	Değer
	Z(s) = sL	$Z(s) \Big _{s \to \infty}$	n > m	$L = \frac{p_n}{q_m}$
	$Y(s) = \frac{1}{sL}$	$\frac{Y(s)}{s \to 0}$	$p_0 = 0$ $q_0 > 0$	$L = \frac{p_1}{q_0}$
	$Z(s) = \frac{1}{sC}$	$Z(s) _{s \to 0}$	$p_0 > 0$ $q_0 = 0$	$C = \frac{q_1}{p_0}$
	Y(s) = sC	$Y(s) \Big _{s \to \infty}$	m > n	$C = \frac{q_m}{p_n}$
	$Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} =$	$=\frac{p_n s^n + \dots + p_2}{q_m s^m + \dots + q_2}$	$\frac{s^{2} + p_{1}s + p_{0}}{s^{2} + q_{1}s + q_{0}}$	-

Tablo 3.7 Eleman elde edilmesi ve kontrolü için sistematik

Seri indüktans ve dirençten oluşan empedans eşitlik (3.72) ile gösterilir.

 $Z(s) = sL + R \tag{3.72}$

Bu empedansa paralel bir kapasitör eklenmesi durumunda empedans admitansa çevrilerek eşitlik (3.73)'deki gibi admitans olarak toplama yapılır.

$$Y' = Y(s) + sC \tag{3.73}$$

Toparlanırsa eşitlik (3.74) elde edilir.

$$Y'(s) = \frac{s^2 L C + s R C + 1}{s L + R}$$
(3.74)

Ya da eşitlik (3.75) ile gösterilebilir.

$$Y'(s) = sC + \frac{1}{sL + R}$$
(3.75)

$$Y(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{p_n s^n + \dots + p_2 s^2 + p_1 s + p_0}{q_m s^m + \dots + q_2 s^2 + q_1 s + q_0}$$
(3.76)

$$Y(s) = sC + \frac{R(s)}{Q(s)}$$
(3.77)

Eşitlik (3.77)'de her iki taraf s ile bölünürse eşitlik (3.78) elde edilir.

$$\frac{Y(s)}{s} = C + \frac{R(s)}{sQ(s)}$$
(3.78)

 $s \rightarrow \infty$ olduğunda C elemanı eşitlik (3.79)'daki gibi yalnız kalır.

$$\frac{Y(s)}{s}\bigg|_{s \to \infty} = C \tag{3.79}$$

Y(s) polinom olarak eşitlik (3.79)'da yerine yazılırsa eşitlik (3.80) elde edilir.

$$C = \frac{P(s)}{sQ(s)} \bigg|_{s \to \infty}$$
(3.80)

<u>Örnek 3.3</u>: Empedans fonksiyonu $Z(s) = \frac{20s^4 + 6s^3 + 35s^2 + 2s + 5}{20s^3 + 6s^2 + 15s}$ olarak verilen devreyi sentezleyelim.

Devrenin eleman değerlerini bulabilmek için Tablo 3.7'den yararlanmak suretiyle işlem adımları gerçekleştirilir.

$$Z'(s) = \frac{20s^2 + 2s + 5}{20s^3 + 6s^2 + 15s}$$

$$Z''(s) = \frac{20s^2 + 2s + 5}{4s^2 + 10s}$$

$$Z^{\prime\prime\prime}(s) = \frac{10s}{2s+5}$$

Ara işlemlerin yapılması sonucunda Z(s)'e ait iki devre modeli eleman değerleriyle birlikte Şekil 3.31 ve Şekil 3.32'deki gibi çıkarılmıştır.



Şekil 3.31 İlk elemanı seri indüktans olan devre



Şekil 3.32 İlk elemanı seri kapasitans olan devre

4. YAPILAN PAKET PROGRAMIN TANITIMI

4.1 Giriş

Bu tez çalışmasında mikrodalga filtre tasarımı konusunda çalışanlara katkı sağlayabilecek yeni bir paket program yazılımı hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda literatürdeki mevcut mikrodalga filtre tasarım yöntemleri ve ilgili paket programlar incelenmiştir. Sonuç olarak, özellikle filtre tasarımının teorik detaya fazla girmeden gerçekleştirilebilmesine imkan tanıyacak şekilde, *Araya girme kaybı* metodunun kullanıldığı yeni bir paket program hazırlanmıştır. Programın en önemli özelliği, görselliği ön plana çıkarmak amacıyla hızlı, pratik ve yüksek doğrulukta hesaplama yeteneğine sahip çok sayıda formlardan oluşturulmasıdır. Formlar ardışık işlemler döngüsünde birbiri ile ilişkili olmalarına rağmen gerektiğinde birbirinden bağımsız olarak kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Paket programın kullanıma sunulması neticesinde kullanıcılardan alınacak geri dönüşümlerle programın mikrodalga mühendislerinin eksikliğini hissettikleri kapsamlı bir paket program haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Paket programın yapım aşamasında birçok zorluklarla karşılaşılmış olunmasına rağmen bu zorluklar aşılarak tez sonucunda mikrodalga mühendislerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte program oluşturulmuştur. Program 5 ayrı ana bölüm olarak tasarlanmıştır. Her bir bölümün şablonu ayrı düzenlenmiştir. Bir çember döngüsü içinde her bir bölüm kendi işlevini gerçekleştirerek çözümleri zor ve uzun zaman alıcı olan karmaşık yapıdaki mikrodalga filtre formülasyonlarının analizini arka plandaki yazılım kodları sayesinde gerçekleştirebilmektedir. Bu çember döngüsü içindeki bölümler Şekil 4.1'de gösterilmiştir.



Şekil 4.1 Program bölümlerinin çember döngüsü

Program; toplam 36 ayrı form ve sınıf yapısı içermektedir. Bu form ve sınıf yapıları görsel bir bütünlük içinde birleştirilerek paket program haline getirilmiştir. Programın yapılışında görsellik ön planda tutulmuştur. Uzun uğraşlar sonucunda gerçekleştirilen kendine özgü grafik desteği ve dosyalama özelliği ile bu program mikrodalga mühendislerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteye ulaştırılmıştır. Programın 36 ayrı form ve sınıf yapısı içermesinin getirmiş olduğu zorluklar aşılmıştır. Formların çalışma ahenginin düzenlenmesi, birbiriyle sürekli veri alışverişinde bulunarak haberleşmelerinin sağlanması, form üzerindeki değerlerin hafizada tutulması, değişen değerlerin güncellenmesi, hatalara anlık çözüm üretilmesi, kullanıcının yönlendirilmesi ve kullanıcı kolaylığının sağlanması gibi birçok zorluklar aşılarak program hedeflendiği şekliyle kullanıma sunulmuştur.

Program ilk açılışta ekrana Şekil 4.2'deki "Başlangıç" form görüntüsüyle gelir. Bu "Başlangıç" formunda programı oluşturan 5 ayrı ana bölümün seçenek butonları yer alır. Kullanıcı buradaki seçenek butonları vasıtasıyla geçmek istediği bölüme ait arayüz formuna yönlendirilir.



Şekil 4.2 "Başlangıç" form görüntüsü

Paket programın kullanımı ve özellikleri uygulamalı olarak 5 ayrı bölüm halinde verilecektir.

4.2 Filtre Analizi

"Filtre Analizi" bölümü; Uygulama 4.1, Uygulama 4.2 ve Uygulama 4.3'de yapılacak analizlerle anlatılmaya çalışılacaktır.

Uygulama 4.1 : Bu uygulama Örnek 3.1'in program uygulamasıdır (Bkz. Örnek3.1). Örnek 3.1'de verilen filtre özelliklerine göre Butterworth filtre tasarlanacağı anlaşılır. Bu nedenle "Filtre Türleri" formundan (Şekil 4.3) "Butterworth Filtre" buton seçeneği ile iki farlı analiz türü seçeneğinin yer aldığı "Analiz Türleri" formuna geçiş yapılır (Şekil 4.4).

Planar Program 2009 / Filtre A	nalizi Cuasi-Statik Analiz Grafik Analiz Yardım Görünüm
	Filtre Türleri Butterworth Filtre
	<u>Chebyshev Filtre</u>
	Geri Don

Şekil 4.3 "Filtre Türleri" form görüntüsü

Filtre Türleri Filtre Sentezi Quasi-Statik Analiz Grafik Analiz Yardım Görünüm Image: Construction of the state	🖳 Planar Program 2009 / F	iltre Analizi	
Butterworth Filtre Analiz Türleri Filtre Derecesine Göre (N) : Araya Girme Kaybına Göre (LAs) : Analiz Ana Sayla Gen Dön	Filtre Türleri Filtre Se	ntezi Quasi-Statik Analiz Grafik Analiz Yardım Görünüm	
Ana Sayfa Gen Don		 Butterworth Filtre Analiz Türleri Filtre Derecesine Göre (N) : Araya Girme Kaybına Göre (LAs) : 	
		Ana Sayfa	

Şekil 4.4 "Analiz Türleri" form görüntüsü

İki farklı analiz türünün her birinin seçilmesi durumunda gelecek olan arayüz sayfalarının ekran görüntüleri sırasıyla (Şekil 4.5) ve (Şekil 4.6)'da görülmektedir.

nanar Program 2007 / Finte Analizi tre Türleri Filtre Sentezi Quasi-Sta	ik Analiz Grafik Analiz Yardım Görünüm	
	#2 Butterworth Prototip Filtre Derecesine Göre (M) Araya Girme Kaybına Göre (LAs) U = 20 U = 20 U = 2 U = 2 U = 2	

Şekil 4.5 "Filtre Derecesine Göre" analiz sayfası görüntüsü

Şekil 4.6 "Araya Girme Kaybına" göre analiz sayfası görüntüsü

Analiz türü belirlenerek gelecek olan "Buttterworth Prototip" arayüz formundan kullanıcı filtrenin parametre girdilerini girerek analize geçebilir. Filtrenin parametre girdilerinin istenilen şekilde girilmesi kullanıcıya mesaj pencereleriyle gösterilmektedir. Yani sadece sayısal değer girilebilecek yere başka karakterlerin girişi önlenmiştir. Ayrıca muhtemel hatalar düşünülerek gerekli kontroller yapılmıştır. Bunun yanında özellikle grafik bölümünde kullanıcı hatasından kaynaklanmayan matematiksel tanımsızlıklara uzun uğraşlar sonucunda uygun çözümler bulunmuştur. Bu şekilde programın sağlıklı çalışması sağlanmıştır. Eğer girişlerde problem yoksa analiz işlemine devam edilmektedir.



Şekil 4.7 Uygulama 4.1 için analiz görüntüsü

Programda, kullanıcı tarafından girilen giriş parametrelerine göre analiz sonucunda diğer bilinmeyen parametreler bulunarak alçak geçiren prototip eleman değerleri bulunur. Daha sonra "Grafik Analiz", "Kayıt İşlemleri" ve "Gerçek Elemanlara Geçiş" butonlarından diğer uygulamalara geçilebilir (Şekil 4.8). Burada "Grafik Analiz" bölümüne geçilecek olunursa iletim ve yansıma karakteristiğinin grafiği varsayılan grafik ayarları ile (Şekil 4.9)'daki gibi elde edilir



Şekil 4.8 Uygulama 4.1 için analiz sonuçları görüntüsü



Şekil 4.9 6. dereceden Butterworth alçak geçiren filtrenin iletim ve yansıma karakteristiği görüntüsü

Kullanıcı grafiği kaydetme, büyültme, değer okuma, yazdırma, değişiklikleri geri alma gibi işlemler yapabilir (Şekil 4.10).



Şekil 4.10 Grafik üzerinde yapılabilen işlemler menüsü

İletim ve yansıma karakteristikleri için çizdirilen grafik üzerinde mavi ile gösterilmekte olan iletim karakteristiği S21(w)'nın grafiği üzerinde w=-2 değerine karşılık gelen -36 dB seviyesinin okunması Şekil 4.11'de görülmektedir.



Şekil 4.11 S21(w) grafiği üzerinde w=-2 değerine karşılık -36 dB seviyesinin okunması

Kullanıcı yeni ayarlarda bir grafik çizdirmek isterse Şekil 4.12'de görüldüğü gibi "Grafik->Yeni" menü seçeneklerini takip ederek Şekil 4.13'deki "Prototip Grafik Ayarları" formuna ulaşır.





e Grafik Prototip Grafik Görünüm	rafik Çizim Prototip yarları	
Filtre Parar N = 6 LAs = 36 LAr = 3 € = 0.99763 vm = 2 LR =	Cizim Ayarlari Eksen Ayarlari Data Ayarlari Data Ayarlari Data Sayisi	

Şekil 4.13 "Prototip Grafik Ayarları" form görüntüsü

Kullanıcı "Prototip Grafik Ayarları" formundan oluşturacağı yeni grafiğin ayarlarını (data sayısı, font ayarları, eksen ayarları vb.) yaparak yeni ayarlarıyla birlikte grafik çizimini tamamlamış olur (Şekil 4.14).



Şekil 4.14 Yeni ayarlarda elde edilen grafik görüntüsü

Programın güzel yanlarından birisi de dinamik olarak değişen değerleri kullanarak aynı anda birden fazla grafik çizdirebilmeyi mümkün kılmasıdır. Mevcut çizilmiş olan grafikler "Görünüm" menüsündeki ayarlardan düzenlenebilmektedir (Şekil 4.15). Grafiklerin düzenli hali Şekil 4.16'da görülmektedir.



Şekil 4.15 Çoklu grafik çalışma görüntüsü



Şekil 4.16 Grafiklerin "Görünüm" menüsünden düzene koyulması

Programın güzel yanlarından bir diğeri de sonradan grafik datalarının kullanılarak tekrar grafik çizdirebilme amacıyla grafiğe ait dataların kendine özgü kayıt formatıyla kaydedilmeye elverişli olmasıdır. "Butterworth Prototip" formu üzerinde iken "Kayıt İşlemleri" bölümüne geçilirse Şekil 4.17'deki ekran görüntüsü ile karşılaşılır. Burada "Normal" ve "Spesifik" kayıt olmak üzere iki farklı türde kayıt yapma özelliği bulunur.

Norr	nal Spesifik			
	Data /	lyarları	<u>Kayıt Ayarları</u>	
	<u>Data Sayısı</u> <u>201</u> <u>401</u>	<u>w Aralığı</u> <u>İlk :</u> -5 <u>Son :</u> 5	<u>Kaydedilecek Datalar :</u> ☑ w ☑ S21(w) ☑ S11(w)
	• <u>801</u> • <u>1601</u>			
		K	aydet	

Şekil 4.17 "Kayıt İşlemleri" form görüntüsü

Bu formda kullanıcı tarafından istenilen özellikte grafik ayarları yapılarak kayıt işlemine geçilirse dosyanın kayıt yapılacak yerinin ve dosya uzantısının ne olacağının sorulduğu Şekil 4.18'de görülen "Dosya Kaydet" penceresi gelir. Burada dosya adı kısmında başlangıçta varsayılan olarak programın kendine özgü uzantılı (*.plnr) olan "Filter.plnr" yer alır.



Şekil 4.18 "Dosya Kaydet" pencere görüntüsü

Programın kayıt formatına göre w, S21(w), S11(w) data dizileri, aralarında belli boşluk bırakılarak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Normal ve spesifik kayıt örnek dosyaları sırasıyla Şekil 4.19'da ve Şekil 4.20'de görülmektedir.Şekil 4.19'daki dosya kayıt formatı bu program ve diğer "Mathcad" vb. programlarda kullanılabilecek formattadır.

Filter.plnr - Not Defteri	
Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım	
Dosya Duzen Bigin Gordnum Yardim -5.000000000 -83.855776139 -0.000000018 -4.987500000 -83.725324663 -0.000000018 -4.975000000 -83.594545830 -0.000000020 -4.962500000 -83.463437993 -0.000000020 -4.95000000 -83.200228658 -0.000000021 -4.92500000 -83.068123802 -0.000000022 -4.912500000 -82.935683229 -0.000000023 -4.87500000 -82.802905227 -0.000000023 -4.87500000 -82.669788073 -0.000000023 -4.87500000 -82.266330029 -0.000000023 -4.87500000 -82.268384259 -0.000000025 -4.862500000 -82.268384259 -0.000000027 -4.82500000 -81.728324115 -0.000000027 -4.82500000 -81.728324115 -0.000000027 -4.812500000 -81.728324115 -0.000000031 -4.77500000 -81.456180742 -0.00000031 -4.775000000 -81.456180742 -0.000000032 -4.775000000	
	E. ₹

Şekil 4.19 "Filter.plnr" dosyasının ekran görüntüsü

ĺ	Filt	erSpesi	ifik.pl	nr - Ne	ot Defteri						x
	Dosya	Düze	en l	Biçim	Görünüm	Yardın	n				
	801 (Data W	içi	n 6.0	lereceden 521(w)	Butt	erworth 511(w)	Filtr	e Analiz	Sonuçları	Â
	-5.00 -4.90 -4.99 -4.99 -4.99 -4.99 -4.99 -4.99 -4.90 -4.80 -4.80 -4.88 -4.88 -4.88 -4.88 -4.88 -4.88 -4.88 -4.88	25000 250000 250000 250000 25000 250000 25000 25000 250000 2500	 000 000 000 000 000 000 000 000 000	 	85577613 72532466 59454583 46343799 33199949 20022865 06812380 93568322 80290522 66978807 53633002 40252934 26838425 13389299 99905375 86386473 72832411			L8 L9 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 20			
	-4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7	8/500 75000 62500 50000 37500 25000 12500 00000	000 000 000 000 000 000 000 000	-81. -81. -81. -81. -81. -80. -80. -80.	59243006 45618074 31957427 18260878 04528239 90759317 76953922 63111859	8 -0. 2 -0. 5 -0. 9 -0. 2 -0. 7 -0. 8 -0. L -0.	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	30 31 32 33 34 35 36 38			Ŧ
l			_			_					► at

Şekil 4.20 "FilterSpesifik.plnr" dosyasının ekran görüntüsü

Programın güzel yanlarından bir diğeri de dışarıdan grafik datası okumaya elverişli olmasıdır. Program, kendi data okuma formatına uygun her türlü uzantıdaki dosyayı okuyup değerlendirebilme yeteneğine sahiptir. Şekil 4.19'daki kaydedilen dosyanın içeriğindeki data bilgileri birkaç yerden okunabilir. Kullanıcı "Grafik Analiz", "Prototip Grafik" ve "Gerçek Grafik" formlarında bulunan "Grafik->Dosyadan Aç" menü seçeneklerini (Şekil 4.21) takip etmek suretiyle "Aç" penceresine ulaşır (Şekil 4.22).



Şekil 4.21 "Grafik->Dosyadan Aç" menü görüntüsü



Şekil 4.22 "Aç" pencere görüntüsü

Bu pencereden data bilgileri okunacak olan dosya belirlendikten sonra dosyadan okunan data bilgilerine göre grafik çizimi gerçekleştirilir (Şekil 4.23).



Şekil 4.23 "Filter.plnr" dosyasından okuma sonucu oluşan grafik görüntüsü

Buraya kadar Örnek 3.1'de istenilen özelliklerdeki filtrenin prototip eleman değerlerinin bulunması işlemi programla birlikte gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki aşama prototip eleman değerlerinden Bölüm 3'de anlatılan frekans ve eleman dönüşümleri yöntemi ile filtrenin gerçek eleman değerlerine geçiş yapılmasıdır. Bu dönüşümler için program uygulaması Örnek 3.1'in devamı niteliğinde yapılacaktır.

"Butterworth Prototip" arayüz formundaki (Bkz. Şekil 4.8) "Gerçek Elemanlara Geçiş" butonu ile, filtre seçeneklerinin yer aldığı Şekil 4.24'deki seçenek formuna geçiş yapılır. Bu formda istenilen filtre türü seçilerek bir sonraki aşamaya geçilir (Şekil 4.25).



Şekil 4.24 "Butterworth Filtre Türleri" form görüntüsü



Şekil 4.25 Butterworth "Alçak Geçiren Filtre" sayfa görüntüsü

Programın bir diğer güzel özelliği de devre tasarımı yapabilmesidir. Kullanıcı eşdeğer devrenin ilk elemanını belirledikten sonra "Devreyi Gerçekle" butonu ile devre tasarımının yapıldığı Şekil 4.26'da gösterilen "Butterworth Filtre Devresi" formuna geçiş yapacaktır. Bu formda eşdeğer devrenin eleman değerleri hem şekil üzerinde hem de liste halinde görülebilmektedir.

tterworth Filtre Devresi		iron Eiline inin analia annualan	
ilk eleman kapasita	ns ans	iren Filtre için analız sonuçları	
Prototip eleman <u>değerleri</u> g0=1 g1=0.517638 g2=1.414214 g3=1.931852 g4=1.931852 g5=1.414214 g6=0.517638 g7=1	Kapasitans değerleri (pF) C1=0.823847 C2=3.074637 C3=2.250791	İndüktans değerleri (nH) L1=5.626977 L2=7.686593 L3=2.059617	
	C2=3.074637pF		
Geri Don		Sonuçları Kaydet	Cikis

Şekil 4.26 İlk elemanı kapasite olan 6. dereceden alçak geçiren filtre prototip eşdeğer devre görüntüsü



Şekil 4.27 Butterworth "Band Geçiren Filtre" sayfa görüntüsü

Şekil 4.27'deki "Band Geçiren Filtre" sayfasından benzer işlemler uygulanıp devre tasarımına geçilecek olunursa prototip eşdeğer devre Şekil 4.28'deki gibi olacaktır.

Prototin eleman	Cinaralel	L naralel	Cseri	Lseri
değerleri	değerleri (pF)	değerleri (nH)	değerleri (pF)	değerleri (nH)
g0=1	Cp1=45.015816	Lp1=0.140674	Cs1=0.153732	Ls1=41.19233
g1=0.517638 g2=1.414214 g3=1.931852 g4=1.931852 g5=1.414214 g6=0.517638	Cp3=16.476932	Lp3=0.38433	Cs2=0.041192 Cs3=0.05627	Ls2=153.73187 Ls3=112.53954

Şekil 4.28 İlk elemanı indüktans olan band geçiren prototip eşdeğer devre görüntüsü

Kullanıcı son olarak bu formda "Sonuçları Kaydet" butonu ile gelecek olan "Sonuçları Kaydet" penceresinden kaydetme işlemi gerçekleştirebilir (Şekil 4.29).



Şekil 4.29 "Sonuçları Kaydet" pencere görüntüsü

Eğer kullanıcının verdiği dosya adı önceden mevcut ise program kullanıcıyı hata mesajı ile uyaracaktır. Diğer durumlarda ise kayıt işlemi başarıyla gerçekleştirilecektir (Şekil 4.30).

Prototip eleman değerleri	C paralel	L naralel	C	
	değerleri (nF)	değerleri (nH)	değerleri (nF)	L seri değerleri (nH)
g0=1	Cp1=45.015816	Lp1=0.140674	Cs1=0.153732	Ls1=41.19233
g1=0.517638	Cp2=61.492748	Lp2=0.102981	Cs2=0.041192	Ls2=153.73187
$g_{2}=1.414214$ $\sigma_{3}=1.931852$	Cp3=10.4/6932	Lp3=0.38433	Cs3=0.05627	Ls3=112.53954
g4=1.931852				
g5=1.414214				
g0=0.51/038 g7=1				
	Ser.	auclar bacamula kaudadik		
	501	laçıdı başarıyla kayacanı		
		Tan	nam	
÷{	÷ ₹ [I DATE DATE		
ĻS	L	LS 1		
	12000			

Şekil 4.30 "Sonuçlar başarıyla kaydedildi..." mesaj görüntüsü

Örnek kayıt dosyası Şekil 4.31'de gösterilmiştir.

👕 Sonuçlar.txt - Not Defteri	3
Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım	
6.dereceden Butterworth Band Geçiren Filtre için analiz sonuçları	~
Giriş Parametreleri	
Filtrenin derecesi (N)= 6Araya girme kaybı (LAS)= -36 dBGeçirme bandı dalgalanması (LAr)= -3 dBRipple faktörü (E)= 0.99763Kesim frekansı (fc)= 2 GHzGiriş empedansı (Zg)= 50 ohmÇıkış empedansı (Zc)= 50 ohmBand genişliği (fbw)= 0.05	
Çıkış Parametreleri	
LAs'ye karşılık gelen frekans değeri (fs) = 3.236 GHz LAs'ye karşılık gelen normalize frekans değeri (ws) = 20.332	
İlk eleman seri rezanatör	
Prototip eleman değerleri au=1	ш
g1=0.517638 g2=1.414214 g3=1.931852 g4=1.931852 g5=1.414214 g6=0.517638 g7=1	
Gerçek eleman değerleri	
Seri kapasitans değerleri	=
Cs1=0.153732pF Cs2=0.041192pF Cs3=0.05627pF	
Seri indüktans değerleri	
Ls1=41.19233nH Ls2=153.73187nH Ls3=112.53954nH	
Paralel kapasitans değerleri	
Cp1=45.015816pF Cp2=61.492748pF Cp3=16.476932pF	
Paralel indüktans değerleri	
Lp1=0.140674nH Lp2=0.102981nH Lp3=0.38433nH	
< +	

Şekil 4.31 "Sonuçlar.txt" dosyasının ekran görüntüsü

Kullanıcı prototip bölümde olduğu gibi "Butterworth Filtre" formu üzerinde de "Kayıt İşlemleri" ve "Grafik Analiz" bölümlerine geçiş yapabilmektedir. Burada diğer filtre türleri için de grafik çizimi gerçekleştirilebilir. Tek fark grafiğin artık gerçek frekans değerlerine göre çizdirilecek olmasıdır (Şekil 4.32, Şekil 4.33). Kayıt işlemleri daha önce anlatıldığı şekilde yapılır.



Şekil 4.32 Alçak geçiren filtrenin S21(w) grafiği üzerinde f(w)=4 GHz değerine karşılık gelen -36 dB seviyesinin okunması



Şekil 4.33 Butterworth band geçiren filtrenin iletim ve yansıma karakteristiği

Uygulama 4.1 ile yapılan program, detaylı bir biçimde anlatılmıştır. Bu nedenle Uygulama 4.2'de Örnek 3.2'nin hızlı bir biçimde uygulaması yapılacaktır.

Uygulama 4.2 : Bu uygulama Örnek 3.2'nin program uygulamasıdır (Bkz. Örnek 3.2). "Filtre Türleri" formundan "Chebyshev Filtre" seçilmek suretiyle Uygulama 4.1'deki benzer işlem adımları takip edilerek sonuçlara gidilir.



Şekil 4.34 Uygulama 4.2 için analiz sonuçları görüntüsü

Chebyshev alçak geçiren filtrenin iletim ve yansıma karakteristiği Şekil 4.35'de görülmektedir.







Şekil 4.36 Chebyshev "Alçak Geçiren Filtre" sayfa görüntüsü



Şekil 4.36'daki formdan "Devreyi Gerçekle" butonu ile devreye geçilir (Şekil 4.37).



<u>Uvgulama 4.3</u>: Bu uygulamada tutma bandı araya girme kaybı LAs=-30 dB'den fazla, geçme bandı dalgalanması LAr=-0.04365 dB ve seçicilik faktörü ws=1.35 olan eliptik filtre analiz edilecektir.

Şekil 4.37'deki "Eliptik Filtre Analiz Türleri" formundan analiz türü belirlenerek "Eliptik Filtre" formuna geçilir (Şekil 4.38). Buradan giriş parametreleri girilmek suretiyle analize geçilir (Şekil 4.39). Analiz sonucunda bulunan parametre değerleri Şekil 4.40'da görülmektedir.

Planar Progra	im 2009 / Filtre Analizi	
Filtre Türleri	Filtre Sentezi Quasi-Statik Analiz Grafik Analiz Yardım Görünüm	
	🖳 Eliptik Filtre Analiz Türleri	
	 Dönme Kaybına Göre (LR) : Araya Girme Kaybına Göre (LAs) : 	
	Ana Sayfa	

Şekil 4.38 "Eliptik Filtre Analiz Türleri" form görüntüsü

Eliptik Filtre Dönme Kaybına Göre (LR)	Araya Girme Kaybına	Gōre (LAs)	Giriş Parametreleri LAr = 0.04365 dB ▼ LAs = 30 dB ▼ ws = 1.35 Analiz sonuçlanıyor	
Ana Sayfa	<mark>ri Dön -</mark> Kay	ıt İşlemleri	Grafik Analiz	Cikas

Şekil 4.39 Uygulama 4.3 için analiz görüntüsü
Eliptik Filtre	
Dönme Kaybına Göre (LR) Araya Girme Kaybına C	iòre (LAs) Giriş Parametreleri LAr = 0.04365 dB • LAs = 30 dB • ws = 1.35 Analiz
	Çıkış Değerleri € = 0.10051 N = 5 LR = 19.99981 dB ▼
Ana Sayfa Geri Dön Kayıl	Işlemleri Grafik Analiz Cıkış

Şekil 4.40 Uygulama 4.3 için analiz sonuçları görüntüsü

Daha sonra rasyonel eliptik fonksiyonun kutup ve sıfırları bulunur.

Dönme Kaybına Göre (LR)	Araya Girme Kaybına Göre (LAs)	
	LAs	$\begin{tabular}{ c c c c c } \hline Giriş Parametreleri \\ LAr = 0.04365 & dB \\ \hline LAs = 30 & dB \\ \hline ws = 1.35 \\ \hline \end{tabular}$
Itetim Stiftlan 1.Stfir: 0.966862 2.Stfir: - 0.966862 3.Stfir: - 0.966862	Kutupiar. <u>Kutupiar</u> 1.Kutup : 1.396269 2.Kutup : -1.396269 3.Kutup : -1.396241	Analiz — Çıkış Değerleri € = 0.10051
3.Siff : 0.000053 4.Sifir : -0.660653 5.Sifir : 0	3.Kutup : 2.043431 4.Kutup : -2.043431 5.Kutup : Sonsuz	N = 5 LR = 19.99981 dB -

Şekil 4.41 Eliptik filtrenin kutup ve sıfırlarının bulunması



Eliptik filtrenin iletim ve yansıma karakteristiği Şekil 4.42'de görülmektedir.

Şekil 4.42 5. dereceden Eliptik filtrenin iletim ve yansıma karakteristiği görüntüsü

Kayıt işlemleri önceki bölümlerde anlatıldığı biçimde yapılır (Bkz. Uygulama 4.1).

4.3 Filtre Sentezi

"Filtre Sentezi" bölümünde sentez yoluyla prototip eleman değerleri bulunmaktadır. Bu bölüme geçildiğinde ilk olarak Şekil 4.43'deki form gelir. Daha sonra analize geçilerek filtrenin bilinmeyen diğer parametre değerleri ve prototip eleman değerleri bulunur (Şekil 4.44).

Chebyshev Sentez Prototip	
Filtre Derecesine Gore (N) Araya Girme Kaybina Góre (LAS)	Giriş Parametreleri fc = 2 GHz v fs = 2.1 GHz v N = 5 LAr = 0.5 Analiz Analiz sonuçlanıyor:
Geri Dön	

Şekil 4.43 "Chebyshev Sentez Prototip" formu analiz görüntüsü



Şekil 4.44 "Chebyshev Sentez Prototip" formu analiz sonuçları görüntüsü

Burada bulunan prototip eleman değerleri formülasyonlarla bulunmuştur. Aynı sonuçları sentez yoluyla da bulmak mümkündür. Bunu yapmak için "Sentez" butonu ile gelecek olan Şekil 4.45'deki "Chebyshev Filtre Sentez Türleri" formunda sentez türü seçilerek "Sentez Bölüm" formuna geçiş yapılır (Şekil 4.46).



Şekil 4.45 "Chebyshev Filtre Sentez Türleri" form görüntüsü



Şekil 4.46 "Chebyshev Sentez Bölüm" form görüntüsü

İlk önce arka planda filtre parametreleri kullanılarak "Kutuplar ve Sıfırlar" butonu ile kutup ve sıfırlar bulunur.

🚽 Chebyshev Sentez Bölü	m	
Ku	tup ve Sıfırlar	
$\frac{\text{Iletim Sifirlam}}{21 = 0.951057}$ $z2 = 0.587785$ $z3 = 0$ $z4 = -0.587785$ $z5 = -0.951057$	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
	Emostans Emissionau	
	Empouans Ponksyonu	
Geri	Don	

Şekil 4.47 Chebyshev filtre için kutup ve sıfırların bulunması

Daha sonraki aşamada kutup ve sıfırlar yardımıyla devrenin empedans fonksiyonu Şekil 4.48'deki şekliyle bulunur.

🖵 Chebyshev Sentez Bölü	m	
K	utup ve Sılırlar	
$\frac{\text{lletim Stfirlar}}{\text{z1} = 0.951057}$ $z2 = 0.587785$ $z3 = 0$ $z4 = -0.587785$ $z5 = -0.951057$	$\frac{\text{Kutuplar}}{\text{pl} = -0.111963+1.011557j}$ p2 = -0.293123+0.625177j p3 = -0.36232+0j p4 = -0.293123-0.625177j p5 = -0.111963-1.011557j	
$Z(s) = \frac{2s^5 + 1.17249}{1.172491s^4}$	Empedants Fonksivonu 1s ⁴ + 3.187367s ³ + 1.309575s ² + 1.065018s + 0.178923 + 0.687367s ³ + 1.309575s ² + 0.440018s + 0.178923	Prototip Değerler
Gen	Don	

Şekil 4.48 Chebyshev filtre için empedans fonksiyonunun bulunması

Sonrasında ise prototip eleman değerleri bulunur (Şekil.4.49).



Şekil 4.49 Chebyshev filtre için prototip eleman değerlerinin sentez yoluyla bulunması

Burada dikkat edilecek olunursa Şekil 4.44 ve Şekil 4.49'da sırasıyla analiz ve sentez yöntemi ile bulunan prototip eleman değerleri neredeyse birbirlerine eşittir. Aralarında çok küçük farklar bulunmaktadır. Bundan sonra "Gerçek Elemanlara Geçiş" butonu ile gelecek olan Şekil 4.50'deki "Chebyshev Filtre Türleri" formundan daha önce anlatıldığı şekilde (Bkz Uygulama 4.1) işlemlere devam edilir.



Şekil 4.50 "Chebyshev Filtre Türleri" form görüntüsü

4.4 Quasi-Statik Analiz

Bölüm 2'de *Mikroşerit Hat*, *Şerit Hat*, *Eş Düzlemsel Dalga Kılavuzu (CPW ve CBCPW)*, *Eş Düzlemsel Şeritler (CPS)* ve *Yarık (Slot) Hat* düzlemsel iletim hatlarının karmaşık yapıdaki formülasyonları ana başlıklar halinde ayrıntılı olarak incelenmişti. Programın bu bölümünde düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin hesaplanması gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, arayüz formunda bir taraftan gireceği giriş parametrelerine karşılık diğer taraftaki çıkış parametrelerine kolaylıkla ulaşabilir.

"Quasi-Statik Analiz" bölümüne başlangıç ekranından (Bkz. Şekil 4.2) veya diğer bölümler içerisindeki menülerden ulaşılabilir. Kullanıcı ilk başlangıçta Şekil 4.51'deki "Planar Analiz" form görüntüsüyle karşılaşır.

🕼 Planar Analiz						- • ×
Şerit Hat Mikro	oşerit Hat CPW CB	CPW CPS SI	ot Hat Help			
Dielektrik Paramu Dielektrik Dielektrik Sabiti Tanjant Kaybi	etreleri FT / Duroid 5590 2.2 0.0009	Sr.	→ w k ★ <u>Serit Hat</u>	t t	İletken Parametreleri İletken Gümüş İletkenlik 61800000	S/m v
Empedans Frekans Eeff	50 10 0	Ohm 💌 GHz 💌	Analiz 🔸	Şerit Genişi Yüksel Şerit Kalı	iği (W) 0.144946 (ik (h) 0.254 niği (t) 0.01	mm v mm v
İletken Zayıfla Dielektrik Zayıfla	ma Sabiti 0 ma Sabiti 0	dB/m	*			X Çıkış

Şekil 4.51 "Planar Analiz" form görüntüsü

"Planar Analiz" formu ilk başta "Şerit Hat" a göre default değerlerle gelmektedir. Kullanıcı "Analiz Butonu" veya "Sentez Butonu" ile birlikte girişi yapılan parametre değerlerine göre çift yönlü hesaplatma yapabilir. Yani bir taraftan girilen parametre değerlerine göre diğer taraftaki parametre değerleri hesaplanır. Şerit hat için analiz ve sentez işlemleri Şekil 4.52 ve Şekil 4.53'de görülmektedir.

🗊 Planar Analiz					
Şerit Hat Mikro	oşerit Hat CPW CB	CPW CPS S	lot Hat Help		
Dielektrik Paramu Dielektrik Dielektrik Sabiti Tanjant Kaybi	etreleri RT / Duroid 5580 💌 2.2 0.0009	E _F	→ <u> w ←</u> 	↓ t iletken Parar iletken [iletkeniik]	netreleri Gümüş 💌 61800000 S/m 💌
			<u>Serit Hat</u>		
Empedans Frekans	50 10 2.2	Ohm 👻 GHz 💌	Analiz	Şerit Genişliği (W) 0.193 Yükseklik (h) 0.254	1975470647366 mm 💌
Lei	,			Şenci (diirnigi (i)	
İletken Zayıfla Dielektrik Zayıfla	ma Sabiti 0 ma Sabiti 0	dB/n			X Çıkış

Şekil 4.52 "Şerit Hat" analiz görüntüsü

Planar Analiz Sarit Hat Mikrocravit Hat CDW CDCDW CDS Slat Hat Holp	
Dielektrik Parametreleri Dielektrik RT/Duroid 5580 ✓ Dielektrik Sabiti 1 2.2 Tanjant Kaybi 0.0009	Iletken Parametreleri Iletken Güimüş Iletkeniik 61800000 S/m
Empedans 48.7779237393589 Ohm Frekans 10 GHz Eeff 2.2 iletken Zayilama Sabiti 6.03549056668828E dB/m	Şerit Genişliği (₩) 0.193975470647366 mm v Yükseklik (h) 0.254 mm v Şerit Kalınlığı (t) 0.01 mm v
Dielektrik Zayıflama Sabiti 1.21477331218627 dB/m 💌	X Çıkış

Şekil 4.53 "Şerit Hat" sentez görüntüsü

Değişik dielektrik ve iletken seçimine göre değişik türdeki düzlemsel yapıların analizi gerçekleştirilebilmektedir. Örnek olarak dielektrik malzeme olarak germanyum ve iletken olarak alüminyum seçilerek (Şekil 4.54 ve Şekil 4.55) işleme geçilebilir.

🗊 Planar Analiz			
Şerit Hat Mikro	şerit Hat CPW CBCPW CP	S Slot Hat Help	
<u>Dielektrik Paramı</u> Dielektrik Dielektrik Sabiti Tanjant Kaybı	etreleri Germanyum Alüminyum GaAs Germanyum Silkon RT/Duroid 5580	, → <mark>w k</mark> , <u>*</u> , , <u>Serit Hat</u>	↓ Iletken Parametreleri ↓ Iletken Gümüş ▼ Iletkenlik 61800000 S/m ▼
Empedans Frekans	50 Dhm 💌 10 GHz 💌	Analiz 🔸	Şerit Genişliği (W) 0.144946 mm 💌 Yükseklik (h) 0.254 mm 💌
Eeff	0	+ Sentez	Şerit Kalınlığı (t) 0.01 mm 💌
İletken Zayıfla Dielektrik Zayıfla	na Sabiti 0 ma Sabiti 0	dB/m ▼ dB/m ▼	X Çıkış

Şekil 4.54 Dielektrik seçimi

<u>Dielektrik Param</u>	Sermanuum 🚽	-			en Parametreleri	-
Dielektrik Dielektrik Sabiti	16	Er.	→ w <u>k</u> t	h I İletke	Gümüş Bakır	 S/m
Tanjant Kaybi	0.0005				Altın Aluminyum Nikel	_
			<u>Şerit Hat</u>		THING	
2.4.1.1.1	50	Ohm v	1		0 144946	mm v
Empedans			Analiz 🔸	Şerit Genişliği (W)	0.254	
Frekans			1	Yükseklik (h)	10.234	
Eeff	10		 Sentez 	Şerit Kalınlığı (t)	J0.01	mm 🗾
İletken Zayıflar	na Sabiti 0	dB/m	•			
		dB/m	-			🗶 Çıkış

Şekil 4.55 İletken seçimi

Şekil 4.56'da ve Şekil 4.57'de görüleceği üzere girilen giriş parametrelerine göre "Analiz Butonu" ile birlikte sağ taraftaki bilinmeyen parametreler hesaplanır. Diğer yandan "Sentez Butonu" ile de sol taraftaki parametre değerleri hesaplanır .

🗊 Planar Analiz				_ _ X
Şerit Hat Mikroşe	erit Hat CPW CBC	CPW CPS Slo	t Hat Help	
<u>Dielektrik Parametr</u> Dielektrik	releri Germanyum 💌		w. k	iletken Parametreleri ↓ t lietken Alüminyum →
Dielektrik Sabiti	16	Er	[−] −−− [−] [−] [−] / _↑ t	h iletkeniik 36900000 S/m 💌
Tanjant Kaybi	0.0005		-	— ——
			<u>Şent Hat</u>	
Empedans	50	Ohm 👻	Analiz 🔸	Şerit Genişliği (W) 0.006984924054479 mm 💌
Frekans	10	GHz 💌		Yükseklik (h) 0.254 mm 💌
Eeff	16		+ Sentez	Şerit Kalınlığı (t) 0.01 mm 💌
İletken Zayıflama	a Sabiti 0	dB/m	•	
Dielektrik Zayıflama	a Sabiti 0	dB/m	•	X Çıkış

Şekil 4.56 "Şerit Hat" analiz sonuçları görüntüsü

erit Hat Mikro	şerit Hat CPW (BCPW CPS	Slot Hat Help		
Dielektrik Parame	treleri			Letken Parametreleri	
Dielektrik	Germanyum	-	→ w k_	iletken Alüminyum 🖵	
Dielektrik Sabiti	16	Er		lletkenlik [36900000 [S/n	n 🔻
Tanjant Kaybi	0.0005			*	
			<u>Serit Hat</u>		
Empedans	51.8856327779182	Ohm 👻	Analiz 🔸	Şerit Genişliği (W) 0.006984924054479 mm	•
Frekans	10	GHz 💌		Yükseklik (h) 0.254 mm	•
Eeff	16		+ Sentez	Şerit Kalınlığı (t) 0.01 mm	•
İletken Zayıfları	na Sabiti 1.312330	96619077E dB/	m 💌		
Dielektrik Zayıflar	na Sabiti 1.82	dB/r	m 💌	X Çıl	uş

Şekil 4.57 "Şerit Hat" sentez sonuçları görüntüsü

Aynı şekilde diğer düzlemsel yapılar seçilerek benzer hesaplamalar yapılabilir. "Mikroşerit Hat" için Şekil 4.58;

Planar Analiz Sorit Hat ODW OPO		
Sent Hat Mikroşent Hat CPW CBC Dielektrik Parametreleri Dielektrik RT/Duroid 5590 ▼ Dielektrik Sabiti 2.2 Taninet Kauta 0.0009	PW CPS Slot Hat Help $\begin{array}{c c} \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline $	<mark>İletken Parametreleri</mark> İletken Gümüş ▼ İletkenlik 61800000 S/m ▼
	<u>Mikroşerit Hat</u>	
Empedans 50 Frekans 10	Ohm ▼ Analiz ◆ Şerit Ge GHz ▼ Yü	enişliği (W) 0.144946 mm 💌 kseklik (h) 0.254 mm 💌
Eeff 0	Sentez Şerit	Kalinliği (t) 0.01 mm 💌
İletken Zayıflama Sabiti 0 Dielektrik Zayıflama Sabiti 0	dB/m ▼ dB/m ▼	X Çıkış

Şekil 4.58 "Mikroşerit Hat" form görüntüsü

"Klasik Eş Düzlemsel Dalga Kılavuzu (CPW)" için Şekil 4.59;

🗊 Planar Analiz					— — X
Şerit Hat Mikro	şerit Hat CPW C	BCPW CPS SI	ot Hat Help		
Dielektrik Parame	treleri		<mark>> ₩ <</mark>	İletken Parametreleri	
Dielektrik	RT/Duroid 5580			iletken Gümüş	•
Dielektrik Sabiti	2.2	εr		h İletkenlik 61800000	S/m 💌
Tanjant Kaybi	0.0009			<u>*</u>	
		<u>Klasik E</u> :	<u>ş Düzlemsel Dalga Kılavuzu</u>	(CPW)	
Empedans	50	Ohm 👻	Analiz 🔸	Şerit Genişliği (W) 0.144946	mm 💌
Frekans	10	GHz 💌		Aralık (G) 0.1	mm 💌
Eeff	0		+ Sentez	Yükseklik (h) 0.254	mm 💌
				Şerit Kalınlığı (t) 0.01	mm 💌
İletken Zayıfları	na Sabiti 0	dB/m	•		
Dielektrik Zayıflar	na Sabiti 0	dB/m	•		X Çıkış

Şekil 4.59 "Klasik Eş Düzlemsel Dalga Kılavuzu" form görüntüsü

🗊 Planar Analiz						X
Şerit Hat Mikro	oşerit Hat CPW	CBCPW CPS S	lot Hat Help			
<u>Dielektrik Param</u> Dielektrik	etreleri RT/Duroid 5580		<mark>→ </mark>		en Parametreleri ken Gümüş	•
Dielektrik Sabiti	2.2	Er .	→ G ←	h İletki	enlik 61800000	S/m 💌
Tanjant Kaybi	0.0009					
		<u>lletken E</u>) estekli Eş Düzlemsel Dalga	<u>a Kilavuzu</u>		
Empedans	50	Ohm 👻	Analiz 🔸	Şerit Genişliği (W)	0.144946	mm 💌
Frekans	10	GHz 💌		Aralık (G)	0.1	mm 💌
Eeff	0		🔶 Sentez	Yükseklik (h)	0.254	mm 💌
				Şerit Kalınlığı (t)	0.01	mm 💌
iletken Zayıflama Sabiti 0 dB/m 💌						
Dielektrik Zayıfla	ma Sabiti 🛛 🛛 🛛 🖉	dB/n				X Çikiş

"İletken Destekli Eş Düzlemsel Dalga Kılavuzu" için Şekil 4.60;

Şekil 4.60 "İletken Destekli Eş Düzlemsel Dalga Kılavuzu" form görüntüsü

"Eş Düzlemsel Şerit (CPS)" için Şekil 4.61;

🗊 Planar Analiz						
Şerit Hat Mikro	şerit Hat CPW	CBCPW CPS	Slot Hat Help			
<u>Dielektrik Parame</u> Dielektrik Dielektrik Sabiti Tanjant Kaybi	<u>xtreleri</u> RT / Duroid 5580 2.2 0.0009		<mark>w ← →</mark> w ← → 6 ←	- ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	iken Parametreleri letken Gümüş ikenlik 61800000	▼ S/m ▼
			Es Düzlemsel Şerit (CPS)			
Empedans	50	Ohm 👻		Şerit Genişliği (M	/) 0.144946	mm 💌
Frekans	10	GHz 💌	🔶 Sentez	Aralık (0	i) 0.1	mm 💌
Eeff	0			Yükseklik (l	n) 0.254	mm 💌
				Şerit Kalınlığı (t) 0.01	mm 💌
iletken Zayıflama Sabiti 0 dB/m 💌						
Dielektrik Zayıflar	ma Sabiti 0	dB/r	m 💌			X Çıkış

Şekil 4.61 "Eş Düzlemsel Şerit" form görüntüsü

"Slot Hat" için Şekil 4.62;

🗊 Planar Analiz Şerit Hat Mikro	şerit Hat CPW CB	CPW CPS Slot H	lat Help		
<u>Dielektrik Parame</u> Dielektrik Dielektrik Sabiti Tanjant Kaybi	etreleri RT / Duroid 5590 2.2 0.0009	ε,	<mark>≯ 6 K—</mark>	↓ 1 ↓ ↓ ↓ ↓	▼ S/m ▼
			<u>Slot Hat</u>		
Empedans Frekans Eeff	50 10 0	Ohm 🔹 GHz 💌	← Sentez	Aralık (G) 0.1 Yükseklik (h) 0.254	mm v
İletken Zayıflar Dielektrik Zayıflar	na Sabiti 0 na Sabiti 0	dB/m	v		X Çıkış

Şekil 4.62 "Slot Hat" form görüntüsü

arayüzlerinden benzer hesaplamalar yapılabilir.

4.5 Grafik Analiz

Bu bölüm "Filtre Analizi" bölümünde yeterli uygulamalarla ayrıntılı olarak ele alınmıştır (Bkz Uygulama 4.1).

4.6 Yardım

Bu bölümde kullanıcıya yol gösterme amaçlı bazı bilgiler (kullanım kılavuzu vb.) yer almaktadır.

5. KULLANILAN YAZILIMLAR

5.1 Giriş

Günümüz teknolojisi artık görselliği vazgeçilmez unsurlardan birisi olarak kabul etmektedir. Bu nedenle hemen herşeyde olduğu gibi programcılıkta da artık görsellik ön plana çıkarılmıştır. Klasik programlama dillerinden farklı olarak Visual Basic, Delphi, Visual C# vb. görsel programlama dilleri; programlamayı karmaşıklıktan çıkararak daha kolay ve zevkli hale getirmiştir. Görsel programlama dilleri 4GL diller olarak nitelendirilmektedir. Yani kod üzeri geliştirilmiş ve programcının işini kolaylaştırmak için procedure kısımlarını otomatik olarak yazan dillerdir.

Bu tez çalışmasında hazırlanan paket programda görsellik ön planda tutulmuştur. Paket programın yazılım aşamasında genel programlama dili olarak Visual C#.Net'den yararlanılmıştır. Ayrıca programın bir parçası olan "Quasi-Statik Analiz" bölümü için Borland Delphi'den yararlanılmıştır. Paket program için yapılan çalışmalarda işlem adımları diğer paket programlar (Mathcad vb.) yardımıyla test edilerek doğruluk kontrolü yapılmıştır.

5.2 Visual C#.Net

C#; C ve C++ temelleri esas alınarak tasarlanmış Visual Studio.Net'in yeni ve güçlü bir dilidir. Windows işletim sistemi üzerinde .Net platformu oluşturulduktan sonra en çok kullanılan ve tercih edilen dil olabilmeyi başarmıştır. C++ diline ait komplex özellikleri kullanmadaki başarısı ve Visual basic diline ait kullanım kolaylığını üzerine alması çok başarılı bir bilgisayar dil tekniği kullanabilmesine yardımcı olmuştur. Bu yazılım hakkında ayrıntılı bilgi **Ekler Bölümü**'nde **Ek-1**'de sunulmuştur.

5.3 Borland Delphi

Borland Delphi tam bir nesnel ve kolaylıkları çok fazla olan bir görsel programlama dilidir. Bu programlama dili klasik programlama dillerinden çok farklıdır. Bu yazılım hakkında ayrıntılı bilgi **Ekler Bölümü**'nde **Ek-2**'de sunulmuştur.

6. SONUÇ ve TARTIŞMA

6.1 Sonuç

Bu çalışmada düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin hesaplanması ve mikrodalga filtre tasarımına yönelik olarak filtre tasarımcılarına katkı sağlayabilecek yeni bir paket program hazırlanmıştır. İlk önce konu ile ilgili ayrıntılı literatür taraması yapılarak filtre tasarımı için en uygun metodun "Araya Girme Kaybı Metodu (Insertion Loss Method)" olduğu sonucuna varılmıştır ve bu metod kullanılarak mikrodalga filtre tasarımı gerçekleştirilmiştir. Düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin hesaplanmasında ise bir Quasi statik analiz metodu olan "Konform Dönüşüm Metodu (Conformal Mapping Method)" esasları kullanılarak düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin hesaplanması gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında yeni paket program hazırlama hedefine yönelik olarak düzlemsel iletim hatlarının analiz ve mikrodalga filtre tasarım aşamaları ayrıntılı bir biçimde incelenerek formülasyonları toparlanmıştır. Toparlanan bu formülasyonlar yazılım haline dönüştürülmüştür. Bu çerçevede hazırlanan programda öncelikli olarak Araya girme kaybı metodu ile, Butterworth, Chebyshev ve Eliptik karakteristikli frekans cevapları için prototip alçak geçiren filtre eleman değerleri hesaplanmakta ve daha sonra frekans ve eleman dönüşüm formülleri kullanılarak prototip eleman değerlerinden gerçek filtrelerin eleman değerlerine geçiş yapılmaktadır. Sonuç olarak; hazırlanan yeni paket program kendine özgü grafik paketi ve kayıt formatları gibi birçok fonksiyonel özelliğe sahip olarak kullanıcılarına değişik platformlarda çalışma imkanı sunmaktadır.

En son aşamada hazırlanan program; setup dosyasının oluşturulması sonucunda gerçek bir paket program haline getirilerek CD halinde kullanıma sunulmuştur.

Hazırlanan yeni paket program ileriki dönemlerde konu ile ilgili yeni çalışmalarla birlikte genişletilebilecek durumdadır.

KAYNAKLAR

- ALGAN Sefer "HerYönüyle C#" Pusula Yayıncılık
- BOWICK, C. Circuit Design, NewNess, Boston, 1982.
- COHN S. B., "Problems in Strip Transmission Lines", *IRE Trans. Microwave Theory Tech.*, Vol. MTT-2, pp. 52-55, July 1954.
- COHN S. B., "Slot Line on a Dielectric Substrate", *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, Vol. MTT-17, pp. 768-778, Oct. 1969.
- DEMIRLI Nihat and INAN Yuksel "Visual C#.NET 2005", 25, 31 Palme Yayıncılık
- ENGLEMANN H. F. and GRIEG D. D., "Microstrip-A New Transmission Technique for the Kilomegacycle Range", *Proc. IRE*, Vol. 40. pp. 1644-1650, Dec. 1952.
- ESFANDIARI R., MAKI D. W., and SIRACUSA M., "Design of Interdigilated Capacitors and Their Application to Gallium Arsenide Monolithic Filters", IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-31, Jan. 1983, pp. 57-64
- GHIONE G. and NALDI C., "Analytical Formulas for Coplanar Lines in Hybrid and Monolithic MICs", *Electron. Lett.*, Vol. 20, No. 4, pp. 179-181, Feb. 1984.
- GHIONE G. and NALDI C., "Paremeters of Coplanar Wave guides with Lower Ground Plane", *Electron. Letters*, Vol. 19, No. 18, pp. 734-735, Sept. 1983.
- GORUR Adnan, KARPUZ Ceyhun, GUNTURKUN Elif, URHAN Mehmet "Design of Microstrip Bandstop Filter with Adjustable Wide Passband Using Folded Open-Circuited Stub Resonators", 2009.

- GOYAL R., Monolithic Microwave Integrated Circuits: Technology and Design, Artech House, Norwood, MA, 1989, 17.
- GUPTA K. C and GARG R.., "Expressions for Wavelength and Impedance of Slotline" Slotline," *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, Vol. MTT-24, p. 532, Aug. 1976.
- GUPTA K. C., GARG R., and BAHL I. J., *Microstrip Lines and Slotlines*, Artech House, Dedham, MA, 1979, pp. 277-280.
- GUPTA K. C., Garg R., and CHADHA R., *Computer-Aided Design of Microwave Circuits* Artech House, Dedham, MA, 1981, p. 72.
- HAMMERSTAD E. O., and JENSEN O., "Accurate Models for Microstrip Computer-Aided Design", 1980 IEEE MTT-S Digest, pp. 407-409.
- HAMMERSTAD E. O., "Equation for Microstrip Circuit Design", Proc. Eur. Microwave Conf., pp. 268-272, 1975.
- HILBERG W., "From Approximation to Exact Relations for Characteristic Impedances", *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, Vol. MTT-13, pp. 29-38, Jan. 1965.
- HIROTA T, TARUSAWA Y, OGAWA H., "Unplanar MMIC Hybrids-A Proposed New MMIC Structure", *IEEE Trans.on Microwave Theory and Tech.* vol. MTT-35 NO. 6 J- 1987
- HOBDELL J., "Optimization of Interdigital Capacitors", IEEE Trans. On MTT, 788-791

HOWE, Artech House Chapter 1 "Stripline Circuit Design", 1974

JANASWAMY R. and SCHAUBERT D. H., "Characteristic Impedance of a Wide Slotline on low_Permittivity Substrates", *IEEE trans. Microwave Theory Tech.*, vol. MTT-34, pp. 900-902, Aug. 1986. J. Champion, Engineer 6 June 2007

- KARAGULLE Ihsan and PALA Zeydin, "Borland Delphi 4" Türkmen Kitabevi
- LANCASTER M. J., JIA-Sheng Hong "Microstrip Filters for RF/Microwave Applications" Copyright @ 2000 John Wiley & Sons. Inc.
- LIU L. C. T., Lin C. S., KESSLER J. R., and WANG S. K., "A 30 Ghz Monolithic Receiver", IEEE 1986 Microwave- and Millimeter-Wave Monolithic Circuit Symposium Digest, New York IEEE, 1986, pp. 41-44.

MEDLEY Max W. "Microwave and RF Circuits : Analysis, Synthesis and Design

- MURAGUCHI ve HAYASHI H. "An MMIC Active Phase Shifter Using a Variable Resonant Circuit", in IEEE MTT- S Int. Microwave Symp. Dig., June 1998
- NGUYEN Cam "Analysis Methods for RF, Microwave, and Millimeter-Wave Planar Transmission Line Structures" Copyright @ 2000 John Wiley & Sons. Inc.
- OHIRA et al, "MMIC 14-GHz VCO and Miller Frequency Divider for Low-Noise Local Oscillators", *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. MTT-35, No. 7, Jul. 1987, pp. 657-662

OZAKI, H. and ISHII J., Synthesis of a Class of Stripline Filters, IRE Trans. Circuit Theory, vol. CT-5, pp. 104-109, June 1958.

POZAR, M., D., Microwave Engineering, Addison-Wesley, Menlo Park, 1990.

PUCEL R. A., MASSE D. J., and HARTWIG C. P., "Losses in Microstrip", *IEEE Trans. Microwave Theory tech*, Vol. MTT-16, pp. 342-350, June 1968.

- PUCEL R. A., MASSE D. J., and HARTWIG C. P., "Correction to Losses in Microstrip", *IEEE Trans. Microwave Theory tech.*, Vol. MTT-16, p. 1064, Dec. 1968.
- RICHARDS, P. I., Resistor Transmission-Line Circuits, Proc. IRE vol. 36 pp. 217-220 February 1948
- WELCH J. D. and PRATT H. J., "Losses in Microstrip Transmission Systems for Integrated Microwave Circuits", NEREM Rec., Vol. 8, pp. 100-101, 1966.
- WEN C. P., "Coplanar Waveguide: A Surface Strip Transmission Line Suitable for Nonreciprocal Gyromagnetic Device Application", *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, Vol. MTT-17, pp. 1087-1090, Dec. 1969.
- WHEELER H. A., "Transmission Line Proportiess of a Stripline Between Paralel Planes", *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, Vol. MTT-26, pp. 8666-876, Nov. 1978
- YAGIMLI Mustafa and AKAR Feyzi, "Delphi 6 Görsel Program Tasarımı" Beta Yayıncılık
- WEB_1 "Txline" http://web.awrcorp.com/Usa/Products/Optional-Products/TX-Line/
- WEB_2 "Filter Design" http://www.aade.com/filter32/
- WEB_3 "Filter Free" http://www.nuhertz.com/filter/

EKLER

Bu kısımda **Bölüm 5**'te kısaca bahsedilen, yapılan paket program yazılımının temelini oluşturan "Visual C#.Net" yazılımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Ek-1.1 Visual C#.Net

C#; C ve C++ temelleri esas alınarak tasarlanmış Visual Studio.Net'in yeni ve güçlü bir dilidir. Windows işletim sistemi üzerinde .Net platformu oluşturulduktan sonra en çok kullanılan ve tercih edilen dil olabilmeyi başarmıştır. C++ diline ait komplex özellikleri kullanmadaki başarısı ve Visual basic diline ait kullanım kolaylığını üzerine alması bu dilin çok başarılı bir bilgisayar dil tekniği kullanmasını sağlamıştır.

C# nesnel bir dildir. Bu sayede sınıf mantığını çok iyi kullanarak profösyenel proje geliştirme olanağı sağlar. Tüm projeler için ortak olan kodlar *.dll uzantılı dosyalarda tutularak diğer projeler içerisinde kullanılmaları sağlanır. Bu nedenle mümkün olduğunca az kod kullanılmasını sağlayarak aynı kodları tekrar yazmak zorunda bırakmaz. Bu şekilde hem kod tutarlılığını ve doğruluğunu sağlarken hem de zamandan tasarruf edilir.

Microsoft Visual Studio 2008 ilk açılışta kullanıcının karşısına Şekil Ek-1.1'deki "Start Page" ekran görüntüsüyle gelir. Daha önceden kaydedilen projelerin isimleri "Recent Projects" listesinde görülmektedir. Bu listeden eski projeler kısa yoldan çift tıklanarak açılabilir.



Şekil Ek-1.1 "Start Page" ekran görüntüsü



Şekil Ek-1.2 "File->New->Project" menü seçenekleri görüntüsü

Kullanıcı yeni bir proje açmak için Şekil Ek-1.2'deki gibi "File->New->Project" menü seçeneklerini takip ederek Şekil Ek-1.3'deki ekrana ulaşır.

Project types:		Templates:	.NET Framework 3.5 🔻 📖 🛛
oject types: ▲ Visual C# Web Smart Device ▷ Office Database Reporting Test WCF Workflow ▷ Other Languages ▷ Other Project Types ▷ Test Projects		Visual Studio installed templates Windows Forms Application WPF Application Console Application Windows Service WPF User Control Library My Templates Search Online Templates	Class Library County Project County
 Other Langua Other Project Test Projects 	ges Types		
 Other Langua Other Project Test Projects A project for creation of the project for creati	ges Types ting an application wit WindowsFormsAr	th a Windows Forms user interface (.NET Francisco)	mework 3.5)
 Other Langua Other Project Test Projects A project for creation:	ges Types ting an application wit WindowsFormsAp C:\Users\MUrhan	th a Windows Forms user interface (.NET Fra oplication1 \Documents\Visual Studio 2008\Projects	mework 3.5)

Şekil Ek-1.3 "New Project" ekran görüntüsü

"Visual C#.Net 2008" sürümü içerisinde bir çok değişik seçenek kullanarak uygulama geliştirebilirsiniz (Şekil Ek-1.3). Console uygulaması, Web uygulaması vb. her çeşit projeyi desteklenmektedir. "New Project" formu sayesinde oluşturulacak projenin tipi, adı ve kaydedileceği yer belirlenebilir. Windows projesi açmak için ilk olarak "Project Type" listesinde yer alan "Visual C#" dili ile "Windows" seçilir ve "Templates" listesinden "Windows Forms Application" uygulaması seçilir. Daha sonra en alt kısımda yer alan "Name" kutusuna bir proje adı ve "Location" kutusuna projenin kaydedileceği yer girilir. Son olarak "OK" tuşuna basılarak windows projesi Şekil Ek-1.4'deki gibi açılmış olur.

Projede ilk olarak "Form1.cs[Design]" varsayılan adında kullanıcının tasarımını yaparak projesini geliştireceği bir form arayüzü oluşur (Şekil Ek-1.4).

WindowsFormsApplication1 - Microsoft Visua	al Studio							
File Edit View Project Build Debug	Data Format Tools Test	Window Help						
🛅 • 🛅 • 💕 🛃 🍠 🐰 🖻 🛝 🔊 •	(* - 💭 - 🖳 🕨 Debug	 Any CPU 	- 🎯		- 🔍	🔄 😒 🛠 🖻	•	
御臣を引する可聞知路。	德 [마 많 맞 맞] 을 찾 을	: e: [-] 후 [1] *						
Toolbox 🗸 🕂 🗙	Form1.cs [Design]					-) -)	 Solution Explorer - Solution 	ution 'WindowsF 👻 👎
All Windows Forms							T 🖪 🕲 🖬 🖻 🖻	8
Pointer	a cont		1				Solution 'Window	sFormsApplication1' (1)
BackgroundWorker	R. Formi						. WindowsForm	nsApplication1
P BindingNavigator							🔬 📴 Properties	
🚏 BindingSource 📃							🗑 🔤 Reference	5
ab Button							🗑 🗉 Form1.cs	
CheckBox							💷 🔮 Program.c	5
😭 CheckedListBox								
🗾 ColorDialog			6				Droportion	
ComboBox							roperties	▼ #
ContextMenuStrip							Form1 System.Windo	vs.Forms.Form
DataGridView							2 2 🗉 🗲 🖻	
P DataSet							Locked	False
DateTimePicker							MainMenuStrip	(none)
DirectoryEntry							MaximizeBox	True
A DirectorySearcher								0; 0
DomainUpDown							MinimizeBox	True
ErrorProvider							MinimumSize	0; 0
EventLog							Opacity	100%
7 FileSystemWatcher							Padding	0; 0; 0; 0
Provide a contraction of the con							RightToLeft	No
FolderBrowserDialog							RightToLeftLayout	False
E FontDialog							ShowIcon	True
[^{xt}] GroupBox							ShowInTaskbar	True
El HelpProvider T							E Size	300; 300
Error List						↓ ₽ 3	× SizeGripStyle	Auto
3 0 Errors 1 0 Warnings (i) 0 Messages							StartPosition	WindowsDefaultLocat
Description			El.	line .	Calum	Desired	Tag	
Description			File	Line	Column	Project	Text	Form1
							Text	
							The text associated wit	h the control.
Ready								
🧑 📼 🕿 🖉 👋 🚺 Viksek Lisan	Mehmet Urh	nierts	Aicrosof Winda	erFor N	Sekils 4 . Daint	TR TR		🗆 🥑 🕅 🖥 🏟 134

Şekil Ek-1.4 Windows uygulama projesi ekran görüntüsü

Ek-1.1.1 Toolbox Penceresi

Formun sol tarafında yer alarak kullanılmaya hazır controller bulundurmaktadır. Kullanıcı bu pencereden kontrolleri sürükle-bırak metodu ile formun üzerine bırakabilir (Şekil Ek-1.5). Bu sayede bir çok proje uygulamasında tasarım ekranları için kod yazmaya gerek kalmayacaktır. Yani "C#" dili kullanıcının yerine arka plan kodlarını otomatik olarak oluşturmaktadır.

Toolbox	- 7 ×	Form1.cr Form1.cs [Design]	
All Windows Forms	<u> </u>		
R Pointer		a cont	
BackgroundWorker	-	Form	
🚰 BindingNavigator			
📅 BindingSource		00	-
ab Button			
CheckBox			
CheckedListBox		listBox	<1
S ColorDialog		Checkberr	
E ComboBox		20.2	
ContextMenuStrip		radioButton 1	
DataGridView			
🗗 DataSet			
T DateTimePicker			

Şekil Ek-1.5 "Toolbox" penceresindeki kontrollerin sürükle-bırak metodu ile kullanılması

Şekil Ek-1.5'de form üzerinde yer alan kontrollerin üzerine çift tıklayarak veya "Solution Explorer" penceresinden seçim yaparak projenin kod kısmının yazıldığı "Form1.cs" varsayılan adında kod editor sayfasına geçiş yapılır (Şekil Ek-1.6).

Form1.cs* Form1.cs [Design]*	+ X
Image: WindowsFormsApplication1.Form1 ■ Image: WindowsFormsApplication1.Form1	-
1 using System;	
2 using System.Collections.Generic;	^
3 using System.ComponentModel;	
4 using System.Data;	
5 using System.Drawing;	
6 using System.Ling;	
7 using System.Text;	
8 Lusing System.Windows.Forms;	=
9	-
10 🖂 namespace WindowsFormsApplication1	
11 {	
12 public partial class Form1 : Form	
13 {	
14 public Form1()	
15 {	
16 InitializeComponent();	
17 - }	
18	
19 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)	
20 {	
21 //Kodlar buraya yazılır.	
22 - }	
23 - }	
24 4	
25	
	*
< III	•

Şekil Ek-1.6 Kod editör sayfa görüntüsü

Bu sayfa üzerinde forma yerleştirilmiş olan kontrollerden birisin adını yazdıktan sonra "." karakterine basılırsa o kontrole ait tüm kullanabileceğiniz komutlar (prosedür, fonksiyon, özellik vb.) çıkar (Şekil Ek-1.7).

Form1.cs* Form	m1.cs [Design]*	. ×
WindowsForm	sApplication1.Form1 🔹 🔊 button1_Click(object sender, EventArgs e)	•
<pre></pre>	<pre>sApplication1.Form1</pre>	
•	III	

Şekil Ek-1.7 Kontrollere ait komutların kullanılması

Ek-1.1.2 Proporties Penceresi

Formun sağ tarafında yer alan bu pencereden; formun üzerindeki herhangi seçili bir kontrolün özellikleri ayarlanabilir (Şekil Ek-1.8). Aynı zamanda buradan kontrollerin "Events" 'larına ulaşılabilir.

		Properties	→ ‡	×
		button1 System.Windo	ws.Forms.Button	-
00 0 button1 b		2 2 1 2		
	· · · ·	⊞ (DataBindings)		
		(Name)	button1	
listBo	ox1	AccessibleDescription		
checkBox1		AccessibleName		15
		AccessibleRole	Default	
radioButton1		AllowDrop	False	
		Anchor	Top, Left	
		AutoEllipsis	False	
		AutoSize	False	
		AutoSizeMode	GrowOnly	
		BackColor	Control	
		BackgroundImage	(none)	
		BackgroundImageLa	Tile	
		CausesValidation	True	
		ContextMenuStrip	(none)	
		Cursor	Default	
		DialogResult	None	-

Şekil Ek-1.8 "Proporties" penceresi kontrollerine ait özellik ayarları

Ek-1.1.3 Solution Explorer Penceresi

Proje için en önemli pencerelerden birisidir. Çünkü projede kullanılan tüm dosyalar (sınıflar, resim dosyaları, xml dosyaları vb.) ile kaynak kodların yer aldığı diğer dosyalar bu pencereden kontrol edilebilir.



Şekil Ek-1.9 "Solution Explorer" pencere görüntüsü

Ek-1.1.4 Error List Penceresi

Program çalıştırıldığında oluşan hataları gösteren çok yararlı bir penceredir. Oluşan hatalar ile ilgili program tarafından bilgi verilir.

E	Error List 👻 🕂 🗙						
3 1 Error 0 Warnings 0 Messages							
		Description	File	Line	Column	Project	
8	1	; expected	Form1.cs	22	33	WindowsFormsApplication1	

Şekil Ek-1.10 "Error List " pencere görüntüsü

Bu kısımda **Bölüm 5**'de kısaca bahsedilen, paket programın "Quasi-Statik Analizi" bölümünün yazılımını oluşturan "Borland Delphi" yazılımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Ek-2.1 Borland Delphi

Borland Delphi tam bir nesnel ve kolaylıkları çok fazla olan bir görsel programlama dilidir. Bu programlama dili klasik programlama dillerinden çok farklıdır. Görsel programlama dilleri 4GL diller olarak nitelendirilmektedir. Yani kod üzeri geliştirilmiş ve programcının işini kolaylaştırmak için procedure kısımlarını otomatik olarak yazan dillerdir.

Delphi'ye ilk girdiğinizde Şekil Ek-2.1'deki gibi bir ekranla karşılaşılır. Program 3 ana pencereden meydana gelmektedir. Bunlar : Form, Object Inspector (Nesne Denetleyicisi) ve Kontrol Paneli. "Form1" başlıklı pencere programın anasayfası olur. Yani çalışmalar bu form üzerinde gerçekleştirilir. "Object Inspector" penceresi form ve bileşen ayarlarını değiştirebileceğimiz bölümdür. Kendi arasında "Properties" ve "Events" olarak ikiye ayrılır. Bizim için gerekli olan ve fazlaca kullanacağımız bölüm "Properties" penceresidir.



Şekil Ek-2.1 "Borland Dephi"'nin açılış ekran görüntüsü

Görsel programlama dillerinin en önemli özelliklerinden birisi programın ekran tasarımının kodlama ile değil tasarım zamanı resim çiziyormuş gibi rahatça yapılabilmesidir. Yapılmak istenen programın aşama aşama safhaları rahatlıkla izlenebilir ve kontrol edilebilir.

Ek-2.1.1 Component Palette Araç Çubuğu

Bir form üzerinde oluşturulacak ekran görüntüsü, Şekil Ek-2.2'de görülen Delphi'nin ana formundaki "Component Palette" araç çubuğunda yer alan 170'i aşkın kontrollerle yapılır. Bu araç çubuğu adeta Delphi'nin kalbi durumundadır.

Component Database Tools Window Help	
Standard Additional Win32 System Data Access Data Controls dbExpress DataSna	₀ B ◀ ▶

Şekil Ek-2.2 "Component Palette" araç çubuğu görüntüsü

Kullanıcı form üzerine "Component Palette" den seçtiği kontrolleri mouse ile kolayca yerleştirebilir (Şekil Ek-2.3).

ਤ 🔗 Standar	d Additional Win32 :	Svstem Data Ar	ccess Data Controls ADO
₽ Form1			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>
	Edit1		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			· <u>S</u>

Şekil Ek-2.3 "Component Palette" araç çubuğu kontrollerinin kullanım görüntüsü

En çok kullanılan kontroller "Standard" sekmesinde yer alır. Şekil Ek-2.4'de "Standard" sekmesi kontrolleri görülmektedir.



Şekil Ek-2.4 "Component Palette" araç çubuğunun "Standard" sekmesi kontrolleri

"Standard" sekmesi ve diğer sekmeler altında yer alan kontroller hakkında aşağıda bilgiler verilmiştir.

TButton (Komut Düğmesi) : Bir olayın kullanıcı tarafından başlatılması için programlarda çok kullanılan kontrollerden biridir. "Standard" sekmesinde yer alır.

A TLabel (Etiket) : Label kontrolü genellikle form üzerinde açıklama yazmak veya başka bir kontrolün ne işe yaradığını belirtmek için kullanılır. "Standard" sekmesinde yer alır.

TEdit (Metin Kutusu) : Programlarda en çok ihtiyaç duyulan kontrol Edit kontrolü olup bilgi girişi amacıyla kullanılmaktadır. "Standard" sekmesinde yer alır.

TMemo (Çok satırlı Bilgi Giriş Kutusu) : Bu kontrol edit kontrolüne alternatif bir kontroldür. Edit kutusunun yapabildiği bütün işleri yapabilirken ayrıca edit kutusunun yapamadığı çok satır bilgi girişi, dosyadan text yükleme ve kaydetme gibi birçok işi de yapabilir. "Standard" sekmesinde yer alır.

TGroupBox (Gruplama Kutusu) : "Standard" sekmesinde yer alan ve sıklıkla kullanılan bir diğer kontrol de "GroupBox"'tır. Bu kontrol tek başına değil, diğer kontrolleri gruplamak için kullanılır. Kontrolleri bu kontrol ile gruplamanın birçok avantajı vardır:

- Bu çerçeveler içine konan kontroller çerçeveye bağımlıdırlar ve konumları bu çerçeve dışına taşamaz.
- Birden fazla kontrolün yerini yada özelliğini birden değiştirmeyi sağlar.
 Özellikle "RadioButton" ların kullanılmasında çerçeve kullanmak zorunlu hale gelebilir.

 TRadioButton (Seçenek Kutusu) : Kullanıcıya birkaç seçenekten birini seçme imkanı veren bir kontroldür. Bu kontrolün tek başına kullanılması anlamsızdır. "Standard" sekmesinde yer alır. **TListBox (Liste Kutusu) :** Windows'un sağladığı, dizileri vb. gösterebilen "Standard" sekmesi kontrollerindendir. Elemanları listelemek, sıralamak gibi özellikler sunan genel amaçlı bir kontroldür.

TComboBox (Aşağı Doğru Açılan Liste) : Aşağı doğru açılabilen bir liste kontrolüdür. Genellikle değerleri daha önceden belli olan elemanların seçimi için kullanılırlar. Liste Kutusuna benzer ancak listedeki elemanlardan sadece seçileni ekranda görüntüler. "Standard" sekmesinde yer alır.

TMainMenu (Menü Oluşturma Kontrolü) : Borland Delphi 6 formlarına menü eklemek, menülere belirli bir format vermek ve oluşturulan menülere program kodu yazmayı mümkün kılan bir kontrol elemanıdır. Uygulamalara menü eklemek için "TMainMenu" kontrol elemanı ilk etepta form üzerine alınır. "Object Inspector" penceresinde bu kontrolün "Items" özelliği tıklanarak menü tasarım formu açılır. Bu form üzerinde istenilen şekilde menü oluşturmak mümkündür. "Standard" sekmesinde yer alır.

TImage (Resim Gösterme Elemanı) : "Image" kontrolü, resimleri göstermek için kullanılır. Gösterilecek resim "Image" kontrolünün "Picture" özelliğine atanır. "Additional" sekmesinde yer alır.



TDateTimePicker (Tarih Seçme Kutusu) : Bu kontrol, tarih ve saatin bulunduğu hazır bir kutu sunar. "Win32" sekmesinde yer alır.

TRichEdit (Zengin Metin) : Bu kontrol, daha önce anlatılan "Memo" kontrolüne benzer özellikler taşır. Fakat "Memo" kontrolünden farklı olarak çok daha önemli özellikler taşır. Mesela "Memo" kontrolündeki yazının bir kısmının font büyüklüğü, font stili vb. değiştirilemezken "RichEdit" kontrolünde bu rahatlıkla yapılabilir. "RichEdit" kontrolü metni "RTF" (Rich Text Format) formatında kaydedebilir. Birçok popüler kelime işlemci bu formattaki dökümanları desteklediği için bir kelime işlem programı gibi rahatlıkla kullanılabilir. "Win32" sekmesinde yer alır.

Ek-2.1.2 Object Inspector (Olaylar ve Özellikler Penceresi)

"Object Inspector" penceresi, "Component Palette" den form üzerine yerleştirilen her kontrolün özellik ve olaylarını belirler. Obeject Inspector penceresi, form üzerinden bir kontrol seçildikten sonra F11 tuşu veya View / Obeject Inspector menü seçeneği ile görüntülenir.

Aşağıda Şekil Ek-2.5'de görülen pencerelerden ikisi de "Object Inspector" penceresidir. Birinci pencerede form üzerine alınan elemanın tasarım zamanı özellikleri (proporties) değiştirilirken, ikinci pencerede ise form üzerindeki elemana ait olan olaylar (events) görüntülenir.

Object Inspector 🛛 🔀		Object Insp	oecto	r		E	3	
Form1	TForm1	-	Form1		TFo	rm1	-	·
Properties Eve	nts		Properties	Even	nts			
Action		^	Action				-	¢,
ActiveControl			ActiveControl			٦		
Align	alNone	=	Menu					
AlphaBlend	false	=	ObjectMenuIter					
AlphaBlendValu	255		OnActivate					
⊞Anchors	[akLeft,akTop]		OnCanResize					
AutoScroll	true		OnClick			_	_	
AutoSize	false		OnClose					
BiDiMode	bdLeftToRight		OnCloseQuery					
⊞BorderIcons	[biSystemMenu,		OnConstrained					
BorderStyle	bsSizeable		OnContextPopu					
BorderWidth	0		OnCreate					
Caption	Form1		OnDblClic	k 🗌				
ClientHeight	446		OnDeacti	vate				
ClientWidth	688		OnDestro	y 📄				
Color	🗌 clBtnFace	~	OnDockD	rop			~	/
All shown		11	All shown					/

Şekil Ek-2.5 "Object Inspector" penceresi görüntüsü

Borland Delphi'nin diğer dillerden bir farkı da budur. Program çalışmadan önce bu özellikler hiçbir koda gerek duymadan değiştirilebilmektedir. Pencerenin ikinci hali ise o kontrole ait olayları belirlemek için kullanılır. Kontrole ait olayların listesi pencerede görülmektedir. Bu pencerenin karşısındaki kutu çift tıklanarak varsayılan (default) olayın yazılmasını veya kendiniz bir program ismi yazarak, o olay gerçekleştiğinde seçtiğiniz olayın çalışması sağlanabilir.
Form ve form üzerinde bulunan her kontrol elemanı çift tıklanarak o elemana ait default olay prosedürüne ulaşılabilir. Bu olaylar arka plandaki kod bölümünde yazılır. Formun hemen altında kod için ayrı bir *.pas uzantılı "Unit" sayfası yer almaktadır. İşte program için yazılan kodlar buraya yazılır. Her olay için ayrı prosedürleri Borland Delphi kendiliğinden oluşturur. Aşağıda Şekil Ek-2.6'da ana formun hemen arkasındaki "Unit" sayfası görülmektedir.



Şekil Ek-2.6 Kodun yazıldığı "Unit.pas" sayfa görüntüsü

Sıklıkla kullanılan bazı olaylar aşağıda açıklanmıştır.

OnClick : Komut düğmesinin en önemli olayı budur. Kontrolün farenin sol tuşunun yanında enter ve kısayol tuşu da meydana getirir. Genel olarak mouse ile tuşlama işlemini görevini klavyeden de yapan tuşlar bu olayı meydana getirir.

OnDblClick : Farenin sol tuşu ile çift tıklanması halinde bu olay meydana gelir.

OnMouseDown : Fare kontrol elemanı üzerinde iken farenin tuşlarından birine basılmasıyla meydana gelir. Click olayından farklı olarak farenin sadece sol tuşu değil sağ ve orta tuşları da bu olayı meydana getirir.

OnMouseUp : Fare kontrol elemanı üzerinde iken basılan fare tuşu bırakıldığında bu olay meydana gelir. Parametrelerin anlamı MouseDown olayındaki gibidir.

OnMouseMove : Programda, üzerinde bulunulan nesne ile ilgili bilginin, formun altında verilmesini sağlar.

OnChange : Bu olay, ilgili kontrolün içeriği değiştiği zaman (bilgi girişi, içerisindeki bilginin değişmesi silinmesi vb.) meydana gelecek bu olayın içindeki program kodu çalışır.

OnKeyPress : Bu olay, klavyeden basılan ve ASCII kodu bulunan bir tuşa basıldığında meydana gelir. Yani bu olay "Control", "Alt", "Shift", "CapsLock", "F1" vb. gibi tuşlarda meydana gelmez. Bu tuşları ancak "OnKeyDown" ve "OnKeyUp" olayları algılayabilir.Bu olay daha çok kullanıcının girdiği karakteri kontrol etmek için kullanılır. Hangi tuşa basıldığı "Key" parametresi ile öğrenilir.

OnKeyDown : Bu olay, klavyeden bir tuşa basıldığında meydana gelir ve basılı tutulduğu müddetçe meydana gelmeye devam eder.

OnKeyUp : Bu olay, basılan tuş bırakıldığı anda meydana gelir.

OnEnter : Bir kontrol elemanının aktif olmasıyla meydana gelir. Bir nesneye kontrolün geçebilmesi için görülebilir (Visible) ve aktif (Enebled) olması gerekir.

OnExit : Kontrol elemanının kontrolü kaybetmesiyle bu olay meydana gelir. Birden fazla form arasında geçiş yapılırken ve Windows uygulamaları arasında geçiş yaparken "OnExit" ve "OnEnter" olayı meydana gelmez. Bu olaylar gerçekleştiğinde programda ne olmasını istiyorsak işte bu "Unit" sayfasında her olayın kendi prosedürleri altındaki begin-end arasına kodları yazarız. Borland Delphi her olayın prosedürlerini kod yazmaya gerek kalmadan kendisi anında oluşturmaktadır. Örnek vermek gerekirse mesela "Button" nesnesine basıldığında programın ne yapmasını istiyorsanız "Button" a ait "OnClick" olayı çift tıklanarak Şekil Ek-2.7'de görüldüğü üzere buna ait

prosedürün oluşturulması sağlatılıp işletilmesi istenilen kod satırları begin-end arasına yazılır.



Şekil Ek-2.7 Kodun yazıldığı prosedür aralığı görüntüsü

ÖZGEÇMİŞ

03.02.1981 tarihinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Denizli'de tamamlayarak 2001 yılında Pamukkale Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. Bu bölümden 2006 yılında mezun olarak hemen ardından bu kez Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Aynı zamanda serbest iş hayatında inşaat proje sektöründe yerini alarak halen Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalın'da yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.